(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2003 年4 月24 日 (24.04.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/033566 A1

(51) 国際特許分類7:

69/48, 73/10, C08J 5/22, H01M 8/02

C08G 65/40,

(21) 国際出願番号:

PCT/JP02/10536

(22) 国際出願日:

2002年10月10日(10.10.2002)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2001-312799

2001年10月10日(10.10.2001)

2002年6月21日(21.06.2002) 特願2002-182252

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三井 化学株式会社 (MITSUI CHEMICALS,INC.) [JP/JP]: 〒100-6070 東京都千代田区 霞が関三丁目2番5号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

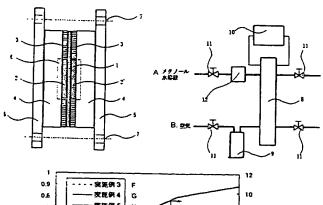
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 石川 淳一 (ISHIKAWA, Junichi) [JP/JP]: 〒299-0265 千葉県 袖ヶ 浦市長浦 580-32 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 黒木 貴志 (KUROKI, Takashi) [JP/JP]: 〒299-0265 千葉県 袖ヶ浦市 長浦580-32 三井化学株式会社 内 Chiba (JP). 藤山 聡子 (FUJIYAMA, Satoko) [JP/JP]; 〒299-0265 千葉県 袖ヶ浦市 長浦 5 8 0-3 2 三井 化学株式会社内 Chiba (JP). 尾身 毅彦 (OMI, Takehiko) [JP/JP]; 〒299-0265 千葉県 袖ヶ浦市 長浦 580-32 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 中田 智

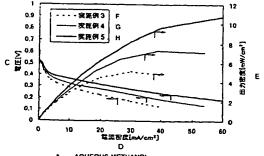
/続葉有1

(54) Title: CROSSLINKABLE AROMATIC RESINS HAVING PROTONIC ACID GROUPS, AND ION-CONDUCTIVE POLY-MER MEMBRANES, BINDERS, AND FUEL CELLS MADE BY USING THE SAME

JP

(54) 発明の名称: プロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂、ならびにそれを用いたイオン伝導性高分子膜、結着剤およ び燃料電池





A . . . AQUEOUS METHANOL

B...AIR C...VOLTAGE [V]

D...CURRENT DENSITY [ma/cm²]

E ... POWER DENSITY [mW/cm2]

. EXAMPLE 3

H . . . EXAMPLE 5

(57) Abstract: The invention relates to a crosslinkable aromatic resin which has crosslinking groups and protonic acid groups and is suitable for electrolyte membranes and binders for fuel cells; polymeric electrolyte membranes and binders for fuel cells, made by using the resin; and fuel cells made by using the membranes or the The aromatic resin has crosslinking groups which are not derived from protonic acid groups and are capable of causing crosslinking without the formation of a leaving component, and exhibits excellent ionic conductivity, heat resistance, water resistance, and adhesion, and low methanol permeability. It is Preferable that the aromatic resin bears as the crosslinking groups both C_{1-10} alkyl bonded directly to an aromatic ring and carbonyl or carbon-carbon double or triple bonds, while preferred examples of the crosslinkable aromatic resin include aromatic polyether, aromatic polyamide, aromatic polyimide, aromatic polyamide-imide, and aromatic polyazole, each of which has crosslinking groups described above.

[続葉有]

WO 03/033566 A1

三井化学株式会社内 Chiba (JP). 藤井 重治 (FU-JII,Shigeharu) [JP/JP]; 〒299-0265 千葉県 袖ヶ浦市 長浦 5 8 0-3 2 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 玉井正司 (TAMAI,Shoji) [JP/JP]; 〒299-0265 千葉県 袖ヶ浦市 長浦 5 8 0-3 2 三井化学株式会社内 Chiba (JP).

- (74) 代理人: 中嶋 重光 (NAKAJIMA,Shigemitsu); 〒101-0053 東京都 千代田区 神田美土代町 1 1-1 2 ニチョビル 3 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(国内): CA, CN, IN, JP, KR, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (DE, FR, GB, IT, SE).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

燃料電池などに用いられる電解質膜および結着剤として好適な、架橋基を有するプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂、およびそれから得られる燃料電池用高分子電解質膜および結着剤、ならびにそれを用いた燃料電池を提供するものである。該プロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂は、プロトン酸基から誘導されず、かつ脱離成分の生成なしに架橋し得る架橋基を有するでものであり、優れたイオン伝導性、耐熱性、耐水性、接着性、さらには低メタノール透過性を発現する。プロトン酸基から誘導されず、かつ脱離成分の生成なしに架橋し得る架橋基としては、芳香環に直接結合した炭素原子数1~10のアルキル基およびカルボニル基である架橋基、または炭素炭素二重結合もしくは炭素炭素三重結合である架橋基が好適な態様である。これらの架橋基を有する芳香族ポリエーテル、芳香族ポリアミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリアゾールなどの芳香族樹脂が、プロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂の好適な態様である。

明細書

プロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂、ならびにそれを用いたイオン伝導性高 分子膜、結着剤および燃料電池

5

技術分野

本発明は、水素、アルコールなどを燃料に用いる燃料電池などにおいて用いられるイオン伝導性のプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂、それを用いて得られる高分子膜、結着剤および燃料電池に関する。

10

15

20

25

背景技術

[高分子型燃料電池]

近年、環境問題の点から新エネルギー蓄電あるいは発電素子が社会で強く求められてきている。燃料電池もその1つとして注目されており、低公害、高効率という特徴から最も期待される発電素子である。燃料電池とは、水素やメタノールなどの燃料を酸素または空気を用いて電気化学的に酸化することにより、燃料の化学エネルギーを電気エネルギーに変換して取り出すものである。

このような燃料電池は、用いる電解質の種類によってりん酸型、溶融炭酸塩型、固体酸化物型および高分子電解質型に分類される。りん酸型燃料電池は、

すでに電力用に実用化されている。しかし、りん酸型燃料電池は高温(200℃ 前後)で作用させる必要があり、そのため起動時間が長い、システムの小型化が困難であること、また、りん酸のイオン伝導度が低いために大きな電流を取り出せないという欠点を有していた。

これに対して、高分子電解質型燃料電池は操作温度が最高で約80~10 0℃程度である。また、用いる電解質膜を薄くすることによって燃料電池内の 内部抵抗を低減できるため高電流で操作でき、そのため小型化が可能である。 このような利点から高分子電解質型燃料電池の研究が盛んになってきている。

10

20

25

高分子電解質型燃料電池には、燃料として、ボンベ、配管などから供給される純水素を用いるタイプのほか、改質器によりガソリンやメタノールから水素を発生させて用いるタイプなどがある。また、燃料としてメタノール水溶液を用いて直接発電を行う直接メタノール型燃料電池(DMFC: Direct Methanol Fuel Cell)も開発されている。このDMFCは、水素を発生させるための改質器が不要なためシンプルでコンパクトなシステムが構成でき、特に携帯機器用電源として注目されている。

高分子電解質型燃料電池は、イオン伝導性を有する高分子電解質膜とこの両側に接触して配置される正極および負極から構成される。燃料の水素あるいはメタノールは負極において電気化学的に酸化されてプロトンと電子を生成する。このプロトンは高分子電解質膜内を、酸素が供給される正極に移動する。一方、負極で生成した電子は電池に接続された負荷を通り、正極に流れ、正極においてプロトンと電子が反応して水を生成する。

この高分子電解質型燃料電池に用いる正極、負極といった電極は、電気伝導 15 性を有する導電材や、水素の酸化反応、酸素の還元反応を促進する触媒といった電極材料と、それを固定する結着剤により構成される。

[プロトン酸基含有フッ素系高分子電解質膜]

この高分子電解質型燃料電池に用いる高分子電解質膜には、燃料電池の電極 反応に関与するプロトンについて高いイオン伝導性が要求される。このような イオン伝導性高分子電解質膜材料としては、プロトン酸基含有フッ素系高分子 が用いられている。

しかしながら、このプロトン酸基含有フッ素系高分子電解質膜は、高温低湿度下でイオン伝導性が極端に低下することが知られている。プロトン酸基含有フッ素系高分子電解質膜は、主鎖の疎水部と側鎖の親水部がミクロドメイン構造を形成し、その親水部が高含水時に連結することによって、水のクラスター形成によるイオン伝導経路を形成している。そのため、高温低湿度下では水の蒸発に伴い伝導経路が遮断され、イオン伝導性が急激に低下するという問題が

10

15

あった。また、この水クラスターによる伝導経路はメタノールを透過する。そのため、プロトン酸基含有フッ素系高分子電解質膜をもちいたDMFCは、メタノールのクロスオーバーによる電圧低下や発電効率の悪さが問題とされていた。さらに、このプロトン酸基含有フッ素系高分子は他のフッ素樹脂と同様に、接着性が低く電極や膜との接着が困難である、非常に高価格である、廃棄時に焼却するとフッ酸ガスが発生するといった問題も有していた。

[プロトン酸基含有炭化水素系高分子電解質膜]

一方、プロトン酸基含有炭化水素系高分子を用いた非フッ素系の電解質膜開発も進められている。炭化水素系高分子電解質膜は水クラスター、イオン伝導経路の形成は観察されず、電解質膜全体が均一に水和している構造にある。従って、炭化水素系高分子電解質膜は、高分子と水分子の相互作用が高く、高温低湿度下でのイオン伝導性の低下が少ないことが知られている。

しかしながら、主鎖が脂肪族鎖で形成されるプロトン酸基含有炭化水素系高分子は、耐熱性および化学的な耐久性が低く、高分子電解質型燃料電池の高分子電解質として用いた場合、電池特性が経時的に悪化するといった問題を有していた。たとえば、スルホン化ポリスチレンはそのガラス転移温度が125℃程度であるため、発電時の発熱により膜が軟化し、変形してしまうという問題があった。また、主鎖構造が有する3級炭素がラジカルの攻撃を受けやすく、電池内で容易にα位の水素を放出してしまうといった問題があった。

20 そのため、主鎖に脂肪族鎖を有さない、すなわち芳香族炭化水素系のプロトン酸基含有高分子が数多く開発されてきた(Macromol. Chem. Phys., 199, 1421-1426 (1998)、Polymer, 40, 795-799 (1999)、Polymer, 42, 3293-3296 (2001)など)。なかでも、スルホン化したポリエーテルエーテルケトンから成る膜は、耐熱性と化学的耐久性に優れ、高分子電解質として長時間の使用に耐えうることが報告されている(本間格、第3回セパレーションズサイエンスをテクノロジー研究会講座講演要旨集「高分子膜燃料電池の基礎と応用」p17 (1999))。

10

15

これらプロトン酸基含有芳香族炭化水素高分子のイオン伝導性を高めるためには、プロトン酸基の導入量を増やす、すなわちイオン交換基当量を小さくすることが必要である。しかしながら、プロトン酸基の導入量を増やすと、同時に親水性が増し、吸水率が増加したり水溶性になることが知られている(特開平10-45913号公報など)。燃料電池は、燃料と酸素の反応により水を副生することから、水溶性の樹脂は燃料電池用の高分子電解質膜として用いることはできない。また、水溶性とならなくても、吸水性が高い場合には、膜の膨潤や強度の低下、吸水した水を介してのメタノールの負極から正極への透過などの問題を生じる。そのため、高いイオン伝導性を有する高分子電解質を得るためには、膜の水溶性、吸水性を低下させる必要があった。

国際公開第 00/066254 号明細書、特開昭 63-305904 号公報などには、水溶性、吸水性を有するスルホン化樹脂と、水溶性、吸水性を有さない塩基性ポリマーとを混合し、塩形成させることにより、その水溶性、吸水性を低下させる方法が示されている。しかしながら、この方法は、水溶性、吸水性を有さない塩基性ポリマーを多量に導入する必要があり、プロトン酸基含有樹脂の組成が低く、イオン伝導性が低いといった問題があった。また、塩形成は平衡反応であり、例えば、発電時に膜中を移動するプロトン酸により解離と再結合を繰り返すことから、スルホン化樹脂が徐々に溶出するといった問題を有していた。

[プロトン酸基含有架橋樹脂膜]

20 一方、水溶性を有さない成分を導入することなしに、水溶性を低下し、さら に、樹脂の溶出も抑制できる方法として、共有結合による架橋構造が注目され てきた。

例えば、特開昭 52-91788 号公報には、フリーデルクラフト反応により架橋 したポリフェニレンオキサイド膜を、発煙硫酸を用いてスルホン化した、プロ 25 トン酸基含有架橋樹脂膜が報告されている。しかしながら、架橋樹脂膜をスル ホン化する方法は、膜表面と膜内部あるいは膜の裏側で架橋密度やスルホン化 度が異なる、厚膜化が困難であるといった問題を有していた。また、この方法

10

15

20

25

では、電気伝導性を有する導電材や水素の酸化反応、酸素の還元反応を促進する触媒を分散させた燃料電池電極を作成する場合、樹脂中に導電材や触媒を分散させ製膜した後にスルホン化処理を施す必要があり、導電材や触媒の変性、 劣化が避けられなかった。

スルホン化した樹脂を製膜時あるいは製膜後に架橋する方法は、特開平 2-248434 号公報、特開平 4-130140 号公報などに開示されている。しかしながら、 芳香環とクロロアルキル基のフリーデルクラフト反応を用いたこの架橋機構は、 副生物である塩酸の脱離を伴う。そのため、副生物の除去効率の異なる膜表面 と膜内部あるいは膜裏面では架橋密度が異なる、厚膜化が困難であるといった 問題や、膜にボイドができる、脱離した塩酸により製造装置が腐食するといった問題を有していた。

他の架橋機構としては、例えば、特表 2000-501223 号公報、米国特許第6221923 号明細書などには、スルホン化ポリエーテルエーテルケトンの膜中のスルホン 酸同士を脱硫酸縮合させ、スルホネート結合を形成させる架橋機構が報告され ている。特開昭 52-99982 号公報には、クロロスルホン化ポリジフェニルメタ ンからなる膜の、クロロスルホン酸の一部を熱分解して、スルホネート結合に よる架橋結合を生成したのち、残りのクロロスルホン酸を加水分解してスルホ ン酸とする方法が報告されている。国際公開第 99/61141 号明細書には、クロ ロスルホン化ポリエーテルエーテルケトンとジアミンを用いたスルホンアミド 結合による架橋方法が報告されている。しかしながら、これらの方法も、硫酸、 塩酸、塩素などの脱離を伴う架橋機構であり、膜表面と膜内部あるいは膜の裏 面で架橋密度が異なる、厚膜化が困難である、膜にボイドができる、脱離した 酸性ガスにより製造装置が腐食するといった問題を有していた。さらに、これ らプロトン酸基を用いた架橋機構により得られる膜は、架橋密度を向上させる とプロトン酸基が減少(イオン交換基当量が増加)し、イオン伝導性が低下す るといった問題があった。また、スルホンアミド結合は加水分解を受けやすい といった問題も有していた。

硫酸や塩酸などの脱離を伴わない架橋機構としては、特開平 6-93114 号公報に、クロロスルホン化ポリエーテルケトンのクロロスルホン酸基とアリルアミンを反応させて、スルホンアミド基で結合したアリル基とし、製膜後付加反応により架橋させる機構が報告されている。この機構によれば、膜厚さ方向のスルホン化度や架橋密度を均一とすることができる。しかしながら、この方法も、架橋密度を向上させるためにはプロトン酸基を減少(イオン交換基当量を増加)させる必要がある。また、架橋基を結合するスルホンアミド結合は加水分解を受けやすいといった問題も有していた。

なお、プロトン酸基を有さない架橋樹脂においては、様々な架橋機構が提唱 されているが、プロトン酸基が多量に存在する条件下でも架橋反応すること、プロトン酸基とは反応しないこと、架橋により生成する基や鎖が燃料電池内で安定であることなどについてはほとんど知見がない。例えば、エポキシ樹脂やビスマレイミド樹脂の硬化システムは、エポキシやアミンがプロトン酸基と反応するためプロトン酸基が減少する、生成した鎖が加水分解あるいは電気的分 解を受けやすいなどの問題を有し、プロトン酸基含有樹脂の架橋機構として、また、燃料電池用高分子電解質膜として用いることができない。そのため、通常の架橋樹脂においては様々な架橋機構が用いられているにもかかわらず、プロトン酸基含有樹脂においては、前述のごく数種類の架橋機構が用いられるにすぎなかった。

20 以上のことから、燃料電池用高分子電解質膜材料として、製膜時あるいは製膜後に架橋させることができ、プロトン酸基から誘導されず、脱離成分も伴わない架橋機構を有する、プロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂が求められていた。 「燃料電池用プロトン酸基含有結着剤」

一方、高分子電解質型燃料電池において、電極材料の固定や、電極と膜の接 25 着に用いられる結着剤についてはほとんど報告例が無く、僅かにプロトン酸基 含有フッ素系高分子が用いられているのみである。しかしながら、このプロト ン酸基含有フッ素系高分子は、プロトン酸基含有フッ素系高分子からなる高分 子電解質膜には接着するものの、プロトン酸基含有芳香族炭化水素系高分子電解質膜との接着性に乏しかった。

また、結着剤は、電極材料などとの混合や、電極材料、膜との接着を行うために、溶剤溶解性あるいは溶融流動性が必要であり、既に架橋し不溶不融となった樹脂は、結着剤として用いることができなかった。

そのため、接着時あるいは接着後に架橋させることができ、架橋後には優れたイオン伝導性、耐熱性、耐水性、接着性を示す、燃料電池用イオン伝導性結着剤も求められていた。

10 発明の開示

5

15

20

25

本発明者らは、鋭意検討を進めた結果、プロトン酸基から誘導されず、かつ脱離成分の生成なしに架橋し得る架橋基を有する、新規なプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂が、架橋により、優れたイオン伝導性、耐熱性、耐水性、接着性、さらには低メタノール透過性を発現し、燃料電池用イオン伝導性高分子膜および結着剤として好適であることを見出し、本発明を完成するに至った。

本発明の目的は、プロトン酸基から誘導されず、かつ脱離成分の生成なしに 架橋し得る架橋基を有するプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂、ならびにそれ から得られるイオン伝導性が高く、耐熱性、耐水性、接着性に優れた燃料電池 用イオン伝導性高分子膜、結着剤、電極および燃料電池を提供することにある。

本発明は、プロトン酸基を含有する架橋性芳香族樹脂において、架橋基が、 プロトン酸基から誘導されず、かつ脱離成分の生成なしに架橋し得る架橋基を 有するプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂を提供する。

本発明は、プロトン酸基から誘導されず、かつ脱離成分の生成なしに架橋し得る架橋基を有するプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂の具体的な態様として、 該架橋基がカルボニル基および芳香環に直接結合した炭素原子数1~10のアルキル基であるプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂を提供する。

本発明は、カルボニル基および芳香環に直接結合した炭素原子数1~10の

アルキル基を有する前記プロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂のさらに具体的な態様として、カルボニル基、芳香環に直接結合した炭素原子数 1~10のアルキル基およびプロトン酸基を有する、芳香族ポリエーテル、芳香族ポリアミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリアゾールから選ばれる芳香族樹脂を提供する。

本発明は、プロトン酸基から誘導されず、かつ脱離成分の生成なしに架橋し得る架橋基として、カルボニル基および芳香環に直接結合した炭素原子数1~10のアルキル基を有し、光、熱および/または電子線により架橋できるプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂を提供する。

- 10 本発明は、炭素炭素二重結合または三重結合を有する前記プロトン酸基含有 架橋性芳香族樹脂のさらに具体的な他の態様として、炭素炭素二重結合または 三重結合を有する、芳香族ポリエーテル、芳香族ポリアミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリアゾールから選ばれる芳香族樹脂を 提供する。
- 15 本発明は、プロトン酸基から誘導されず、かつ脱離成分の生成なしに架橋し得る架橋基を有するプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂の他の具体的な態様として、該架橋基が炭素炭素二重結合または三重結合であるプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂を提供する。

本発明は、前記プロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂より得られる架橋物、高 20 分子膜、結着剤を提供する。

本発明はまた、前記高分子膜、結着剤を用いて得られる電極、燃料電池を提供する。

本発明の更に一層具体的な態様は、後記の説明から明らかとなる。

[本発明のプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂の優位性]

- 25 本発明のプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂は以下の優位性を有する。
 - ①主鎖構造が芳香環およびその連結基により形成され、3級炭素を含まないため、耐熱性が高く、燃料電池内でのラジカル攻撃による樹脂の変性が小さい。

また、非フッ素系であるため、高温低湿度下でのイオン伝導性の低下が少なく、接着性に優れる。

- ②本発明の樹脂は未架橋時には直鎖状であり、溶剤溶解性、熱可塑性に優れ、 ワニスとしての取り扱い、電極材料との混合、製膜などが容易である。
- 5 ③製膜時、製膜後の熱処理、光照射などにより、脱離成分の生成なしに架橋を 形成できることから、架橋反応に伴う電極材料などの変性、劣化が無く、膜厚 方向での架橋密度が均一であり、厚膜化が容易で、製造装置を腐食するガスも 発生しない。
- ④架橋後の構造が、共有結合でありかつ加水分解を受けにくい構造であること 10 から、燃料電池内で用いた場合の架橋結合の減少が少ない。
 - ⑤プロトン酸基から誘導されない架橋であることから、プロトン酸基量を減少 (イオン交換基当量を増大) させることなく、架橋密度を制御することができ る。
- ⑥架橋により、水、メタノールへの溶解性や吸水、吸メタノール性、燃料のクロスオーバーが抑制されることから、プロトン酸基の導入量を増やすことが可能となる。

[本発明の架橋物、高分子膜、結着剤の優位性]

本発明のプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂より得られる架橋物、高分子膜、結着剤は以下の優位性を有する。

- 20 ①未架橋の膜、結着剤に比べ、水、メタノールへの溶解性や吸水、吸メタノー ル性、燃料のクロスオーバーが抑制される。
 - ②未架橋の膜、結着剤に比べ、プロトン酸基の導入量を増やすことができることから、高いイオン伝導性を有する。
- ③水クラスター、プロトン伝導経路の形成がなく、高温低湿度下でもイオン伝 25 導性の低下が小さい。
 - ④フッ素系樹脂に比べ、高い接着性を有し、電池の結着剤として用いた場合に 膜、電極材料などの剥離による電池特性の低下が小さい。

⑤吸水、吸メタノールによる寸法変化が小さいため、燃料の組成や供給量変化 時の樹脂の寸法変化に伴う剥離と、それによる電池特性の低下が小さい。

[本発明の燃料電池の優位性]

本発明の前記高分子膜、結着剤を用いて得られる燃料電池は、膜、結着剤の イオン伝導性により高い出力が得られると共に、樹脂の溶解、溶出、燃料のクロスオーバーや、電池を構成する膜、電極材料の剥離などによる出力低下が生じにくく、発電効率と信頼性に優れる。

図面の簡単な説明

第1図は、本発明の実施例で用いた燃料電池の断面構造を示す概略図である。
 第2図は実施例で燃料電池の評価に用いた燃料電池評価装置を示すブロックフロー図である。第3図は本発明の実施例で得られた燃料電池の特性を示すグラフである。図1~3中の符号は以下のものを示す。1 電解質膜、2、2, 触媒付き電極、3 ガスケット、4 セパレーター、5 加圧板、6 ガス流路、7 締め付けボルト、8 燃料電池セル、9 加湿用バブリングタンク、10電子負荷、11 マスフローコントローラー、12 送液ポンプ

発明の実施の態様

以下、本発明を具体的に説明する。

20 本発明のプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂は、架橋基を有するプロトン酸 基含有芳香族樹脂であって、プロトン酸基から誘導されず、かつ脱離成分の生 成なしに架橋し得る架橋基を有するプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂である。 「架橋基を有するプロトン酸基含有芳香族樹脂〕

本発明における架橋基を有するプロトン酸基含有芳香族樹脂としては、主鎖 25 が脂肪族鎖を有さず、芳香環およびその連結基で構成される芳香族樹脂であっ て、その構成単位の一部あるいは全部がプロトン酸基を有し、かつ、主鎖、側 鎖、あるいは末端に架橋基を有する樹脂が好ましい。また、本発明において、

樹脂とは、1または2以上の繰り返し構造からなる単一の樹脂のみならず、繰り返し構造の異なる2種以上の樹脂を混合した樹脂組成物をも包含する。

本発明の樹脂は、直鎖状であるため、溶剤溶解性、熱可塑性に優れ、ワニスとしての取り扱い、電極材料との混合、製膜などが容易である。なお、本発明の樹脂は上記特徴を損なわない程度の分岐構造を有していても良い。

本発明の樹脂は、架橋基を有し、架橋後には高い耐水性、耐メタノール性と、低い燃料透過性を示すことから、架橋機構を有さない樹脂に比べ、プロトン酸 基の導入量を増やすことができる。

[プロトン酸基]

- 10 本発明におけるプロトン酸基とは、具体的には、下記式(1)~(3)で示されるスルホン酸基、カルボン酸基、ホスホン酸基などが挙げられる。中でも下記式(1)で示されるスルホン酸基が好ましく、下記式(1)においてn=0で示されるスルホン酸基が特に好ましい。
 - $-C_nH_{nn}-SO_3Y$ (nは0~10の整数、YはH, NaまたはK) (1)
- 15 -C_nH_{2n}-COOY(nは0~10の整数、YはH, NaまたはK) (2)
 - $-C_nH_{2n}-PO_3Y_2$ (nは0~10の整数、YはH, NaまたはK) (3)

本発明のプロトン酸基含有樹脂のプロトン酸基含有量に特に制限はないが、 好ましくは、イオン交換基当量にして200~5000g/mol、より好ま しくは200~1000g/molである。ここで、イオン交換基当量とは、

20 プロトン酸基1モル当たりの樹脂重量で定義され、樹脂単位重量当たりのプロトン酸基のモル数の逆数を意味する。すなわち、イオン交換基当量が小さいほど、樹脂単位重量当たりのプロトン酸基量が多いことを示す。

イオン交換基当量が小さすぎる場合には、未架橋時の樹脂の水への溶解性が 著しく高く、樹脂の製造や精製(樹脂中からの無機酸や無機塩の除去)が困難 25 となる。イオン交換基当量が大きすぎる場合には、未架橋の樹脂であっても耐 水、耐メタノール性が高く、架橋の必要性が低くなる。ただし、イオン交換基 当量が大きすぎる場合には、イオン伝導性が低く高出力の燃料電池を得ること ができない。

5

「芳香族樹脂の具体例]

本発明において、主鎖が脂肪族鎖を有さず、芳香環およびその連結基で構成 される芳香族樹脂とは、具体的には、主鎖が下記で示される構造の少なくとも 1種により構成される樹脂が例示される。

連結基としては、直接結合、-CO-、 $-SO_2-$ 、-S-、 $-CH_2-$ 、 $-CF_2-$ 、-C(CF_3) $_2-$ 、-C(CF_3) $_2-$ 、-O-、-NH-CO-、 -CO-O-、-O-CO-O-、9, 9-フルオレン基などを挙げることができる。

また、芳香環は、その水素原子の一部あるいは全部が以下の置換基で置換さ 20 れているものをも包含する。

 $-C_nH_{2n}-SO_3Y$ 、 $-C_nH_{2n}-COOY$ 、 $-C_nH_{2n}-PO_3Y_2$ (以上上記プロトン酸基 (1) \sim (3) と同じ意味を有する)

 $-C_{n}H_{2n+1}$, $-C_{n}H_{2n}-CH=CH-R$, $-C_{n}H_{2n}-C\equiv C-R$

(以上、nは0~10の整数、YはH, NaまたはK、RはHまたはフェニル

25 基を表す)、

-F, -Cl, Br, CF_3 ,

本発明の芳香族樹脂は、主鎖構造が芳香環およびその連結基により構成され、 3級炭素を含まないため、耐熱性、耐ラジカル性が高い。また、芳香環や連結 基が極性を有するため、フッ素系樹脂に比べ、接着性に優れる。

主鎖が脂肪族鎖を有する樹脂、例えばポリエチレンやポリスチレンなどのポ10 リオレフィン、脂肪族ジアミン類を用いたナイロンや半芳香族ポリアミド、ポリエチレンオキシドなどの脂肪族ポリエーテルは、耐熱性が低く電池内で軟化し変形する、主鎖中の3級炭素が電池内でラジカルの攻撃を受けα位の水素を放出し樹脂が劣化するなどの問題を有するため好ましくない。なお、テフロン(登録商標)など、主鎖がフッ素化脂肪族鎖で構成され、3級炭素を有さない15 樹脂は、耐ラジカル性に優れるが、主鎖が疎水性であるためにプロトン酸基と層分離しやすく、その結果、水クラスターを形成し易いため好ましくない。

本発明における芳香族樹脂とは、例えば、芳香族ポリエーテル、芳香族ポリアミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリアゾール、芳香族ポリエステル、芳香族ポリカーボネートなどが挙げられる。好ましいものとして、芳香族ポリエーテル、芳香族ポリアミド、芳香族ポリアジールを挙げることができる。中でも、未架橋時の溶剤溶解性に優れ、製膜などの加工が容易な芳香族ポリエーテル、芳香族ポリアミドが好ましく、熱水、酸、アルカリ水、アルコール類などによる加水分解を受けない芳香族ポリエーテルが特に好ましい。なお、芳香族ポリエステル、芳香族ポリカーボネートなど、主鎖が熱水、酸、アルカリ水、アルコール類などによる加水分解を受けやすい樹脂の場合には、燃料電池中での使用条件下で、主鎖が徐々に分解、低分子量化することにより、強度、接着性の低

20

25

下や樹脂の溶出などが起こる恐れがある。

ここで、本発明における芳香族ポリエーテルとは、たとえば、ポリフェニレンオキシドなど、芳香環の連結基がエーテル基のみからなる芳香族ポリエーテルだけでなく、連結基がエーテル基とカルボニル基からなるポリエーテルケトン、連結基がエーテル基とスルホン基からなるポリエーテルスルホン、ポリスルホン、およびポリエーテルニトリル、ポリエーテルピリジンをも包含する。

[架橋基]

5

15

20

25

本発明の架橋基は、プロトン酸基から誘導されず、かつ脱離成分の生成なし 10 に架橋し得る架橋基である。ここで、本発明における架橋とは、高分子鎖同士 が共有結合により結合されることを示し、解離や再結合を繰り返すイオン結合 や水素結合などによる高分子鎖同士の相互作用は含まない。

本発明において、プロトン酸基から誘導されない架橋とは、高分子鎖同士を結合させるためにプロトン酸基を用いない架橋をいう。言い換えれば、架橋後に高分子鎖同士を結合する基または鎖がプロトン酸基から誘導された基または鎖ではない架橋をいう。すなわち、本発明のプロトン酸基から誘導されない架橋には、架橋反応時にプロトン酸基が化学的に反応する架橋はもちろん、事前にプロトン酸基を介して架橋基を導入し、その後に架橋する架橋も含まれない。

本発明のプロトン酸基から誘導されない架橋は、樹脂のプロトン酸基量を減少 (イオン交換基当量を増大) させることなく、樹脂の架橋密度を制御することができるので好ましい。

一方、プロトン酸基から誘導される架橋は、架橋密度を増大させるためには、 より多くのプロトン酸基を用いる必要があり、その結果、得られる架橋樹脂の イオン伝導性が低下するため好ましくない。プロトン酸基から誘導される架橋 としては、芳香環とクロロアルキル基のフリーデルクラフト反応により高分子 鎖同士を結合する架橋、スルホン酸同士の脱硫縮合により高分子鎖同士を結合 する架橋、クロロスルホン酸同士を反応させて高分子鎖同士を結合する架橋、 高分子鎖のクロロスルホン酸同士をスルホンアミド基を介して結合する架橋、 クロロスルホン酸基とアリルアミンとの反応により高分子の側鎖にアリル基を 導入した後、アリル基同士を付加反応させて高分子鎖同士を結合する架橋など が挙げられる。

- 5 本発明において、脱離成分を生成しない架橋とは、脱離成分のない反応により、高分子鎖同士を結合する架橋機構を示す。ここで、脱離成分とは、例えば、フリーデルクラフト反応におけるハロゲン化炭化水素または塩、縮合反応における、水、ハロゲン化水素または塩といった、反応において生成し、樹脂鎖と結合していない副生物を示す。
- 10 本発明の脱離成分を生成しない架橋は、脱離成分による電極材料の変性、劣化がなく、膜厚方向での架橋密度が均一であり、厚膜化が容易で、製造装置を腐食するガスも発生しないため好ましい。
 - 一方、脱離成分を生成する架橋は、脱離成分の除去操作が必要である、脱離 成分の除去効率の異なる膜表面と膜内部あるいは膜裏面で架橋密度が異なる、
- 75 厚膜化が困難である、膜にボイドができる、脱離した酸性ガスにより電極材料や製造装置が腐食するなどの問題を有し、好ましくない。脱離成分を生成する架橋としては、芳香環とハロゲンのフリーデルクラフト反応によりハロゲン化水素を副生する架橋、スルホン酸同士の脱硫縮合により硫酸を副生する架橋、クロロスルホン酸とアミンの反応により塩酸を副生する架橋などが挙げられる。

[架橋基の具体例]

本発明における、プロトン酸基から誘導されず、かつ脱離成分の生成なしに 架橋し得る架橋基の具体例としては、カルボニル基および芳香環に直接結合し た炭素原子数1~10のアルキル基である架橋基、または炭素炭素二重結合ま たは三重結合である架橋基などを挙げることができる。。

なかでも、架橋基がカルボニル基および芳香環に直接結合した炭素原子数1 ~10のアルキル基である架橋基は、樹脂を構成する繰り返し単位1単位中に

25

プロトン酸基、カルボニル基、アルキル基をそれぞれ同時に1以上含有することができ、著しく高い架橋密度を得ることができるため、特に好ましい。また、この架橋機構は架橋により生成する結合中にラジカルの攻撃を受けやすい3級 炭素のα位の水素を含まないため、特に好ましい。

5 [カルボニル基および芳香環に直接結合した炭素原子数1~10のアルキル基 である架橋基]

本発明の架橋基がカルボニル基および芳香環に直接結合した炭素原子数1~10のアルキル基であるプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂における架橋機構について説明する。ポリマー中のカルボニル基、および、ポリマー中の芳香環10 に直接結合した炭素原子数1~10のアルキル基は次のような形で架橋反応に関与していると推定される。下記反応式はアルキル基がメチル基の場合について示した。

上記反応式に示すように、紫外線照射や加熱処理などによるエネルギー供給により、ベンゾフェノン上にラジカルが発生し、これがメチル基から水素を引き抜く。引き続き、ベンジルラジカルの二量化、ベンジルラジカルとアルコール性炭素ラジカルカップリング反応、アルコール性炭素ラジカルの二量化のような反応が起こることで、ポリマー同士の架橋が起こっていると推定される。

[炭素炭素二重結合または三重結合である架橋基]

本発明における好ましい炭素炭素二重結合または三重結合である架橋基としては、側鎖に少なくとも1つ有する $-C_mH_{2m}-CH=CH-R$ または $-C_mH_{2m}-C\equiv C-R$ で表される基(mは $0\sim 1$ 0の整数、RはHまたはフェニル基を表す)、分子末端に少なくとも1つ有する-R°--CH=CH-R°または-R°- $-C\equiv C-R$ °基(R°はフェニレン基、R°はHまたはフェニル基を示す)、分子末端に少なくとも1つ有する下記式(4)または(5)で表される基などを挙げることができる。

10

5

$$\begin{array}{ccc}
\bullet & \bullet & \bullet \\
\bullet & \bullet & \bullet \\
\bullet & \bullet & \bullet
\end{array}$$
(4)

[式 (4) 中、Ar¹ は、

15 を表し、R、R'は同一でも異なっていてもよく、水素、メチル基、エチル基 またはフェニル基を表す。]

$$-NHCO-Ar^2$$
 (5)

[式 (5) 中、Ar²は、

20 を表し、R、R'は、式(4)と同じ意味を表し、同一でも異なっていてもよ

い。]

炭素炭素二重結合または三重結合である架橋基の存在により、主として熱によって本発明のプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂を架橋させることができ、 樹脂の耐溶剤性および耐熱性を向上させることができる。

5

10

15

20

「プロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂の具体例1]

架橋基としてカルボニル基および芳香環に直接結合した炭素原子数1~10のアルキル基を有するプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂は、本発明のプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂のより好ましい態様である。このような芳香族樹脂として、芳香族ポリエーテル、芳香族ポリアミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリアゾールなどを挙げることができる。中でも、未架橋時の溶剤溶解性に優れ、製膜などの加工が容易な芳香族ポリエーテル、芳香族ポリアミドが好ましく、熱水、酸、アルカリ水、アルコール類などによる加水分解を受けない芳香族ポリエーテルが特に好ましい。すなわち、カルボニル基および芳香環に直接結合した炭素原子数1~10のアルキル基を有するプロトン酸基含有架橋性芳香族ポリエーテルが特に好ましい。

以下にカルボニル基および芳香環に直接結合した炭素原子数1~10のアルキル基を有するプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂の具体例を示す。

なお、本発明の式において、同一の記号は同じ定義を意味するが、それぞれ は同じでも異なっていてもよい。

[プロトン酸基含有架橋性芳香族ポリエーテル1]

本発明における、架橋基がカルボニル基および芳香環に直接結合した炭素原子数1~10のアルキル基であるプロトン酸基含有架橋性芳香族ポリエーテルの具体例としては、全繰り返し構造単位に対し、

25 下記式 (6) で表される繰り返し構造単位 10~100モル%、および下記式 (7) で表される繰り返し構造単位 0~90モル%を含み、

 $R^{1} \sim R^{10}$ の少なくとも1つが $-C_mH_{2m+1}$ (mは1~10の整数) であり、

かつ $X^1 \sim X^{10}$ の少なくとも1つがプロトン酸基である芳香族ポリエーテルケトンを挙げることができる。

$$\begin{array}{c|c}
 & R^7 & R^8 & R^{10} \\
\hline
 & Q & R^7 & R^8 & R^{10} \\
\hline
 & Q & R^7 & R^8 & R^{10} \\
\hline
 & Q & R^7 & R^8 & R^{10} \\
\hline
 & Q & R^7 & R^8 & R^{10} \\
\hline
 & Q & R^7 & R^8 & R^{10} \\
\hline
 & Q & R^8 & R^{10} & R^{10} \\
\hline
 & Q & R^8 & R^{10} & R^{10} \\
\hline
 & Q & R^8 & R^{10} & R^{10} \\
\hline
 & Q & R^8 & R^{10} & R^{10} \\
\hline
 & Q & R^8 & R^{10} & R^{10} \\
\hline
 & Q & R^8 & R^{10} & R^{10} \\
\hline
 & Q & R^8 & R^{10} & R^{10} \\
\hline
 & Q & R^8 & R^{10} & R^{10} \\
\hline
 & Q & R^8 & R^{10} & R^{10} \\
\hline
 & Q & R^8 & R^{10} & R^{10} \\
\hline
 & Q & R^8 & R^{10} & R^{10} \\
\hline
 & Q & R^8 & R^{10} & R^{10} \\
\hline
 & Q & R^8 & R^{10} & R^{10} \\
\hline
 & Q & R^8 & R^{10} & R^{10} \\
\hline
 & Q & R^8 & R^{10} & R^{10} \\
\hline
 & Q & R^8 & R^{10} & R^{10} \\
\hline
 & Q & R^8 & R^{10} & R^{10} \\
\hline
 & Q & R^8 & R^{10} & R^{10} \\
\hline
 & Q & R^8 & R^{10} & R^{10} \\
\hline
 & Q & R^8 & R^{10} & R^{10} \\
\hline
 & Q & R^{10$$

10

15

20

25

式 (6) および (7) 中、 $R^1 \sim R^{10}$ はそれぞれ独立して、Hまたは $-C_m$ H_{2m+1} (mは $1 \sim 10$ の整数)、 $X^1 \sim X^{10}$ は、それぞれ独立して、Hまたは プロトン酸基、 $A^1 \sim A^3$ は、それぞれ独立して、直接結合、 $-CH_2 -$ 、-C (CH_3) $_2 -$ 、-C (CF_3) $_2 -$ 、-O-、 $-SO_2 -$ または-CO-であり、i, j, kおよび 1 は、それぞれ独立して、0または 1を示す。式 (6) および 1 で、1 の の の の の で、1 の の で、1 の の で、1 の の で、1 の で、1 の の で、1 の で、1 の で、1 の で、1 の の で、1 の で、

式(6) および(7) で表される繰り返し構造単位は、それぞれアルキル基 およびプロトン酸基の双方を含む単位、いずれか一方を含む単位またはその双 方とも含まない単位と、任意の形をとり得る。式(6) および(7) それぞれ が、複数の形態で存在してもよい。

本発明のプロトン酸基含有架橋性芳香族ポリエーテルケトンは、式(6)で表される繰り返し構造単位 10~100モル%および式(7)で表される繰り返し構造単位 0~90モル%を含んでいれば、式(6)および(7)と異なる構造単位を含んでいてもよい。

本発明のプロトン酸基含有架橋性ポリエーテルケトンの中でも、下記式(8)で表される繰り返し構造単位 10~100モル%、および下記式(9)で表

される繰り返し構造単位 $0\sim9$ 0モル%を含み、 $R^3\sim R^5$ 、 $R^8\sim R^{10}$ の少なくとも1つが一 C_mH_{2m+1} (mは $1\sim1$ 0の整数)、 X^1 、 X^2 、 X^6 および X^7 の少なくとも1つがプロトン酸基であり、かつ、 A^2 が一 SO_2 一または一CO一である芳香族ポリエーテルケトンが好ましい。

5

$$\begin{array}{c|c}
O & R^3 & R^4 & R^5 \\
\hline
O & I & A^1 & A^1 & A^1 & A^1 & A^2 &$$

10

25

$$\begin{array}{c|c}
 & R^8 & R^9 & R^{10} \\
\hline
 & A^3 & A^3$$

式 (8) および (9) 中、R 3 ~R 5 およびR 8 ~R 10 はそれぞれ独立して、 15 Hまたは $-C_mH_{2m+1}$ (mは1~10の整数)、 X^1 、 X^2 、 X^6 および X^7 は、 それぞれ独立して、Hまたはプロトン酸基、 A^1 ~A 3 は、それぞれ独立して、 直接結合、 $-CH_2$ -、-C (CH_3) $_2$ -、-C (CF_3) $_2$ -、-O-、-S O_2 -または-CO-であり、i, j, kおよび l は、それぞれ独立して、 0 または l を示す。式 (8) および (9) の芳香環の水素原子は、 $-C_mH_{2m+1}$ 20 (mは l ~10の整数)、プロトン酸基、l l 、l 下またはl l l 。

該芳香族ポリエーテルケトンのプロトン酸基は、電子吸引基である $-SO_2$ ーまたは-COーに直接結合した芳香環に結合していることから、他の芳香環に結合したプロトン酸基に比べ、結合力が強く、分解、解離を受けにくい。なお、既存の芳香族ポリエーテルケトンを発煙硫酸などでスルホン化した場合には、電子吸引基である $-SO_2$ ーまたは-COーに直接結合していない芳香環にスルホン酸基が導入されることが知られている。

本発明のプロトン酸基含有架橋性ポリエーテルケトンの中でも、下記式(10)で表される繰り返し構造単位 $10\sim100$ モル%、および下記式(11)で表される繰り返し構造単位 $0\sim90$ モル%を含む芳香族ポリエーテルケトンは特に好ましい。

$$\begin{array}{c|c}
\hline
(X)_{x} & (Y)_{y}
\end{array}$$
O-Ar -O-
(10)

(式(10)および(11)中、Arは、下記式(12)または(13)で表される基を示し、その芳香環の水素は、アルキル基、ハロゲン化炭化水素基あるいはハロゲンで置換されていてもよく、XおよびYはそれぞれ、プロトン酸基を表し、xおよびyは0以上の整数であり、少なくともx+yは1以上である。)

20 (式(1 2)中、R 21 ~R 28 はそれぞれ独立してHまたは $^{-}$ C $_{m}$ H $_{2m+1}$ (m は 1 $^{-}$ 1 $^{-}$ 0 の整数)を表し、少なくとも一つは $^{-}$ C $_{m}$ H $_{2m+1}$ を表す。Aは、単 結合、 $^{-}$ CH $_{2}$ $^{-}$ 、 $^{-}$ C(CH $_{3}$) $_{2}$ $^{-}$ 、 $^{-}$ C) $^{-}$ SO $_{2}$ $^{-}$ または

を表す。)

$$R^{29}$$
 R^{30} (13)

(式 (13) 中、 $R^{29} \sim R^{32}$ はそれぞれ独立してHまたは $-C_m H_{2m+1}$ (m 5 は $1 \sim 10$ の整数) を表し、少なくとも一つは $-C_m H_{2m+1}$ である。)

該芳香族ポリエーテルケトンはすべての繰り返し構造単位中にカルボニル基 および芳香環に直接結合したアルキル基を有するため、高度に架橋することが できる。

[プロトン酸基含有架橋性芳香族ポリエーテル1の製造方法例]

10 式(6)で表される繰り返し構造単位を含むプロトン酸基含有架橋性芳香族 ポリエーテルケトンは、以下の方法によって得ることができる。

例えば、下記式(14)および(15)で表される芳香族ジヒドロキシ化合物と、下記式(16)および(17)で表される芳香族ジハライド化合物とを縮合重合させることにより製造する方法を挙げることができる。

15

$$HO \xrightarrow{\mathbb{I}^3} \left\{ A^1 \xrightarrow{\mathbb{I}^1} A^1 \xrightarrow{\mathbb{I}^1} OH \right\}$$

$$X^4 \qquad X^5 \qquad Y$$

20
$$HO = \begin{pmatrix} A^3 & A^3 &$$

式(14)から(17)におけるR¹~R¹⁰、X¹~X¹⁰およびA¹~A³は、 10 式(6)および(7)と同じ意味を表し、Yはハロゲンまたはニトロ基を表す。 芳香族ジヒドロキシ化合物および芳香族ジハライド化合物は、プロトン酸基 および/またはアルキル基を含有するもの、および含有しないものを適宜の量 で組み合わせることにより、目指すプロトン酸基及びアルキル基の量を有する 芳香族ポリエーテルケトンを得ることができる。以下に説明する芳香族樹脂を

15 重縮合により得る場合においても同様のことが言える。

ちなみに、式(14)から(17)で表される化合物それぞれ1モルを縮合 重合した場合、式(6)で表される繰り返し構造単位0.5モル、式(7)で 表される繰り返し構造単位0.5モルと、式(14)と式(17)で表される 化合物から誘導される繰り返し構造単位0.5モル、式(15)と式(16) で表される化合物から誘導される繰り返し構造単位0.5モルの、4つの繰り 返し構造単位を、前繰り返し構造単位に対してそれぞれ25モル%ずつ有する 芳香族ポリエーテルケトンが得られる。

式(6)で表される繰り返し構造単位を含むプロトン酸基含有架橋性芳香族ポリエーテルケトンを得ることができる他の好ましい方法の一つとして、芳香族ポリエーテルケトンもしくはポリエーテルエーテルケトンなどの芳香族ポリエーテルケトンに、公知のスルホン化、アルキルスルホン化などの方法により所望量のプロトン酸基を導入する方法を挙げることができる。

20

25

[プロトン酸基含有架橋性芳香族ポリエーテル2]

本発明における、架橋基がカルボニル基および芳香環に直接結合した炭素原子数1~10のアルキル基であるプロトン酸基含有架橋性芳香族ポリエーテルの他の具体例としては、全繰り返し構造単位に対し、

5 下記式 (18) で表される繰り返し構造単位 $10\sim100$ モル%、 および下記式 (19) で表される繰り返し構造単位 $0\sim90$ モル%を含み、 $R^1\sim R^{10}$ および $R^{1'}$ 、 $R^{2'}$ の少なくとも1つが $-C_mH_{2m+1}$ (mは $1\sim10$ の整数) であり、かつ $X^1\sim X^{10}$ の少なくとも1つがプロトン酸基である芳香族ポリエーテルを挙げることができる。

10

15

$$\begin{array}{c|c}
 & R^6 \\
\hline
 & A^2 \\
\hline
 & X^6
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & R^8 \\
\hline
 & R^9 \\
\hline
 & R^{10} \\
\hline
 & A^3 \\
\hline
 & X^9
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & A^{3} \\
\hline
 & X^9
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & X^{10} \\
\hline
 & X^{10}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & X^{10} \\
\hline
 & X^{10}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & X^{10} \\
\hline
 & X^{10}
\end{array}$$

20

25

式 (18) および (19) 中、 $R^1 \sim R^{10}$ 、 R^1 、 R^2 はそれぞれ独立して、Hまたは $-C_mH_{2m+1}$ (mは $1\sim 10$ の整数)、 $X^1\sim X^{10}$ は、それぞれ独立して、Hまたはプロトン酸基、 $A^0\sim A^3$ は、それぞれ独立して、直接結合、 $-CH_2-$ 、-C (CH_3) $_2-$ 、-C (CF_3) $_2-$ 、-O-、 $-SO_2-$ または-CO-、Vは、それぞれ独立して CH、NまたはC-CNであり、g, h, i, j, kおよび l は、それぞれ独立して、0または l を示す。式 (1

8) および(19)の芳香環の水素原子は、 $-C_mH_{2m+1}$ (mは1 \sim 10の整数)、プロトン酸基、C1、FまたはCF。に置換されていてもよい。

式(18) および(19) で表される繰り返し構造単位は、それぞれアルキル基およびプロトン酸基の双方を含む単位、いずれか一方を含む単位またはその双方とも含まない単位と、任意の形をとり得る。式(18) および(19) それぞれが、複数の形態で存在してもよい。

本発明のプロトン酸基含有架橋性芳香族ポリエーテルは、式(18)で表される繰り返し構造単位 10~100モル%および式(19)で表される繰り返し構造単位 0~90モル%を含んでいれば、式(18)および(19)と異なる構造単位を含んでいてもよい。

[プロトン酸基含有架橋性芳香族ポリアミド 1]

本発明における、架橋基がカルボニル基および芳香環に直接結合した炭素原子数1~10のアルキル基であるプロトン酸基含有架橋性芳香族ポリアミドとしては、下記式 (20) で表される繰り返し構造単位 10~100モル%、および下記式 (21) で表される繰り返し構造単位 0~90モル%を含み、 $R^1~R^{10}$ の少なくとも1つが $-C_mH_{2m+1}$ (mは1~10の整数) であり、かつ $X^1~X^{10}$ の少なくとも1つがプロトン酸基であり、 A^1 または A^2 のうち少なくとも1つが-COである芳香族ポリアミドを挙げることができる。

20

5

10

15

$$-HNOC \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} A^1 & A^2 & A^3 & A^4 & A^5 \\ \hline X^1 & X^2 & X^3 & X^4 & X^5 \end{pmatrix}_{j} A^2 \xrightarrow{l_1} \begin{pmatrix} A^2 & A^$$

10

15

20

式(20)および(21)中、 $R^1 \sim R^{10}$ はそれぞれ独立して、Hまたは一 C_mH_{2m+1} (mは $1 \sim 10$ の整数)、 $X^1 \sim X^{10}$ は、それぞれ独立して、Hまたはプロトン酸基、 $A^1 \sim A^4$ は、それぞれ独立して、直接結合、 $-CH_2$ ー、-C(CH_3) $_2$ ー、-C(CF_3) $_2$ ー、-Oー、 $-SO_2$ ーまたは-COーであり、i, j, k, lおよびnは、それぞれ独立して、0または1を示す。式(20)および(21)の芳香環の水素原子は、 $-C_mH_{2m+1}$ (mは $1 \sim 10$ の整数)、プロトン酸基、Cl、Fまたは CF_3 に置換されていてもよい。

式(20)および式(21)で表される繰り返し構造単位は、それぞれアルキル基およびプロトン酸基の双方を含む単位、いずれか一方を含む単位またはその双方を含まない単位の形をとり得る。

例えば、式(20)で表される繰り返し単位が、アルキル基およびプロトン 酸基の双方を含む単位であるとき、式(21)で表される繰り返し単位が、プロトン酸基を含まない繰り返し単位であって、式(20)で表される繰り返し 単位と式(21)で表される繰り返し単位のモル比が20~90モル%:80 ~10モル%であるポリアミド樹脂は本発明の芳香族ポリアミドの好ましい態 様である。

本発明のプロトン酸基含有架橋性芳香族ポリアミドは、式 (20) で表される繰り返し構造単位 $10\sim100$ モル%および式 (21) で表される繰り返し構造単位 $0\sim90$ モル%を含んでいれば、式 (20) および式 (21) と異なる構造単位を含んでいてもよい。

本発明のプロトン酸基含有架橋性芳香族ポリアミドを得る方法としては、芳香族ジアミンと芳香族ジカルボン酸クロリドを公知の方法で重縮合することにより得る方法を挙げることができる。

例えば、上記式(20)の繰り返し単位を有する芳香族ポリアミドを得るた 25 めには、芳香族ジカルボン酸クロリドと芳香族ジアミンとして、下記式(22) の芳香族ジカルボン酸クロリドおよび下記式(23)の芳香族ジアミンなどを 用いることができる。

式 $(2\ 2)$ および $(2\ 3)$ 中、 $R^1\sim R^5$ 、 $X^1\sim X^5$ 、 $A^1\sim A^2$ および i, 10 j , n は、上記式 $(2\ 0)$ と同じ意味を持つ。式中の芳香環の水素原子は、- C_mH_{2m+1} (mは $1\sim 1\ 0$ の整数)、プロトン酸基、Cl、Fまたは CF_3 に置換されていてもよい。

式 (20)で表される繰り返し構造単位を含むプロトン酸基含有架橋性芳香 族ポリアミドを得ることができる他の好ましい方法の一つとして、芳香族ポリ 15 アミドに、公知のスルホン化、アルキルスルホン化などの方法により所望量の プロトン酸基を導入する方法を挙げることができる。

「プロトン酸基含有架橋性芳香族ポリイミド 1]

本発明における、架橋基がカルボニル基および芳香環に直接結合した炭素原子数1~10のアルキル基であるプロトン酸基含有架橋性芳香族ポリイミドとしては、全繰り返し構造単位に対し、

下記式 (24) で表される繰り返し構造単位 $10\sim100$ モル%、 および下記式 (25) で表される繰り返し構造単位 $0\sim90$ モル%を含み、 $R^3\sim R^5$ 、 $R^8\sim R^{10}$ の少なくとも1つが $-C_mH_{2m+1}$ (mは $1\sim10$ の整数) であり、かつ $X^3\sim X^5$ 、 $X^8\sim X^{10}$ の少なくとも1つがプロトン酸基であり、 A^1 または A^2 のうち少なくとも1つが-CO-である芳香族ポリイミドを挙げることができる。

20

25

10

式 (24) および (25) 中、R³~R⁵、R⁸~R¹⁰はそれぞれ独立して、 Hまたは-C_mH_{2m+1} (mは1~10の整数)、X³~X⁵、X⁸~X¹⁰は、そ れぞれ独立して、Hまたはプロトン酸基、A²およびA⁴は、それぞれ独立し て、直接結合、 $-CH_2-$ 、 $-C(CH_3)_2-$ 、 $-C(CF_3)_2-$ 、-O-、 $-SO_2$ -または-CO-であり、i, j, kおよび l は、それぞれ独立して、 Oまたは1を示し、Ar³およびAr⁴は、それぞれ

25

15

を表し、 A^1 および A^3 は、それぞれ独立に、直接結合、 $-CH_2-$ 、-C(C H_3) $_2-$ 、-C (CF $_3$) $_2-$ 、-O-、-SO $_2-$ または-CO-である。 式 (24) および (25) の芳香環の水素原子は、-C_mH_{2m+1} (mは1~ 10の整数)、プロトン酸基、C1、FまたはCF₃に置換されていてもよい。 式(24)および(25)は、種々の繰り返し単位の形をとり得ることは、 上記式(20)および(21)について述べたとおりである。

例えば、式(24)で表される繰り返し単位が、アルキル基とプロトン酸基を有し、式(25)で表される繰り返し単位がプロトン酸基を含まない繰り返し単位であって、式(24)で表される繰り返し単位と式(25)で表される繰り返し単位のモル比が20~90モル%:80~10モル%であるポリイミド樹脂は本発明の芳香族ポリイミド樹脂の好ましい態様である。

本発明のプロトン酸基含有架橋性芳香族ポリイミドは、式(24)で表される繰り返し構造単位 $10\sim100$ モル%および式(25)で表される繰り返し構造単位 $0\sim90$ モル%を含んでいれば、式(24)および式(25)と異なる構造単位を含んでいてもよい。

10 上記式(24)で表される繰り返し単位を含む芳香族ポリイミドを得る方法 として、芳香族ジアミンと芳香族テトラカルボン酸二無水物とを有機溶媒中で 反応させ、前駆体のポリアミド酸とした後、熱イミド化または化学イミド化す ることにより得る方法を挙げることができる。

芳香族ジアミンと芳香族テトラカルボン酸二無水物としては、それぞれ下記 15 式 (26) および (27) で表される化合物を挙げることができる。

20

5

式(26)および(27)中、R³~R⁵、X³~X⁵、A²およびAr³、並びにiおよびjは、上記式(24)と同じ意味を表す。式(26)および(27)の芳香環の水素原子は、-C_mH_{2m+1}(mは1~10の整数)、プロトン

酸基、C1、FまたはCF3に置換されていてもよい。

式 (24) で表される繰り返し構造単位を含むプロトン酸基含有架橋性芳香 族ポリイミドを得ることができる他の好ましい方法の一つとして、芳香族ポリ イミドに、公知のスルホン化、アルキルスルホン化などの方法により所望量の プロトン酸基を導入する方法を挙げることができる。

[プロトン酸基含有架橋性芳香族ポリアミドイミド 1]

本発明における、架橋基がカルボニル基および芳香環に直接結合した炭素原子数 $1\sim10$ のアルキル基であるプロトン酸基含有架橋性芳香族ポリアミドイミドとしては、全繰り返し構造単位に対し、下記式(28)で表される繰り返し 構造単位 $10\sim100$ モル%、および下記式(29)で表される繰り返し 構造単位 $0\sim90$ モル%を含み、 $R^1\sim R^{10}$ の少なくとも1つが $-C_mH_{2m+1}$ (mは $1\sim10$ の整数)であり、かつ $X^1\sim X^{10}$ の少なくとも1つがプロトン酸基であり、 A^1 または A^2 のうち少なくとも1つが-CO一である芳香族ポリアミドイミドを挙げることができる。

式 (28) および (29) 中、 $R^1 \sim R^{10}$ はそれぞれ独立して、Hまたはー C_mH_{2m+1} (mは $1\sim 10$ の整数)、 $X^1\sim X^{10}$ は、それぞれ独立して、Hまたはプロトン酸基、 $A^1\sim A^4$ は、それぞれ独立して、直接結合、 $-CH_2-$ 、-C $(CH_3)_2-$ 、-C $(CF_3)_2-$ 、-O-、 $-SO_2-$ または-CO-で

あり、i, j, k、1およびnは、それぞれ独立して、0または1を示す。

式 (28) および (29) の芳香環の水素原子は、 $-C_mH_{2m+1}$ (mは1~10の整数)、プロトン酸基、C1、Fまたは CF_3 に置換されていてもよい。

式(28)および(29)で表される繰り返し構造単位は、前記式(20)

5 および(21)について述べたとおり種々の繰り返し単位の形をとり得る。例 えば、式(28)で表される繰り返し単位がアルキル基およびプロトン酸基を 有し、式(29)で表される繰り返し単位がプロトン酸基を含まない繰り返し 単位であって、式(28)で表される繰り返し単位と式(29)で表される繰 り返し単位のモル比が20~90モル%:80~10モル%であるポリアミド イミドは本発明の芳香族ポリアミドイミドの好ましい態様である。

本発明のプロトン酸基含有架橋性芳香族アミドイミドは、式(28)で表される繰り返し構造単位 $10\sim100$ モル%および式(29)で表される繰り返し構造単位 $0\sim90$ モル%を含んでいれば、式(28)および(29)と異なる構造単位を含んでいてもよい。

15 前記式(28) および。(29) で表される繰り返し単位を有する芳香族ポリアミドイミドは、芳香族ジアミンとトリカルボン酸無水物モノクロリドを有機溶媒中で重縮合しポリアミド酸前駆体とした後、熱イミド化または化学イミド化することにより得ることができる。

例えば式 (28) で表される繰り返し単位を有する芳香族ポリアミドイミド 20 は、下記式 (30) で表される芳香族ジアミンと、下記式 (31) で表される トリカルボン酸無水物モノクロリドを公知の方法で重縮合させることにより得ることができる。

$$H_{2}N \xrightarrow{\mathbb{Q}^{3}} \begin{pmatrix} A^{2} & A^{5} & A^{5} & A^{2} &$$

$$O \xrightarrow{R^1} A^1 \xrightarrow{R^2} COCI$$

$$O \xrightarrow{C} X^1 \qquad X^2 \qquad n$$
(31)

5 式(30) および式(31) 中、R¹~R⁵、X¹~X⁵、A¹~A²およびi, jおよびnは、前記式(28) と同じ意味を表す。

式 (30) および式 (31) の芳香環の水素原子は、 $-C_mH_{2m+1}$ (mは1 \sim 10の整数)、プロトン酸基、Cl、Fまたは CF_3 に置換されていてもよい。

式(28)で表される繰り返し構造単位を含むプロトン酸基含有架橋性芳香 族ポリアミドイミドを得ることができる他の好ましい方法の一つとして、芳香 族アミドイミドに、公知のスルホン化、アルキルスルホン化などの方法により 所望量のプロトン酸基を導入する方法を挙げることができる。

[プロトン酸基含有架橋性芳香族ポリアゾール 1]

本発明における、架橋基がカルボニル基および芳香環に直接結合した炭素原子数 $1\sim100$ アルキル基であるプロトン酸基含有架橋性芳香族ポリアゾールとしては、全繰り返し単位に対し、下記式(32)で表される繰り返し構造単位 $10\sim100$ モル%、および下記式(33)で表される繰り返し構造単位 $0\sim90$ モル%を含み、 $R^3\sim R^5$ 、 $R^8\sim R^{10}$ の少なくとも1つが $-C_mH_{2m}$ (mは $1\sim10$ の整数)であり、かつ $X^3\sim X^5$ 、 $X^8\sim X^{10}$ の少なくとも 1つがプロトン酸基であり、 A^1 または A^2 のうち少なくとも1つが一CO-である芳香族ポリアゾールを挙げることができる。

$$-c \stackrel{N}{\underset{Z}{\nearrow}} Ar^{6} \stackrel{N}{\underset{Z}{\nearrow}} c \stackrel{R^{8}}{\underset{U}{\nearrow}} A^{4} \stackrel{R^{9}}{\underset{U}{\nearrow}} A^{4} \stackrel{R^{10}}{\underset{U}{\nearrow}} A^{4} \stackrel{R^{1$$

式 (32) および (33) 中、 $R^3 \sim R^5$ 、 $R^8 \sim R^{10}$ はそれぞれ独立して、 Hまたは $-C_mH_{2m+1}$ (mは $1\sim 10$ の整数)、 $X^3 \sim X^5$ 、 $X^8 \sim X^{10}$ は、それぞれ独立して、Hまたはプロトン酸基、Zは-NH-または-O-を表し、 A^2 および A^4 は、それぞれ独立して、直接結合、 $-CH_2$ -、-C(CH_3)。 -、-C(CF_3)。 -、-O-、 $-SO_2$ -または-CO-であり、i, j, kおよび 1 は、それぞれ独立して、0または 1を示し、A r 5 および A r 6 は、それぞれ

15 および

を表し、 A^1 および A^3 は、それぞれ独立に、直接結合、 $-CH_2-$ 、-C(CH_3)。-、-C(CF_3)。-、-C0、 $-SO_3$ -または-CO-である。

20 式(32) および(33) の芳香環の水素原子は、一C_mH_{2m+1} (mは1~10の整数)、プロトン酸基、C1、FまたはCF₃に置換されていてもよい。本発明におけるプロトン酸基含有架橋性芳香族ポリアゾールは、前記式(32) および(33) で表される-Z-が、-NH-であるポリベンゾイミダゾールと、-Z-が-O-であるポリベンゾオキサゾールに大別される。

25 - Z - が - NH - であるポリベンゾイミダゾールは、芳香族テトラアミンと 芳香族ジカルボン酸エステルを公知の方法で縮合させることにより得ることが できる。また、Z が - O - であるポリベンゾオキサゾールは、ジアミノジヒド ロキシ化合物と、芳香族ジカルボン酸を、公知の方法で重縮合させすることに より得ることができる。

プロトン酸基を有するポリベンゾイミダゾールまたはポリベンゾオキサゾー ルは、重縮合の際プロトン酸基を含有するモノマーを使用することによって得 ることができる。また、ポリベンゾオキサゾールもしくはポリベンゾイミダゾ 5 ールなどの芳香族ポリアゾールに、公知のスルホン化、アルキルスルホン化な どの方法により所望量のプロトン酸基を導入することにより得ることができる。 式(32)および(33)は、種々の繰り返し単位の形をとり得る。例えば、 式 (32)で表される繰り返し単位が、R3~R5の少なくとも1つが一C-H 2m+1 (mは1~10の整数) であり、かつX3~X5の少なくとも1つがプロ 10 トン酸基である繰り返し単位であり、式(33)で表される繰り返し単位がプ ロトン酸基を含まない繰り返し単位であり、A¹, A²の少なくとも1つが-CO-であって、式(32)で表される繰り返し単位と式(33)で表される 繰り返し単位のモル比が20~90モル%:80~10モル%であるポリアゾ ールは本発明の芳香族ポリアゾールの好ましい態様である。 15

本発明のプロトン酸基含有架橋性芳香族ポリアゾールは、式(32)で表される繰り返し構造単位 10~100モル%および式(33)で表される繰り返し構造単位 0~90モル%を含んでいれば、式(32)および式(33)と異なる構造単位を含んでいてもよい。

20

[プロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂の具体例2-カルボニル基含有樹脂とアルキル基含有樹脂からなるプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂]

本発明における、プロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂の他の具体例として、 カルボニル基を有するカルボニル基含有樹脂、および芳香環に直接結合した炭 25 素原子数1~10のアルキル基を有するアルキル基含有樹脂からなる樹脂であ って、該カルボニル基含有樹脂または該アルキル基含有樹脂の少なくとも一方 が分子鎖内にプロトン酸基を有するものを挙げることができる。

10

このようなプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂としては、

全繰り返し構造単位に対し、前記した式と同じ下記式(6)、(18)、(20)、(24)、(28) および(32) から選ばれる少なくとも1以上に示される繰り返し構造単位(ただし、式(20)、(24)、(28) および(32) においては、 A^1 または A^2 のうち少なくとも1つが-CO-)を10~100モル%合むカルボニル基含有樹脂20~80重量%、および、全繰り返し構造単位に対し、前記した式と同じ下記式(7)、(19)、(21)、(25)、(29) 及び(33) から選ばれる少なくとも1以上に示される繰り返し構造単位(ただし、 R^6 ~ R^{10} の少なくとも1つが $-C_mH_{2m+1}$ (mは1~10の整数))を10~100モル%含むアルキル基含有樹脂20~80重量%を含んでなり、かつ X^1 ~ X^{10} の少なくとも1つがプロトン酸基であるプロトン酸基含有架橋

性芳香族樹脂を挙げることができる。

$$-HNOC \xrightarrow{\Gamma} \begin{pmatrix} A^3 & A^4 & A^4$$

מאוכרתיות אות האחמיבבבא ו ו

$$\begin{array}{c|c}
O & R^8 & R^9 & R^{10} \\
\hline
C & Ar^4 & C & R^9 & R^{10} \\
C & Ar^4 & C & R^9 & R^{10} \\
C & Ar^4 & C & R^9 & R^{10} \\
C & Ar^4 & C & R^9 & R^{10} \\
C & Ar^4 & C & R^9 & R^{10} \\
C & Ar^4 & C & R^9 & R^{10} \\
C & Ar^4 & C & R^9 & R^{10} \\
C & Ar^4 & C & R^9 & R^{10} \\
C & Ar^4 & C & R^9 & R^{10} \\
C & Ar^4 & C & R^9 & R^{10} \\
C & Ar^4 & C & R^9 & R^{10} \\
C & Ar^4 & C & R^9 & R^{10} \\
C & Ar^4 & C & R^9 & R^{10} \\
C & R^9 & R^{10} & R^{1$$

$$-c \stackrel{N}{>} Ar^{6} \stackrel{N}{>} c \stackrel{l}{\downarrow} \stackrel{R^{9}}{\searrow} A^{4} \stackrel{R^{10}}{\downarrow} \stackrel{N}{\searrow} \stackrel{N}{\downarrow} \stackrel$$

これら式 (6)、(7)、(18)、(19)、(20)、(21)、(24)、(25)、(28)、(29)、(32) および (33) 中、 $R^1 \sim R^{10}$ はそれぞれ独立して、 Hまたは $-C_mH_{2m+1}$ (mは $1\sim 10$ の整数)、 $X^1\sim X^{10}$ は、それぞれ独立して、 Hまたはプロトン酸基、Zは-NH-または-O-を表し、 $A^0\sim A^4$ は、それぞれ独立して、直接結合、 $-CH_2$ -、-C(CH_3) $_2$ -、-C(CF_3) $_2$ -、-O-、 $-SO_2$ -または-CO-、Vは、それぞれ独立して C H、NまたはC-CNであり、Ar $^3 \sim A$ r 6 は前記と同じ意味を表し、g, h, i, j, k, 1およびnは、それぞれ独立して、0または1を示す。これらの式の芳香環の水素原子は、 $-C_mH_{2m+1}$ (mは $1\sim 10$ の整数)、プロトン酸基、C1、Fまたは CF_3 に置換されていてもよい。

上記カルボニル基含有樹脂は、式(6)、(18)、(20)、(24)、(28) 25 または(32)で示されるカルボニル基を含有する繰り返し単位を10~10 0モル%含むが、カルボニル基を含有しない繰り返し単位を0~90モル%含むことができる。 上記アルキル基含有樹脂は、式 (7)、(19)、(21)、(25)、(29) または (33) で示されたアルキル基を含有する繰り返し単位を10~100モル%含むが、アルキル基を含有しない繰り返し単位を0~90モル%含むことができる。

5 カルボニル基含有樹脂とアルキル基含有樹脂は、そのいずれかがプロトン酸 基を有していればよいので、上記記載に基づいて適宜選択し、使用することが できる。

中でも、式 (6) に示される繰り返し構造単位を $10\sim100$ モル%を含むカルボニル基含有樹脂 $20\sim80$ 重量%、および、全繰り返し構造単位に対し、10 式 (7) に示される繰り返し構造単位を $10\sim100$ モル%を含むアルキル基含有樹脂 $20\sim80$ 重量%を含んでなり、 $R^6\sim R^{10}$ の少なくとも1つが一 C_mH_{2m+1} (mは $1\sim10$ の整数)であり、かつ $X^1\sim X^{10}$ の少なくとも1つがプロトン酸基であるプロトン酸基含有架橋性芳香族ポリエーテルケトンが特に好ましい。このカルボニル基含有樹脂とアルキル基含有樹脂は相溶性に優れるため、相分離のない均質な樹脂を得ることができる。

本発明のカルボニル基含有樹脂とアルキル基含有樹脂からなるプロトン酸基 含有架橋性芳香族樹脂は、カルボニル基含有樹脂20~80重量%およびアル キル基含有樹脂20~80重量%を含んでいれば、カルボニル基もアルキル基 も含有しない樹脂を含んでいてもよい。

20

25

[プロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂の具体例3]

架橋基として炭素炭素二重結合または炭素炭素三重結合を有するプロトン酸 基含有架橋性芳香族樹脂は、本発明のプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂の好 ましい態様である。このような芳香族樹脂として、芳香族ポリエーテル、芳香 族ポリアミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリアゾ ールなどを挙げることができる。中でも、未架橋時の溶剤溶解性に優れ、製膜 などの加工が容易な芳香族ポリエーテル、芳香族ポリアミドが好ましく、熱水、 酸、アルカリ水、アルコール類などによる加水分解を受けない芳香族ポリエー テルが特に好ましい。すなわち、炭素炭素二重結合または炭素炭素三重結合を 有するプロトン酸基含有架橋性芳香族ポリエーテルが特に好ましい。

本発明において、架橋基として炭素炭素二重結合または炭素炭素三重結合を 有するプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂としては、架橋基である炭素炭素二 重結合または炭素炭素三重結合を、側鎖に有するプロトン酸基含有架橋性芳香 族樹脂と、分子末端に有するプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂に大別するこ とができ、なかでも、架橋基を側鎖に有するプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂が特に好ましい。架橋基を側鎖に有するプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂 は、最大ですべての繰り返し構造単位中に架橋基を有することができるため、 高度に架橋することができる。一方、架橋基を分子末端に有するプロトン酸基 含有架橋性芳香族樹脂は、その分子量を下げ、末端基量を増やすことにより、 架橋度を制御することができる。ただし、分子量が著しく低い場合には、未架 橋時の機械強度が低下するため、未架橋の膜を得ることが難しい場合がある。

15 以下に炭素炭素二重結合または炭素炭素三重結合を有するプロトン酸基含有 架橋性芳香族樹脂の具体例を示す。

[プロトン酸基含有架橋性芳香族ポリエーテル 3]

本発明の架橋基として炭素炭素二重結合または炭素炭素三重結合を有するプロトン酸基含有架橋性芳香族ポリエーテルの例として、下記のように重合体側鎖に該架橋基を有する芳香族ポリエーテルを挙げることができる。

20

[式中、R¹¹~R¹⁵は、それぞれ独立して、H、 $-C_mH_{2m}-CH=CH-R$ または $-C_mH_{2m}-C\equiv C-R$ (mは $0\sim 10$ の整数、RはHまたはフェニル基)を表し、X¹¹~X¹⁵は、それぞれ独立して、Hまたはプロトン酸基、VはCH、C-CNまたはNを表し、A⁴およびA⁵は、それぞれ独立して、直接結合、 $-CH_2-$ 、-C(CH_3) $_2-$ 、-C(CF_3) $_2-$ 、-O-、-SO $_2-$ または-CO-を表し、k,l,nは、それぞれ独立して、0または1をす。式(34)中の芳香環の水素原子は、 $-C_mH_{2m}-CH=CH-R$ 、 $-C_mH_{2m}-C\equiv C-R$ (mは $0\sim 10$ の整数、RはHまたはフェニル基)、プロトン酸基、C1、Fまたは CF_3 に置換されていてもよい。]

15 本発明の芳香族ポリエーテルとして好ましい樹脂は、 A^4 が-CO-であるポリエーテルケトンまたはポリエーテルエーテルケトン、 A^4 が $-SO_2$ ーであるポリエーテルスルホンまたはポリスルホン、 A^4 が-O-であるポリフェニレンオキシドなどである。

芳香族ポリエーテルは、繰り返し構造単位を構成するモノマーを重縮合させ 20 て得ることができる。例えば、芳香族ポリエーテルは、芳香族ジヒドロキシ化合物と、芳香族ジハライド化合物とを重縮合させることにより得ることができる。その際上記した $-C_mH_{2m}-CH=CH-R$ または $-C_mH_{2m}-C\equiv C-R$ 基を側鎖に有する化合物を使用することにより、 $-C_mH_{2m}-CH=CH-R$ または $-C_mH_{2m}-C\equiv C-R$ 基を側鎖に有する芳香族ポリエーテルを得る ことができる。

[プロトン酸基含有架橋性芳香族ポリエーテル 4]

本発明の架橋基として炭素炭素二重結合または炭素炭素三重結合を有するプ

ロトン酸基含有架橋性芳香族ポリエーテルの他の例として、下記のように分子 末端に該架橋基を有する芳香族ポリエーテルを挙げることができる。

全繰り返し構造単位に対し、式(35)に示される繰り返し構造単位20~100モル%を含み、

5 $X^{16} \sim X^{20}$ の少なくとも1つがプロトン酸基であり、かつその分子末端が $R^a - CH = CH - R^b$ または $-R^a - C \equiv C - R^b$ (R^a はフェニレン基、 R^b はHまたはフェニル基を示す)であるプロトン酸基含有架橋性芳香族ポリエーテル。

[式中、 X^{16} ~ X^{20} はそれぞれ独立して、Hまたはプロトン酸基、VはCH, C-CNまたはNを表し、 A^6 および A^7 は、それぞれ独立して、直接結合、 15 $-CH_2-、-C(CH_3)_2-、-C(CF_3)_2-、-O-、-SO_2-または-CO-を表し、<math>k$, 1 , n は、それぞれ独立して、0 または 1 を示す。式 (35) の芳香環の水素原子は、プロトン酸基、C1、F または CF_3 に置換されていてもよい。]

芳香族ポリエーテルは、繰り返し構造単位を構成するモノマーを重縮合させ 20 て得ることができる。例えば、芳香族ポリエーテルは、芳香族ジヒドロキシ化 合物と、芳香族ジハライド化合物とを重縮合させることにより得ることができ る。その際、 $Q-R^a-CH=CH-R^b$ または $Q-R^a-C\equiv C-R^b$ (Qは、 OH, ハロゲン、ニトロ基など重縮合モノマーと反応し得る基、 R^a はフェニ レン基、 R^b はHまたはフェニル基を示す)を、末端封止剤として存在させる ことにより、 $-R^a-CH=CH-R^b$ または $-R^a-C\equiv C-R^b$ 基を分子末 端に有する芳香族ポリエーテルを得ることができる。

[プロトン酸基含有架橋性芳香族ポリアミド 2]

本発明の架橋基として炭素炭素二重結合または炭素炭素三重結合を有するプロトン酸基含有架橋性芳香族ポリアミドの例として、下記のように分子末端に 該架橋基を有する芳香族ポリアミドを挙げることができる。

5 全繰り返し構造単位に対し、式(36)に示される繰り返し構造単位20~ 100モル%を含み、

 $X^{16} \sim X^{20}$ の少なくとも1つがプロトン酸基であり、かつその分子末端が-R*-CH=CH-Rb、-R*-C≡C-Rb(以上R*はフェニレン基、RbはHまたはフェニル基を示す)、または下記式(5)

$$10 \qquad -NHCO-Ar^2 \qquad (5)$$

で示される基であるプロトン酸基含有架橋性芳香族ポリアミド。

$$-HNOC \xrightarrow{[!]{}} (A^{1} \xrightarrow{[!]{}} CONH \xrightarrow{[!]{}} (A^{2} \xrightarrow{[!]{}} A^{2} \xrightarrow{[!]{}} (X^{19} \times X^{20})$$

$$\times X^{16} \times X^{17} \times X^{18} \times X^{19} \times X^{20} \times X$$

15

20

[式 (36) 中、 X^{16} ~ X^{20} はそれぞれ独立して、Hまたはプロトン酸基を表し、 A^1 および A^2 は、それぞれ独立して、直接結合、 $-CH_2-$ 、-C(CH_3) $_2-$ 、-C(CF_3) $_2-$ 、-O-、 $_2-$ または $_3$ 0の方を表し、 $_3$ 1、 $_3$ 1、 $_3$ 2、 $_3$ 2、 $_3$ 3、 $_3$ 4、 $_3$ 4、 $_3$ 5、 $_3$ 6 の方を環の水素原子は、プロトン酸基、 $_3$ 6、 $_3$ 7 に置換されていてもよい。] [式 (5) 中、 $_3$ 7 は、

$$- \bigcap_{\mathbf{R}}^{\mathbf{R}'} - \bigcap_{\mathbf{R}}^{\mathbf{R}'} \quad \text{sta} \quad \boxed{ } = \mathbf{R}$$

を表し、R、R'は同一でも異なっていてもよく、水素、メチル基、エチル基 25 またはフェニル基を表す。] 芳香族ポリアミドは、芳香族ジアミノ化合物と、芳香族ジカルボン酸または 芳香族ジカルボン酸クロリドとを重縮合させることにより得ることができる。 その際、 $Q-R^a-CH=CH-R^b$ 、 $Q-R^a-C\equiv C-R^b$ 、

で示される化合物(Qは、NH,カルボン酸、カルボン酸クロリドなど重縮合モノマーと反応し得る基、R^aはフェニレン基、R^bはHまたはフェニル基、

10 R、R'は、水素、メチル基、エチル基またはフェニル基を示す)を、末端封 止剤として存在させることにより、分子末端に前記架橋基を有する芳香族ポリ アミドを得ることができる。

[プロトン酸基含有架橋性芳香族ポリイミド 2]

本発明の架橋基として炭素炭素二重結合または炭素炭素三重結合を有するプ 15 ロトン酸基含有架橋性芳香族ポリイミドの例として、下記のように分子末端に 該架橋基を有する芳香族ポリイミドを挙げることができる。

全繰り返し構造単位に対し、式(37)に示される繰り返し構造単位20~100モル%を含み、

 $X^{16} \sim X^{18}$ の少なくとも1つがプロトン酸基であり、かつその分子末端が-20 $R^a - CH = CH - R^b$ 、 $-R^a - C = C - R^b$ (R^a はフェニレン基、 R^b はHまたはフェニル基を示す)または下記式(4)で示される基であるプロトン酸基含有架橋性芳香族ポリイミド。

$$--N \longrightarrow Ar^1$$
 (4)

[式 (4) 中、A r ¹ は、

3NSDOCID: <WO____03033566A1_I_>

を表し、R、R'は同一でも異なっていてもよく、水素、メチル基、エチル基 またはフェニル基を表す。]

[式中、 $X^{16} \sim X^{18}$ はそれぞれ独立して、Hまたはプロトン酸基を表し、 A^1 は、それぞれ独立して、直接結合、 $-CH_2-$ 、-C(CH_3) $_2-$ 、-C(CH_3) $_2-$ 、-C(CH_3) $_2-$ 、-C0 なたは1を示し、 A^{18} は、 A^{18

15 を表し、 A^3 は、直接結合、 $-CH_2-$ 、-C(CH_3) $_2-$ 、-C(CF_3) $_2$ $-、-O-、-SO_2-または-CO-を表す。式(37)の芳香環の水素原子は、プロトン酸基、<math>C1$ 、Fまたは CF_3 に置換されていてもよい。]

芳香族ポリイミドは、芳香族ジアミンと芳香族テトラカルボン酸二無水物とを有機溶媒中で反応させ、前駆体のポリアミド酸とした後、熱イミド化または化学イミド化することにより得ることができる。その際、 $Q-R^*-CH=CH-R^*$ 、 $Q-R^*-C\equiv C-R^*$ (Qは、 NH_2 , カルボン酸、カルボン酸クロリドなどモノマーと反応し得る基、 R^* はフェニレン基、 R^* はHまたはフェニル基を示す)、または、下記式 (38)で表されるジカルボン酸無水物を、

末端封止剤として存在させることにより、分子末端に前記架橋基を有する芳香 族ポリイミドを得ることができる。

$$\begin{array}{c}
\mathbf{O} \\
\mathbf{O} \\
\mathbf{O}
\end{array}$$
(38)

[式 (38) 中、Ar¹ は、

5

を表し、R、R'は同一でも異なっていてもよく、水素、メチル基、エチル基 またはフェニル基を表す。]

[プロトン酸基含有架橋性芳香族ポリアミドイミド 2]

10 本発明の架橋基として炭素炭素二重結合または炭素炭素三重結合を有するプロトン酸基含有架橋性芳香族ポリアミドイミドの例として、下記のように分子末端に該架橋基を有する芳香族ポリアミドイミドを挙げることができる。

全繰り返し構造単位に対し、式(39)に示される繰り返し構造単位20~100モル%を含み、

15 $X^{16} \sim X^{19}$ の少なくとも1つがプロトン酸基であり、かつその分子末端がー $R^a - CH = CH - R^b$ 、 $-R^a - C \equiv C - R^b$ (R^a はフェニレン基、 R^b はHまたはフェニル基を示す)、式(4)または式(5)で表される基であるプロトン酸基含有架橋性芳香族ポリアミドイミド。

[式 (4) 中、A r 1 は、前記と同じ意味を表す。]

BNSDOCID: <WO_____03033566A1_I_>

15

46

$$-NHCO-Ar^{2}$$
 (5)

[式 (5) 中、 Ar^2 は、前記と同じ意味を表す。]

$$\begin{array}{c|c}
 & O \\
 & C \\$$

[式中、 X^{16} ~ X^{20} はそれぞれ独立して、Hまたはプロトン酸基を表し、 A^{1} および A^{2} は、それぞれ独立して、直接結合、 $-CH_{2}-$ 、-C(CH_{3}) $_{2}-$ 、-C(CF_{3}) $_{2}-$ 、-C(CF_{3}) $_{2}-$ 、-C(CF_{3}) $_{2}-$ 、-C0、 $-SO_{2}-$ または-CO-を表し、k, l, nは、-C1 でれぞれ独立して、-C2 で表し、式(-C3 の方香環の水素原子は、プロトン酸基、-C3 で表には-C4 である。

芳香族ポリアミドイミドは、芳香族ジアミンと、芳香族トリカルボン酸モノクロリドとを有機溶媒中で反応させ、前駆体のポリアミド酸とした後、熱イミド化または化学イミド化することにより得ることができる。その際、 $Q-R^*$ - $CH=CH-R^b$ 、 $Q-R^*-C\equiv C-R^b$ 、

で示される化合物(Qは、 NH_2 , カルボン酸、カルボン酸クロリドなど重縮 20 合モノマーと反応し得る基、 R^a はフェニレン基、 R^b はHまたはフェニル基、 R、R、は、水素、メチル基、エチル基またはフェニル基を示す)、または、 下記式(38)で表されるジカルボン酸無水物を末端封止剤として存在させる ことにより、分子末端に前記架橋基を有する芳香族ポリアミドイミドを得ることができる。

$$\begin{array}{c}
\mathbf{O} \\
\mathbf{O} \\
\mathbf{O}
\end{array}$$
(38)

[式 (38) 中、Ar¹ は、前記と同じ意味を表す。] [プロトン酸基含有架橋性芳香族ポリアゾール 2]

本発明の架橋基として炭素炭素二重結合または炭素炭素三重結合を有するプロトン酸基含有架橋性芳香族ポリアゾールの例として、下記のように分子末端 に該架橋基を有する芳香族ポリアゾールを挙げることができる。

全繰り返し構造単位に対し、式(40)に示される繰り返し構造単位20~ 100モル%を含み、

 $X^{16} \sim X^{18}$ の少なくとも1つがプロトン酸基であり、かつその分子末端が $R^a - CH = CH - R^b$ または $-R^a - C \equiv C - R^b$ (R^a はフェニレン基、 R^b 10 はHまたはフェニル基を示す)であるプロトン酸基含有架橋性芳香族ポリアゾール。

$$- c \stackrel{N}{\underset{Z}{\nearrow}} Ar^{5} \stackrel{N}{\underset{Z}{\nearrow}} C \stackrel{U}{\underset{X^{16}}{\longrightarrow}} \left\{ A^{1} \stackrel{U}{\underset{X^{17}}{\longrightarrow}} A^{1} \stackrel{U}{\underset{X^{18}}{\longrightarrow}} \right\}_{1}$$

$$(40)$$

15

[式中、 X^{16} ~ X^{18} はそれぞれ独立して、Hまたはプロトン酸基、Zは-NH-または-O-を表し、Ar⁵は、

20 を表し、 A^1 および A^3 は、それぞれ独立して、直接結合、 $-CH_2-$ 、-C(CH_3) $_2-$ 、-C(CF_3) $_2-$ 、-O-、 $_2-$ または-CO-を表し、 $_3$ は、それぞれ独立して、 $_3$ のまたは $_3$ を示し、式($_4$ の)の芳香環の水素原子は、プロトン酸基、 $_3$ に置換されていてもよい。]

-Z-が-NH-であるポリベンゾイミダゾールは、芳香族テトラアミンと 25 芳香族ジカルボン酸エステルを公知の方法で反応させることにより得ることが できる。また、Zが-O-であるポリベンゾオキサゾールは、ジアミノジヒド ロキシ化合物と、芳香族ジカルボン酸を、公知の方法で反応させすることによ

り得ることができる。その際、Q-R°-CH=CH-R°、Q-R°-C≡C-R°、

で示される化合物(Qは、NH,カルボン酸、カルボン酸クロリド、カルボン酸エステルなど重縮合モノマーと反応し得る基、R^aはフェニレン基、R^bはHまたはフェニル基、R、Rⁱは、水素、メチル基、エチル基またはフェニル基を示す)を末端封止剤として存在させることにより、分子末端に前記架橋基を有する芳香族ポリアゾールを得ることができる。

[芳香族樹脂の製造方法の例]

5

10

15

20

本発明の芳香族樹脂を製造する方法の一例としては、前記したようなモノマー、末端封止剤を重縮合させる方法が挙げられる。ここで、重縮合の条件としては、従来公知の方法に基づいて適宜選択することができる。これらの条件の選択にあたっては、例えば、「新高分子実験学3 高分子の合成・反応(2)」155~175頁[共立出版(1996年)]、「実験化学講座28 高分子化学」326~332頁[丸善株式会社(1992年)]、「新実験化学講座19 高分子化学(I)」137~138頁[丸善株式会社(1978年)] などに記載の方法を参照することができる。

得られた芳香族樹脂は、水、塩酸水、有機溶剤などを用いて精製することにより、未反応モノマー、オリゴマー、酸や塩を除去することができる。

[モノマー類の具体例]

前記した本発明のプロトン髪俺酸基含香族樹脂を重縮合により製造する際に 25 使用することのできるモノマー類および末端封止剤の具体例を以下に示す。

[芳香族ジヒドロキシ化合物の具体例]

前記した本発明のプロトン酸基含有芳香族樹脂を 縮合により製造する際に

使用することのできる芳香族ジヒドロキシ化合物の具体例を示す。 `

芳香族ジヒドロキシ化合物として、ハイドロキノン、レゾルシン、カテコール、4, 4'ージヒドロキシビフェニル、4, 4'ージヒドロキシジフェニルスルフィド、4, 4'ージヒドロキシジフェニルメタン、4, 4'ージヒドロキシジフェニルスルホン、4, 4'ージヒドロキシベングフェノン、2, 2ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロパン、1, 1, 1, 3, 3, 3ーへキサフルオロー2, 2ービス(4ーヒドロキシフェニル)ベンゼン、α, α'ービス(4ーヒドロキシフェニル)ー1, 4ージメチルベンゼン、α, α'ービス(4ーヒドロキシフェニル)ー1, 4ージイソプロピルベンゼン、α, α'ービス(4ーヒドロキシフェニル)ー1, 3ージイソプロピルベンゼン、α, α'ービス(4ーヒドロキシフェニル)ー1, 3ージイソプロピルベンゼン、1, 4ービス(4ーヒドロキシベンゾイル)ベンゼン、3, 3ージフルオロー4, 4'ージヒドロキビフェニル、9, 9ービス(4ーヒドロキシフェニル)フルオレンなどを挙げることができる。

アルキル基含有芳香族ジヒドロキシ化合物として、2ーメチルハイドロキノ 15 ン、2-エチルハイドロキノン、2-イソプロピルハイドロキノン、2-オク チルハイドロキノン、2、3ージメチルハイドロキノン、2、3ージエチルハ イドロキノン、2,5-ジメチルハイドロキノン、2,5-ジエチルハイドロ キノン、2、5-ジイソプロピルハイドロキノン、2、6-ジメチルハイドロ キノン、2,3,5ートリメチルハイドロキノン、2,3,5,6ーテトラメ 20 チルハイドロキノン、3, 3'ージメチルー4, 4'ージヒドロキシビフェニ ル、3,3',5,5'ーテトラメチルー4,4'ージヒドロキシビフェニル、 3. 3'ージメチルー4. 4'ージヒドロキシジフェニルメタン、3, 3', 5, 5, -テトラメチルー4, 4, -ジヒドロキシジフェニルメタン、3, 3, 5、5'ーテトラエチルー4、4'ージヒドロキシジフェニルメタン、3、3' 25 ージメチルー4,4'ージヒドロキシジフェニルエーテル、3,3',5,5' ーテトラメチルー4,4'ージヒドロキシジフェニルエーテル、3,3'ージ

WO 03/033566 PCT/JP02/10536

架橋基含有芳香族ジヒドロキシ化合物としては、2ーアリルハイドロキノン、 15 4,4'-ジヒドロキシー3,3'-ジアリルビフェニル、ビス (4ーヒドロ キシー3ーアリルフェニル)メタン、2,2ービス (4ーヒドロキシー3ーア リルフェニル)プロパンなどを挙げることができる。

20

25

プロトン酸基含有ジヒドロキシ化合物としては、前記芳香族ジヒドロキシ化合物およびアルキル基含有芳香族ジヒドロキシ化合物のスルホン化物、アルキルスルホン化物などを挙げることができる。なお、スルホン化物およびアルキルスルホン化物はNa、Kなどのアルカリ金属の塩も含む。スルホン化物は芳香族ジヒドロキシ化合物を、濃硫酸などの公知のスルホン化剤でスルホン化する(Macromol. Rapid. Commun., 19, 135(1998))、などの方法により得ることができる。アルキルスルホン化物は芳香族ジヒドロキシ化合物を、ホルムアルデヒドおよび亜硫酸と反応させる(J. Amer. Chem. Soc., 92, 861(1970))、などの方法により得ることができる。

プロトン酸基含有芳香族ジヒドロキシ化合物としては、前記の芳香族ジヒド

ロキシ化合物のスルホン化物およびアルキルスルホン化物のほかに、2,5-ジヒドロキシ安息香酸、2,5-ジヒドロキシテレフタル酸、5,5'-メチレンジサリチル酸、5,5'-チオジサリチル酸などのカルボン酸基を有する芳香族ジヒドロキキシ化合物およびそのアルカリ金属塩や2,5-ジヒドロキシフェニルホスホン酸などのリン酸基を有する芳香族ジヒドロキシ化合物およびそのアルカリ金属塩も挙げられる。

[芳香族ジハライド化合物の具体例]

前記した本発明のプロトン酸基含有芳香族樹脂を重縮合により製造する際に 使用することのできる芳香族ジハライド化合物の具体例を示す。

- 芳香族ジハライド化合物として、4,4'ージフルオロベンゾフェノン、3,3'ージフルオロベンゾフェノン、4,4'ージクロロベンゾフェノン、3,3'ージクロロベンゾフェノン、4,4'ージフルオロジフェニルスルホン、4,4'ージクロロジフェニルスルホン、1,4ージフルオロベンゼン、1,3ージフルオロベンゼン、4,4'ージフルオロビフェニル、3,3'ージブロモー4,4'ージフルオロビフェニル、4,4'ージフルオロジフェニルメタン、4,4'ージフルオロジフェニルメタン、4,4'ージフルオロジフェニルメタン、4,4'ージフルオロジフェニルエーテル、2,2ービス(4ーフルオロフェニル)プロパン、2,2ービス(4ークロロフェニル)プロパン、α,α'ービス(4ーフルオロフェニル)ー1,4ージイソプロピルベンゼン、2,5ージフルオロベンゾフェノン、2,5ージクロロー4ーピリジルフェニルケトン、2,5ージフルオロベンゾニトリルなどを挙げることができる。
- アルキル基含有芳香族ジハライド化合物として、3,3'ージメチルー4,4'ージフルオロベングフェノン、3,3'ージエチルー4,4'ージフルオロベングフェノン、3,5'ーテトラメチルー4,4'ージフルオロベングフェノン、3,3',5,5'ージメチルー4,4'ージクロロベングフェノン、3,3',4,4'ーテトラメチルー5,5'ージクロロベングフェノン、3,3'ージメチルー4,4'ージフルオロジフェニルスルホン、3,3'ージメ

チルー4, 4'ージクロロジフェニルスルホン、2, 5ージフルオロトルエン、2, 5ージフルオロエチルベンゼン、2, 5ージフルオローpーキシレンなどを挙げることができる。

プロトン酸基含有ジヒドロキシ化合物としては、前記芳香族ジヒドロキシ化合物およびアルキル基含有芳香族ジヒドロキシ化合物のスルホン化物、アルキルスルホン化物などを挙げることができる。スルホン酸基含有芳香族ジハライド化合物は前記芳香族ジハライド化合物またはアルキル基含有ジハライド化合物を、発煙硫酸などの公知のスルホン化剤でスルホン化(Macromol. Chem. Phys., 199, 1421(1998))する、などの方法により得ることができる。なお、スルホン化物およびアルキルスルホン化物はNa、Kなどのアルカリ金属の塩も含む。

プロトン酸基含有芳香族ジハライド化合物としては、前記の芳香族ジハライド化合物のスルホン化物およびアルキルスルホン化物のほかに、2,5ージクロロ安息香酸、2,5ージフルオロ安息香酸、5,5'ーカルボニルビス(2ーフルオロ安息香酸)、5,5'ースルホニルビス(2ーフルオロ安息香酸)などのカルボン酸基を有する芳香族ジハライド化合物およびそのアルカリ金属塩や2,5ージクロロフェニルホスホン酸、5,5'ーカルボニルビス(2ーフルオロベンゼンホスホン酸)などのリン酸基を有する芳香族ジハライド化合物およびそのアルカリ金属塩も挙げられる。

20 [芳香族ジアミン化合物の具体例]

5

10

前記した本発明のプロトン酸基含有芳香族樹脂を重縮合により製造する際に使用することのできる芳香族ジアミンの具体例としては、1,4ージアミノベンゼン、4,4'ージアミノビフェニル、4,4'ージアミノジフェニルエーテル、4,4'ージアミノジフェニルメタン、4,4'ージアミノジフェニル プロパン、4,4'ージアミノジフェニルスルホン、4,4'ージアミノジフェニルスルフィド、9,9ービス(4ーアミノフェニル)フルオレン、1,4ービス(4ーアミノフェノキシ)ベンゼン、4,4'ージアミノベンゾフェ

ノン、3,3'ージアミノベングフェノン、3,5ージアミノベンゾフェノン、2ーメチルー1,4ージアミノベンゼン、2,5ージメチルー1,4ージアミノベンゼン、3,3'ージメチルー4,4'ージアミノビフェニル、3,3'ージメチルー4,4'ージアミノジフェニルエーテル、2,2'ージメチルー4,4'ージアミノジフェニルメタン、2,2'ージメチルー4,4'ージアミノジフェニルプロパン、2,2'ージメチルー4,4'ージアミノジフェニルスルホン、3,3',5,5'ーテトラメチルー4,4'ージアミノジフェニルスルホンなどが挙げられる。

10 プロトン酸基含有芳香族ジアミンとしては、前記芳香族ジアミンのスルホン化物、アルキルスルホン化物などを挙げることができる。なお、スルホン化物およびアルキルスルホン化物はNa、Kなどのアルカリ金属の塩も含む。スルホン酸基を有する芳香族ジアミンは前記の芳香族ジアミンを、発煙硫酸などの公知のスルホン化剤でスルホン化する (Macromolecules, 35, 6707(2002))、などの方法により得ることができる。

プロトン酸基含有芳香族ジアミンとしては、前記の芳香族ジアミンのスルホン化物およびアルキルスルホン化物のほかに、3,5ージアミノ安息香酸などのカルボン酸基を有する芳香族ジヒドロキキシ化合物およびそのアルカリ金属塩や3,5ージアミノフェニルホスホン酸などのリン酸基を有する芳香族ジヒドロキシ化合物およびそのアルカリ金属塩も挙げられる。

[芳香族ジカルボン酸クロリドの具体例]

前記した本発明のプロトン酸基含有芳香族樹脂を重縮合により製造する際に使用することのできる芳香族ジカルボン酸クロリドの具体例としては、テレフタル酸クロリド、イソフタル酸クロリド、3,3'ービフェニルジカルボン酸クロリド、3,3'ージフェニルエーテルジカルボン酸クロリド、3,3'ージフェニルスルフィドジカルボン酸クロリド、3,3'ージフェニルスルホンジカルボン酸クロリド、3,3'ージフェニルメタンジカルボン酸クロリド、3,3'ージフェニルメタンジカルボン酸クロリド、3,3'ージフェニルメタンジカルボン酸クロリド、3,3'ージフェニルメタンジカルボン酸クロリド、

20

PCT/JP02/10536

2-メチル-1, 4-ベンゼンジカルボン酸クロリド、5-メチル-1, 3-ベンゼンジカルボン酸クロリド、2, 5-ジメチル-1, 4-ベンゼンジカルボン酸クロリド、4, 6-ジメチル-1, 3-ベンゼンジカルボン酸クロリド、3, 3'-ジメチル-4, 4'-ビフェニルジカルボン酸クロリド、2, 2'-ジメチル-4, 4'-ビフェニルジカルボン酸クロリド、3, 3', 5, 5'-テトラメチル-4, 4'-ビフェニルジカルボン酸クロリドなどが挙げられる。

[芳香族テトラカルボン酸二無水物の具体例]

前記した本発明のプロトン酸基含有芳香族樹脂を重縮合により製造する際に 使用することのできる芳香族テトラカルボン酸二無水物の具体例としては、ピ 10 ロメリット酸二無水物、3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無 水物、2,2',3,3'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)エーテル二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシ フェニル)スルフィド二無水物、ビス(3,4ージカルボキシフェニル)スル ホン二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)メタン二無水物、ビス 15 (3, 4-ジカルボキシフェニル) プロパン二無水物、1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロ-2, 2-ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)プロパ ン二無水物、1,4,5,8ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、3,3 ', 4, 4'ーベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、3ーメチルー1, 2, 4, 5-ベンゼンテトラカルボン酸二無水物、ビス(5-メチルー3, 4-ジ 20 カルボキシフェニル)エーテル二無水物、ビス(5-メチル-3,4-ジカル ボキシフェニル)スルホン二無水物、ビス(5-メチル-3,4-ジカルボキ シフェニル) メタン二無水物、2,3,6,7ーテトラメチルー1,4,5, 8-ナフタレンテトラカルボン酸二無水物などが挙げられる。

25 [芳香族トリカルボン酸モノクロリドの具体例]

前記した本発明のプロトン酸基含有芳香族樹脂を重縮合により製造する際に 使用することのできる芳香族トリカルボン酸モノクロリドとしては、1,2, 4ーベンゼントリメリット酸クロリド無水物、3', 4, 4'ービフェニルトリカルボン酸モノクロリド無水物、3', 4, 4'ージフェニルメタントリカルボン酸クロリド無水物、3', 4, 4'ージフェニルイソプロパントリカルボン酸クロリド無水物、5ーメチルー1, 2, 4ーベンゼントリカルボン酸モノクロリド無水物、3ーメチルー3', 4, 4'ービフェニルトリカルボン酸モノクロリド無水物、3ーメチルー3', 4, 4'ービフェニルメタントリカルボン酸クロリド無水物、3ーメチルー3', 4, 4'ージフェニルメタントリカルボン酸クロリド無水物、3ーメチルー3', 4, 4'ージフェニルスルホントリカルボン酸クロリド無水物、3, 4, 4'ーベンゾフェノントリカルボン酸モノクロリド無水物、などが挙げられる。

10 [芳香族テトラアミンの具体例]

5

15

20

前記した本発明のプロトン酸基含有芳香族樹脂を重縮合により製造する際に使用することのできる芳香族テトラアミンの具体例としては、1, 2, 4, 5 ーテトラアミノベンゼン、3, 3, 4, 4, 4 ーテトラアミノジフェニルエーテル、3, 3, 4, 4 ・ 4

プロトン酸基含有芳香族テトラアミンは、前記芳香族テトラアミンのスルホン化物などを挙げることができる。なお、芳香族テトラアミンスルホン化物はNa、Kなどのアルカリ金属の塩も含む。芳香族テトラアミンスルホン化物は前記の芳香族テトラアミンを、発煙硫酸などの公知のスルホン化剤でスルホン化する、などの方法により得ることができる。

[芳香族ジカルボン酸の具体例]

芳香族ジカルボン酸の具体例として、テレフタル酸、テトラクロロテレフタル酸、イソフタル酸、4,4'-ジカルボキシビフェニル、4,4'-ジカルボキシジフェニルエーテル、4,4'-ジカルボキシジフェニルスルホン、25 4,4'-ジカルボキシベンゾフェノン、ビス(4-カルボキシフェニル)メタン、2,2-ビス(4-カルボキシフェニル)プロパン、ヘキサフルオロ-2,2-ビス(4-カルボキシフェニル)プロパン、2-メチル-1,

WO 03/033566 PCT/JP02/10536

56

4-ベンゼンジカルボン酸、5-メチルー1, 3-ベンゼンジカルボン酸、2, 5-ジメチルー1, 4-ベンゼンジカルボン酸、3, 3, -ジメチルー4, 4, 4, -ビフェニルジカルボン酸などが挙げられる。

プロトン酸基含有芳香族ジカルボン酸としては、2,5ージカルボキシベンゼンスルホン酸、3,5ージカルボキシベンゼンスルホン酸などのスルホン酸基含有芳香族ジカルボン酸、2,5ージカルボキシフェニルホスホン酸などのリン酸基酸基含有芳香族ジカルボン酸およびそのアルカリ金属塩が挙げられる。[芳香族ジカルボン酸エステルの具体例]

5

前記した本発明のプロトン酸基含有芳香族樹脂を重縮合により製造する際に 使用することのできる芳香族ジカルボン酸エステルの具体例としては、テレフタル酸ジフェニル、イソフタル酸ジフェニル、4,4'ージフェニルエーテルジカルボン酸ジフェニル、4,4'ージフェニルスルホンジカルボン酸ジフェニル、4,4'ーベンゾフェノンジカルボン酸ジフェニル、2ーメチルー1,4ーベンゼンジカルボン酸ジフェニル、5ーメチルー1,3ーベンゼンジカルボン酸ジフェニル、5ーメチルー1,3ーベンゼンジカルボン酸ジフェニル、3,3'ージメチルー4,4'ービフェニルジカルボン酸ジフェニル、3,3'ージメチルー4,4'ージフェニルエーテルジカルボン酸ジフェニル、2,2'ージメチルー4,4'ージフェニルスルホンジカルボン酸ジフェニル[芳香族ジアミノジヒドロキシ化合物の具体例]

20 芳香族ジアミノジヒドロキシ化合物の具体例としては、2,5ージアミノー 1,4ージヒドロキシベンゼン、4,6ージアミノー1,3―ジヒドロキシベン ゼン、3,3'ージアミノー4,4'ージヒドロキシビフェニル、4,4'ージ アミノー3,3'ージヒドロキシビフェニルなどが挙げられる。

プロトン酸基含有芳香族ジアミノジヒドロキシ化合物は、前記芳香族ジアミ 25 ノジヒドロキシのスルホン化物などを挙げることができる。なお、スルホン化 物はNa、Kなどのアルカリ金属の塩も含む。スルホン酸基を有する芳香族ジアミノジヒドロキシは前記の芳香族ジアミノジヒドロキシ化合物を、発煙硫酸

などの公知のスルホン化剤でスルホン化する方法などにより得ることができる。 [架橋基含有末端封止剤の具体例]

前記架橋基含有末端封止剤のとしては、例えば、モノハライド化合物、モノヒドロキシ化合物、モノアミン化合物、モノカルボン酸クロリド化合物、モノカルボン酸エステル化合物、ジカルボン酸無水物化合物などが挙げられる。

モノハライド化合物の具体例としては、3-フルオロプロペン、3-フルオロー1-プロピン、4-フルオロー1-ブテン、4-フルオロー1-ブチン、3-フルオロシクロヘキセン、3-フルオロスチレン、4-フルオロエチニルベンゼン、α-フルオロー4-エチニルトルエン、4-フルオロスチルベン、

- 10 4- (フェニルエチニル) フルオロベンゼン、3- (フェニルエチニル) フルオロベンゼン、4-フルオロー4' -フェニルエチニルーベンゾフェノン、4-フルオロー4' -フェニルエチニルジフェニルスルホン、4-クロロー1-ブテン、4-クロロー1-ブチン、3-クロロシクロヘキセン、4-クロロスチレン、3-クロロスチレン、3-クロロエチニルベンゼン、3- (フェニル15 エチニル) クロロベンゼン、4-クロロー4'- (フェニルエチニル) ベンゾ
- モノヒドロキシ化合物の具体例としては、3-ヒドロキシー1-プロピン、 4-ヒドロキシー1-ブテン、4-ヒドロキシー1-ブチン、4-ヒドロキシ スチレン、3-ヒドロキシスチレン、2-アリルフェノール、4-ヒドロキシ 20 エチニルベンゼン、3-エチニルフェノール、4-ヒドロキシスチルベン、4 - (フェニルエチニル) フェノール、3- (フェニルエチニル) フェノール、 4-ヒドロキシー4' -フェニルエチニルベンゾフェノン、4-ヒドロキシー

フェノンなどが挙げられる。

- 4' ーフェニルエチニルージフェニルスルホン、4ーフェニルエチニルフタル イミドフェノールなどが挙げられる。
- 25 モノカルボン酸クロリド化合物の具体例としては、4ーカルボキシー1ーシ クロヘキセンクロリド、1ーメチルー4ーカルボキシー1ーシクロヘキセンク ロリド、2ーカルボキシー5ーノルボルネンクロリド、5ーメチルー2ーカル

ボキシー5ーノルボルネンクロリド、4ーエチニル安息香酸クロリド、4ーフェニルエチニル安息香酸クロリド、3ービニル安息香酸クロリド、4ーカルボキシスチルベンクロリドなどが挙げられる。

モノアミン化合物の具体例としては、3-エチニルアニリン、3-ビニルア 5 ニリンなどが挙げられる。

エステル化合物の具体例としては、4-(カルボキシフェニル)-1-シクロヘキセン、1-メチル-4-(カルボキシフェニル)-1-シクロヘキセン、2-(カルボキシフェニル)-5-ノルボルネン、5-メチル-2-(カルボキシフェニル)-5-ノルボルネン、2-エチニル安息香酸フェニル、3-エキシフェニル)-5-ノルボルネン、2-エチニル安息香酸フェニル、3-エチニル安息香酸フェニル、4-エチニル安息香酸フェニル、3-(フェニルエチニル)安息香酸フェニル、4-(フェニルエチニル)安息香酸フェニル、3-ビニル安息香酸フェニル、4-(カルボキシフェニル)スチルベンなどが挙げられる。

架橋基含有ジカルボン酸無水物の具体例としては、マレイン酸無水物、2-15 メチルマレイン酸無水物、2ーフルオロマレイン酸無水物、2,3ージメチルマレイン酸無水物、エチルマレイン酸無水物、2ーフェニルマレイン酸無水物、5ーノルボルネンー2,3ージカルボン酸無水物、5ーメチルー2,3ージカルボキシー5ーノルボルネン無水物、5,6ージメチルー2,3ージカルボキシー5ーノルボルネン無水物、シスー1,2,3,4ーテトラヒドロフタル酸無水物、3ーメチルーシスー1,2,3,6ーテトラヒドロフタル酸無水物、4,5ージメチルーシスー1,2,3,6ーテトラヒドロフタル酸無水物、1ーフェニルー2ー(3,4ージカルボキシフェニル)アセチレン無水物、3ーエチニルフタル酸無水物、3ービニルフタル酸無水物などが挙げられる。

25 [芳香族樹脂へのプロトン酸基導入方法の例]

本発明の芳香族樹脂のうち、プロトン酸基を有する芳香族樹脂は、プロトン 酸基を含有するモノマーを用いる縮合重合反応により得る方法のほか、プロト ン酸基を有さない芳香族樹脂に、プロトン酸基を導入する方法により得ることもできる。ここで、芳香族樹脂にプロトン酸基を導入する方法としては、スルホン化やアルキルスルホン化など公知の方法を適宜選択使用することができる。

具体例として、樹脂をスルホン化する方法としては、公知のスルホン化剤、 例えば濃硫酸 (特開昭57-25328号公報)、発煙硫酸 (特表平11-50245号公報)、クロロスルホン酸 (Journal of Applied Polymer Science, 70,477 (1998))、メタンスルホン酸 (Macromolecules, 276267 (1994))) などによりスルホン化する方法が挙げられる。樹脂をアルキルスルホン化する方法としては、サルトン化合物を用いる方法 (J. Amer. Chem. Soc.,76, 105357(1954))、樹脂の芳香族環の水素をリチウムに置換し、次いでジハロゲノアルカンでハロゲノアルキル基に代え、スルホアルキル基に変換する方法やテトラメチレンハロゲニウムイオンを用いてハロゲノブチル基を導入し、次いでハロゲンをスルホン酸基に変換する方法などが挙げられる。

得られたプロトン酸基含有芳香族樹脂は、水、塩酸水、有機溶剤などを用いて精製することにより、酸や塩を除去することができる。

前記した本発明のプロトン酸基含有芳香族樹脂を得るために使用できる樹脂の具体例としては、前述の芳香族樹脂の製造方法の例により得られる芳香族樹脂、ポリ (オキシー2ーメチルー1,4ーフェニレンオキシー1,4ーフェニレンカルボニルー1,4ーフェニレンカルボニルー1,4ーフェニレンカルボニルー1,4ーフェニレン)、ポリ (オキシー2ーエチルー1,4ーフェニレン)、ポリ (オキシー2ーオクチルー1,4ーフェニレンオキシー1,4ーフェニレンカルボニルー1,4ーフェニレンンカルボニルー1,4ーフェニレン)、ポリ (オキシー2,3,6ートリメチルー1,4ーフェニレンカルボニルー1,4ーフェニレン)、ポリ (オキシー2,3,6ートリメチルー1,4ーフェニレンカルボニルー1,4ーフェニレンカルボニルー1,4ーフェニレンカルボニルー1,4ーフェニレンカルボニルー1,4ーフェニレンカルボニルー1,4ーフェニレン)、ポリ (オキシー2,3,5,6ーテトラメチルー1,4ーフェニレンオキシー1,4ーフェニレンカルボニルー1,4ーフェニレン)、ポリ (オキシー3,3°ージメチルー4,4°ー

WO 03/033566 PCT/JP02/10536

ビフェニレンオキシー1,4ーフェニレンカルボニルー1,4ーフェニレン)、 ポリ (オキシー2, 6ージメチルー1, 4ーフェニレンメチレンー3, 5ージ メチルー1, 4ーオキシー1, 4ーフェニレンカルボニルー1, 4ーフェニレ ン)、ポリ(オキシー2ーメチルー1,4ーフェニレンー2、2ープロピリデ ン-1, 4-フェニレンオキシ-1、4-フェニレンカルボニル-1, 4-フ 5 ェニレン)、ポリ (オキシー2, 6-ジメチル-1, 4-フェニレン-2、2 ープロピリデンー3,5ージメチルー1,4ーフェニレンオキシー1、4ーフ ェニレンカルボニルー1, 4ーフェニレン)、ポリ (オキシー1, 4ーフェニ レンー1, 4-フェニレンオキシー1、4-フェニレンカルボニルー1, 4-フェニレン)、ポリ(オキシー2-メチルー1,4-フェニレンスルホニルー 10 3-メチル-1, 4-フェニレン)、ポリ(オキシ-2, 6-ジメチル-1. 4-フェニレンスルホニルー3,5-ジメチルー1,4-フェニレン)、ポリ (オキシー1, 4ーフェニレンスルホニルー1, 4ーフェニレンオキシー2, 5-ジメチル-1, 4-フェニレン)、ポリ (オキシ-1, 4-フェニレンス ルホニルー1, 4-フェニレンオキシー1, 4-テトラメチルフェニレン)、 15 ポリ (オキシー2ーメチルー1, 4ーフェニレンスルホニルー3ーメチルー1, 4-フェニレンオキシー1, 4-フェニレン)、ポリ (オキシー1, 4-フェ ニレンスルホニルー1, 4ーフェニレンオキシー5ーメチルー1, 3ーフェニ レン)、ポリ (オキシー1, 4ーフェニレンスルホニルー1, 4ーフェニレン オキシー2, 6ージメチルー1, 4ーフェニレンー3, 5ージメチルー1, 4 20 ーフェニレン)、ポリ (オキシー1, 4ーフェニレンスルホニルー1, 4ーフ ェニレンオキシー2、6ージメチルー1、4ーフェニレンメチレンー3、5ー ジメチルー1, 4-フェニレン)、ポリ(オキシー1, 4-フェニレンスルホ ニルー1, 4-フェニレンオキシ-2, 6-ジメチル-1, 4-フェニレンー 2、2-イソプロピリデン-3、5-ジメチル-1、4-フェニレン)、など 25 が挙げられる。

[プロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂の分子量]

本発明のプロトン酸基含有芳香族樹脂の分子量に特に制限はない。なお、良好な未架橋膜を得るためには、その分子量が還元粘度(η inh)にして0.1 ~5.0 d 1/g、好ましくは0.2~3.0 d 1/g、さらに好ましくは0.3~1.5 d 1/g(溶媒中、ポリマーまたは前駆体濃度0.5 g/d 1、35℃で測定した場合)であることが好ましい。分子量が低すぎると得られる未架橋膜の機械特性が低く、製膜時や取り扱い時に割れなどが発生するおそれがある。ただし、分子量が低い場合でも、製膜と同時に架橋処理を施せば、機械特性に優れた架橋膜を得ることができる。また、末端に架橋基を有する樹脂の場合には、分子量が低い方が、架橋密度の高い膜を得ることができる。分子量が高すぎると、樹脂の溶剤への溶解が困難となる、得られるワニスの粘度が極端に高いなど、ワニスの調整や使用上の問題を生じる場合がある。なお、本発明のプロトン酸基含有芳香族樹脂の分子量は、反応時に用いるモノマーのモル比や、末端封止剤の量を調整することにより制御することができる。

[プロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂を用いて得られるワニス]

本発明のプロトン酸基含有芳香族樹脂およびその前駆体(例えばポリアミド酸など)は、未架橋時には直鎖状であることから、溶剤溶解性に優れる。従って、該樹脂を溶剤に溶解したワニスの形態とすることができる。ここで、溶剤は特に制限なく選択でき、たとえば、水、メタノール、エタノール、1ープロパノール、2ープロパノール、ブタノールなどのアルコール類、トルエン、キシレンなどの炭化水素類、塩化メチル、塩化メチレンなどのハロゲン化炭化水素類、ジクロロエチルエーテル、1,4ージオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル類、酢酸メチル、酢酸エチルなどの脂肪酸エステル類、アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン類のほか、N,Nージメチルアセトアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、ジメチルスルホキシド、炭酸ジメチルなどの非プロトン性極性溶剤類があげられる。これらは単独でも混合溶媒でも使用でき

20

る。中でも、低級アルコール類、テトラヒドロフラン、炭酸ジメチルなどは、 沸点が低く溶媒の蒸発が早く、水溶性のため好ましく、更にこれらと水との混 合溶媒を用いることが好ましい。ワニス中の樹脂濃度は、使用方法により選択 できるが、1wt%以上80wt%以下が好ましい。また、該ワニスは、該樹 脂のほかに、例えばフッ素系イオン伝導性樹脂や電極材料などを含んでいても 良く、この場合、すべてが溶解した溶液はもちろん、一部が溶解していない懸 濁液であってもよい。

[プロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂を用いて得られる高分子膜]

本発明の高分子膜は、プロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂を用いて得られる 10 高分子膜である。本発明の高分子膜は、本発明のプロトン酸基含有芳香族樹脂 のほかに、例えばフッ素系イオン伝導性樹脂や電極材料などを含んでいても良 く、金属、ガラスやカーボンからなる繊維や高分子多孔質膜などと複合化され ていてもよい。

本発明のプロトン酸基含有芳香族樹脂は、未架橋時には直鎖状であることか 5、熱可塑性に優れ、プレス成形や押し出し成形により、容易に製膜化することができ、延伸処理などを施すこともできる。ただし、芳香族ポリイミド、芳香族ポリアゾールなど、一部の樹脂においては、熱可塑性でない場合がある。また、一部の樹脂においては、その溶融流動温度が、プロトン酸基の分解(芳香環からの脱離温度)より高く、溶融成形に適さない場合がある。

20 本発明のプロトン酸基含有芳香族樹脂は、前述のワニスの形態からキャスト 法により製膜することもできる。すなわち、該ワニスを支持体上に塗布、溶剤 を揮発除去することにより、良質の膜を得ることができる。

[イオン伝導性高分子膜]

本発明の燃料電池用イオン伝導性高分子膜は、前述の高分子膜を架橋するこ 25 とにより得られるイオン伝導性高分子膜である。本発明の燃料電池用イオン伝 導性高分子膜は、本発明のプロトン酸基含有芳香族樹脂のほかに、例えばフッ 素系イオン伝導性樹脂や電極材料などを含んでいても良く、金属、ガラスやカ ーボンからなる繊維や高分子多孔質膜などと複合化されていてもよい。

本発明の燃料電池用イオン伝導性高分子膜のイオン交換基当量に特に制限はないが、好ましくは200~5000g/mol、より好ましくは200~1000g/mol、より好ましくは200~1000g/molである。ここで、イオン交換基当量とは、プロトン酸基1モル当たりの樹脂重量で定義され、樹脂単位重量当たりのプロトン酸基のモル数の逆数を意味する。すなわち、イオン交換基当量が小さいほど、樹脂単位重量当たりのプロトン酸基量が多いことを示す。イオン交換基当量が上記の範囲の未架橋膜の場合、膜が水やメタノールに溶解する、膜の膨潤が著しい、燃料の膜透過量が大きいなどの問題を有する。一方、本発明の燃料電池用イオン伝導性高分子膜は、架橋により、溶解、膨潤、燃料の膜透過が抑制できることから、イオン交換基当量が上記の範囲であっても、燃料電池用途に供することができる。なお、イオン交換基当量が大きすぎる場合には、イオン伝導性が低く高出力の燃料電池を得ることができない。

本発明の燃料電池用イオン伝導性高分子膜のメタノール溶解性は、好ましく は15 w t %未満、より好ましくは10 w t %以下、特に好ましくは5 w t % 以下である。ここで、メタノール溶解性とは、膜をメタノールに浸漬した後の 重量減少率で示される。本発明の燃料電池用イオン伝導性高分子膜は、架橋に より、メタノールへの溶解性が抑制でき、イオン交換基当量が小さくてもメタノール溶解性を上記の範囲とすることができる。 なお、メタノール溶解性が大 きい場合には、電池中で、膜の溶解、強度低下、薄膜化、穴の発生、メタノールのクロスオーバーなどが起こるため、燃料電池用途に供することができない。 本発明の燃料電池用イオン伝導性高分子膜のイオン交換基当量およびメタノール溶解性は、用いるプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂のプロトン酸基含有量や架橋基含有量により制御することができる。また、架橋処理の条件により 架橋量を調整することによって制御することもできる。

本発明の燃料電池用イオン伝導性高分子膜の厚みに特に制限はないが、通常、 $10\sim200\,\mu$ m、特には $30\sim100\,\mu$ mが好ましい。この範囲内であれば、

十分な膜強度が得られ、かつ膜抵抗が実用上十分に低くなる。すなわち、電池の正極と負極の燃料を遮断し、かつ、十分なイオン伝導性を有することで、燃料電池として優れた発電性能を得ることができる。膜の厚みが薄すぎる場合には、燃料のクロスオーバーを十分に抑制しきれない場合があり、厚すぎる場合には、膜抵抗が高く、発電性能に影響を与える場合がある。ここで、膜厚は、製膜時の条件、例えばプレス成形時の温度や圧力、キャスト時のワニス濃度や塗布厚などにより制御することができる。

本発明の燃料電池用イオン伝導性高分子膜は、前述のプロトン酸基を有するが、中でも、最もイオン伝導性の高い、下記式(41)のプロトン酸基であることが好ましい。

 $-C_nH_{2n}-SO_3H$ (nは0~10の整数) (41)

なお、該プロトン酸基を有する燃料電池用イオン伝導性高分子膜は、該プロトン酸基を有するプロトン酸基含有芳香族樹脂を用いることにより得ることができる。あるいは、該プロトン酸基のアルカリ金属塩であるプロトン酸基を有するプロトン酸基含有芳香族樹脂から得られた膜を、塩酸水、硫酸水などで処理することにより得ることもできる。

本発明の燃料電池用イオン伝導性高分子膜中に、キャスト時の有機溶剤などが残存している場合には、イオン伝導性が低下する場合がある。そのため、本発明の燃料電池用イオン伝導性高分子膜は十分な乾燥や、水、硫酸水、塩酸水などでの洗浄を施すことが好ましい。

「結着剤〕

5

10

15

20

25

本発明の燃料電池用イオン伝導性結着剤は、本発明のプロトン酸基含有架橋性樹脂を含んでなる結着剤である。結着剤は、電極材料などとの混合や、電極材料、膜との接着を行うために用いられるものである。したがって、既に架橋し不溶不融となった樹脂は、結着剤として用いることができなかったが、本発明のプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂は、接着時あるいは接着後に架橋させることができ、架橋後には優れたイオン伝導性、耐熱性、耐水性、接着性を示

すので、燃料電池用イオン伝導性結着剤として好適な性質を示すものである。

すなわち、本発明の結着剤は、導電材料や触媒などを固めて電極とする役割を果たせるし、また電解質膜、電極およびセパレーターをつなぎ合わせる役割を果たすことができる。なお、本発明の結着剤は、粉体、塗膜として、あるいは、溶剤に溶解または懸濁したワニスとして、結着に供することができる。

本発明の燃料電池用イオン伝導性結着剤のイオン交換基当量およびメタノール溶解性に特に制限はなく、用いるプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂のプロトン酸基含有量や架橋基含有量により制御することができる。また、架橋処理の条件により架橋量を調整することによって制御することもできる。なお、高分子膜と異なり、結着剤は燃料の透過性が高い方が好ましい。ここで、本発明の結着剤は、架橋により溶解性を抑制できることから、通常の未架橋樹脂に比べ、イオン交換基当量をより小さくし、イオン伝導性と燃料の透過性を向上することができる。さらに、架橋基含有量や架橋処理の条件により架橋量を減らすなどにより、その燃料透過性を制御することもできる。

本発明の燃料電池用イオン伝導性結着剤は、本発明のプロトン酸基含有架橋 性芳香族樹脂に他のイオン伝導性高分子材料を組合わせて用いることもできる。 このような他のイオン伝導性高分子材料としては、例えば下記式(42)で表 されるプロトン酸基含有フッ素系高分子、あるいは、従来公知のプロトン酸基 含有炭化水素系高分子を用いることができる。

5

10

15

$$\begin{array}{c}
(CF_2-CF_2)_p(CF_2-CF_2)_q\\
CF_2\\
F_3C-CF\\
O\\
CF_2\\
F_3C-CF

O

S

CF_2

G

CF_2

CF_2$$

(式(42)中、p、qは互いに独立に1~2000の整数、sは0~6の整数、tは1~6の整数である。)

この場合、結着剤中のプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂の組成比は5wt%以上とすることが好ましく、それにより電極材料や高分子などとの高い接着性を示す。

[電極形成用組成物]

本発明の電極形成用組成物は、前記のプロトン酸基含有芳香族樹脂またはこれと他の各種イオン伝導性高分子との混合物からなる結着材と、電極材料との混合物からなる。

10 電極材料としては、電気導電性を有する導電材料や、水素の酸化反応、酸素 の還元反応を促進する触媒などが挙げられる。

導電材としては、電気伝導性物質であればいずれのものでもよく、各種金属や炭素材料などが挙げられる。例えば、アセチレンブラックなどのカーボンブラック、活性炭および黒鉛などが挙げられ、これらは単独あるいは混合して、

15 粉末状あるいはシート状で使用される。

触媒としては、水素の酸化反応および酸素の還元反応を促進する金属であれば特に限定されないが、例えば鉛、鉄、マンガン、コバルト、クロム、ガリウム、バナジウム、タングステン、ルテニウム、イリジウム、パラジウム、白金、ロジウムまたはそれらの合金が挙げられる。

20 電極材料が、カーボンブラック、活性炭、黒鉛、鉛、鉄、マンガン、コバルト、クロム、ガリウム、バナジウム、タングステン、ルテニウム、イリジウム、パラジウム、白金、ロジウムおよびそれらの合金からなる群より選ばれる少なくとも一種である電極形成用組成物は、電極材料の好ましい態様である。

これらの電極材料と結着剤の比率は特に制限はないが、結着剤の比率が5~ 25 90wt%であると、電極の強度と効率が両立できるので好ましい。

なお、本発明の電極形成用組成物は、粉体として、あるいは、溶剤に溶解または懸濁したワニスとして、電極形成に供することができる。

[プロトン酸基含有架橋性樹脂、高分子膜、結着剤、電極形成用組成物の架橋] 本発明のプロトン酸基含有架橋性樹脂、高分子膜、結着剤、電極形成用組成物を架橋することにより、架橋物、燃料電池用イオン伝導性高分子膜、電極やMEA (Membrane Electrode Assembly:イオン伝導膜-電極複合体)を得ることができる。

本発明のプロトン酸基含有架橋性樹脂、高分子膜、結着剤、電極形成用組成物の架橋方法に特に制限はなく、光、熱、電子線などにより架橋することができる。

本発明のプロトン酸基含有架橋性樹脂、高分子膜、結着剤、電極形成用組成 物を光架橋する場合には、用いる光源としては、特に限定されず、通常、紫外線光、可視光の範囲の光が照射できる光源を用いる。具体的には、低圧水銀灯、高圧水銀灯、キセノンランプ、メタルハライド灯などが挙げられる。また、照射線量は光の波長、照射される樹脂の構造、樹脂の含有量、架橋温度およびその膜厚などにより異なるが、通常、500~10000mJ/cm²、好ま しくは1000~3000mJ/cm²である。

本発明のプロトン酸基含有架橋性樹脂、高分子膜、結着剤、電極形成用組成物を熱により架橋する場合、その熱供給方法は特に限定されず、通常のオーブンなどによる加熱で十分である。また、加熱時の温度、時間は、用いる架橋性ポリエーテルケトンの構造およびその膜厚により異なるが、通常、120~3~00℃、好ましくは150~250℃で、0.1~180分間、好ましくは1~60分間である。

本発明のプロトン酸基含有架橋性樹脂、高分子膜、結着剤、電極形成用組成物は、塗布後の乾燥や熱プレスなど、製膜や接合の操作時にその熱により架橋させることもできる。また、製膜や接合の操作時に同時に光照射を行うことで架橋させることもできる。

[燃料電池]

本発明の燃料電池は、本発明の高分子膜、結着剤、電極形成用組成物および

20

25

/または電極を用いて得られる燃料電池である。

本発明の燃料電池は、本発明の高分子膜とこの両側に接触して配置される正極および負極から構成される。水素、メタノールなどの燃料は負極において電気化学的に酸化されて、プロトンと電子を生成する。このプロトンは高分子電解質膜内を酸素が供給される正極に移動する。一方、負極で生成した電子は電池に接続された負荷を通り、正極に流れ、正極においてプロトンと酸素と電子が反応して水を生成する。

前記燃料電池を構成する電極は、本発明の結着剤および/または電極形成用 組成物を用いて得られる電極であることが好ましい。ここで、結着剤としては、 フッ素系樹脂なども使用でき、例えば前述のプロトン酸基含有フッ素系高分子 や、ポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレンーパーフルオロア ルキルビニルエーテル共重合体などが挙げられる。ただし、本発明の高分子膜 との接着性が高く、電池とした際に膜、電極材料の剥離がおきにくいことから、 本発明の結着剤を用いることが特に好ましい。

15 本発明の前記高分子膜、結着剤、電極材料を用いて得られる燃料電池は、膜、 結着剤のイオン伝導性により高い出力が得られると共に、樹脂の溶解、溶出、 燃料のクロスオーバーや、電池を構成する膜、電極材料の剥離などによる出力 低下が生じにくく、発電効率と信頼性に優れる。

20 [実施例]

以下、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明はこれにより何ら制限されるものではない。

実施例中の各種試験の試験方法は次に示すとおりである。

(i) 還元粘度

- 25 重合体粉末 0.50gを溶媒 100mlに溶解または重合体溶液を濃度 0.005g/mlに希釈し、35℃において測定した。
 - (ii) 5%重量減少温度、重量減少開始温度

空気中にてDTA-TG (マック・サイエンス社製TG-DTA 2·0 0 0)を用い、昇温速度 1 0 ℃/minで測定した。

(iii) ガラス転移温度

示差走査熱量測定 (DSC、マック・サイエンス社製DSC3100) により昇温速度10℃/minで400℃まで測定した。

(iv) プロトン交換

5

15

プロトン酸の金属塩等は以下の方法でフリーのプロトン酸に戻した。

- 1) プロトン酸基含有架橋樹脂粉末、膜またはその光架橋膜を2N-硫酸に一 晩浸した。
- 10 2)酸処理した粉末または膜を蒸留水に一晩浸した。
 - 3)酸処理および蒸留水で洗浄した粉末または膜を150℃で4時間乾燥して、 フリーのプロトン酸を含有する粉末または膜を得た。

(v-1) 光架橋 1

メタルハライドランプを用いて6000m J / c m² の光照射を行い、光架 橋させた。

(v-2) 光架橋 2

光架橋の光照射量を10000mJ/cm²とした。

(vi) 熱架橋

窒素気流中270℃で2時間熱処理して架橋させた。

20 (vii) イオン伝導度

イオン伝導性高分子膜を幅5mm、長さ40mmに切り出した後、PTFE (ポリテトラフルオロエチレン) ホルダー上に設置し、4本の電極を圧接し、4端子法の交流インピーダンス法で求まるColeーColeプロットの円弧から抵抗率を測定した。電圧端子間は20mmとした。インピーダンスの測定はLCRメーター(日置電機(株)製3532)を使用した。温度変化は電極を接続したサンプルをアルミブロック製の恒温槽内に設置することにより行い、30℃から110℃の範囲の伝導度を測定した。加湿は常圧の恒温槽内への蒸

気の導入により行い、水蒸気発生器にて測定温度が100℃未満では恒温槽温+5℃、100℃以上では120℃の一定温度に蒸留水を加熱し、生成する蒸気を使用した。また、イオン伝導度の計算に必要な膜厚は乾燥状態でマイクロメータを用いて測定した。

5 (幅)メタノール溶解性

窒素雰囲気下 150℃で4時間乾燥させたイオン伝導性高分子膜をメタノールに浸し、25℃で 24時間静置した。取り出したイオン伝導性高分子膜を再度 150℃で 4時間乾燥させた後、質量減少率を測定した。

(ix) メタノール透過性

10 室温にて蒸留水と、1 mo 1 / L メタノール水溶液を、直径 $2 3 \text{ mm} \phi$ の イオン伝導性高分子膜を介して接し、3 時間までの蒸留水側のメタノール濃度 変化をガスクロにて測定した。得られたメタノール濃度増加直線の傾きより、 膜厚 $5 0 \mu \text{ m}$ でのメタノール透過性を計算した。

(x)イオン交換基当量

15 イオン伝導性高分子膜を密閉できるガラス容器中に精秤し、そこに過剰量の 塩化カルシウム水溶液を添加して一晩攪拌した。系内に発生した塩化水素を O. 1 N水酸化ナトリウム標準水溶液にてフェノールフタレイン指示薬を用いて滴 定し、計算した。

(合成例1)

20 提拌器、温度計および冷却管を装備した反応フラスコに、4,4'ージフルオロベンゾフェノン(0.525mol)と、50%発煙硫酸210mlを装入した後、100℃で12時間反応した。これを、1000gの氷水に排出した後、NaOH210gで中和した。次に、NaClを210g加え、加熱溶解した後放冷し一夜放置した。析出した結晶を濾過した後、水400ml、エ25 タノール400mlを加えて加熱溶解後放冷し、再結晶を行った。析出した結晶を濾過後、100℃で6時間乾燥して下記の5,5'ーカルボニルビス(2ーフルオロベンゼンスルホン酸ナトリウム)の白色結晶を得た。収量155.

2g(0.386mol、収率70%)。

 $^{1}H-NMR$ (D₂O, TMS) ppm

 δ 7. 46 (2H, dd, a-H×2)

7. 99 (2H, ddd, $b-H\times 2$)

8. 23 (2H, dd, $c-H\times 2$)

元素分析 (%) C H

計算値 36.98 1.43

分析值 36.65 1.40

10 (合成例2)

5

15

20 5g(0.194mol、収率32%)

NMR (JEOL社製GSX-270にて測定)

¹ H-NMR (DMSO, TMS) ppm

- δ 7.83 (2H, dd, a-H×2)
 - 8. 10 (2H, ddd, $b-H\times 2$)
- 5 8. 54 (2H, dd, $c-H\times 2$)

元素分析(%)(パーキンエルマー社製2400型CHN分析装置にて測定)

C H

計算値 29.34 1.23

分析値 29.38 1.20

10 (合成例3)

ジムロート冷却管、100m1滴下ロートを備えた500m13つロフラスコに2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロパン(10g、0.04モル)、亜硫酸ナトリウム(48.3g、0.35モル)、炭酸ナトリウム(2.8g、0.03モル)、水200m1を加え、37%ホルムアルデヒド水溶液(10.5g、28.4m1、0.35モル)を加熱還流下、15分で滴下した。その後、加熱還流下12時間反応を行った。室温まで冷却後、10%塩酸を溶液がpH7になるまで加えた。析出した固体をろ別し、固体を水、エタノールを用いて洗浄した。2,2ービス(3,5ービス(スルホメチル)ー4ーヒドロキシフェニル)プロパンナトリウム塩を26.0g(収率74.4%)で20 得た。

分析結果:

 $^{1}H-NMR(D_{2}O): \delta(ppm)7. 10 (s, 2H), 4. 09 (s, 4H),$ 1. 52 (s, 3H)

(実施例1)

ゾフェノン2.18g (0.01mol)、2,2-ビス(3,5-ジメチルー4ーヒドロキシフェニル)プロパン5.69g (0.02mol) および炭酸カリウム3.46g (0.025mol) を秤取した。これにジメチルスルホキシド40mlとトルエン30mlを加え、窒素雰囲気下で撹拌し、130℃で2時間加熱し、生成する水を系外に除去した後、トルエンを留去した。

引き続き、160℃で14時間反応を行い、粘稠なポリマー溶液を得た。得られた溶液にジメチルスルホキシド (DMSO) 60m1を加えて希釈した後濾過した。このポリマー溶液をアセトン600m1に排出し、析出したポリマー粉を濾過後、160℃で4時間乾燥してポリエーテルケトン粉10.39g (収率92%)を得た。得られたポリエーテルケトン粉の還元粘度は0.85d 1/g (DMSO)、ガラス転移温度は230℃、5%重量減少温度は367℃であった。

- (a)得られた粉末ポリマーをDMSOに溶解させガラス基板上にキャストし、 200℃で4時間乾燥してスルホン酸Naを含有するポリエーテルケトン膜を 得た。得られた膜は可とう性に富み、強靭であった。この膜について、前記(vii) に記載の方法でイオン伝導度を測定した結果を表1に示す。
- (b) この膜を、前記(iv) に記載の方法でプロトン交換を行い、スルホン酸を含有するポリエーテルケトン膜を得た。得られた膜は可とう性に富み、強靭であった。この膜について、前記(vii) に記載の方法でイオン伝導度を測定した結果を表1に示す。
- (c)上記(a)で得られたスルホン酸N a を含有するポリエーテルケトン膜を、前記(v-1)に記載の方法で架橋し、スルホン酸N a 含有架橋ポリエーテルケトン膜を得た。得られた膜は可とう性に富み、強靭であった。この膜について、前記(vii)に記載の方法でイオン伝導度を測定した結果を表1に示す。
- 25 (d) 上記(c) で得られたスルホン酸Na含有架橋ポリエーテルケトン膜を、 前記(iv) に記載の方法でプロトン交換を行い、スルホン酸含有架橋ポリエー テルケトン膜を得た。得られた膜は可とう性に富み、強靭であった。この膜に

5

10

ついて、前記(vii)に記載の方法でイオン伝導度を測定した結果を表1に示す。 上記(a)で得られたスルホン酸Na含有ポリエーテルケトン膜の一部をD MSOに浸したところ完全に溶解し、水に浸したところ一部溶解した部分が見 られた。一方、上記(c)で得られたスルホン酸Na含有架橋ポリエーテルケ トン膜は、DMSOと水に完全に不溶化し、架橋して耐薬品性および耐水性が 向上していることが確認された。

- (e)上記(d)で得られたスルホン酸含有架橋ポリエーテルケトン膜のスルホン酸基脱離による重量減少開始温度を前記(ii)記載の方法で測定したところ257℃であった。
- 10 また、上記(b) および(d) で得られたスルホン酸基含有ポリエーテルケトン膜のメタノール溶解性を(vii) 記載の方法で測定した。(b) の膜の溶解性が60wt%であったのに対し(d) の膜は4.2wt%であり、架橋により耐メタノール性が大幅に向上していることが確認された。

(実施例2)

- 15 2, 2-ビス(3, 5-ジメチルー4-ヒドロキシフェニル)プロパンの使用量を5.41g(0.019mol)とした他は実施例1と同様にしてポリマー粉10.30g(収率93%)を得た。得られたポリエーテルケトン粉の還元粘度は0.40d1/g(DMSO)、5%重量減少温度は360℃であった。
- 20 得られた粉末ポリマーを用い、実施例1(a)~(d)と同等にしてポリエーテルケトン膜を得、イオン伝導度を測定した。結果を表1に示す。得られた膜はいずれも可とう性に富み、強靱であった。

表 1

	伝導度 (S/cm)					
実施例	(a) (30℃/90℃)	(30℃/90℃)	(c) (30℃/90℃)	(30℃∕90℃) (d)		
1	0.018/0.065	0.048/0.147	0.017/0.069	0.021/0.132		
2	0.018/0.063	0.051/0.150	0.016/0.069	0.020/0.136		

(実施例3)

3-1) 電解質膜の作成

実施例1のポリマーを用い、(d)で得られたスルホン酸含有架橋ポリェー 5 テルケトン膜を電解質膜とした。

3-2)空気極 (正極) 電極の作成

実施例1で得られたプロトン酸基含有ポリエーテルケトン粉を前記(iv)と同様にプロトン交換した粉末0.5gを結着剤として、蒸留水5.0g、テトラヒドロフラン4.5gの混合溶媒に溶解したワニス10gを田中貴金属製の30wt%Pt担持触媒(名称:TEC10V30E)0.5gと混合し、超音波印加ののち撹拌し、空気極用の電極形成用組成物とした。

東レ製カーボンペーパー(品番: TGP-H-060) の上にアプリケータを用いて、電極形成用組成物を塗工し、70で12時間真空乾燥した後、5 c m^2 に切り出し電極 2 とした。塗工量はP t 量で2 m g f とした。

15 3-3)燃料極 (負極) 電極の作成

実施例1で得られたプロトン酸基含有ポリエーテルケトン粉を前記(iv)と同様にプロトン交換した粉末0.5gを結着剤として、蒸留水5.0g、テトラヒドロフラン4.5gの混合溶媒に溶解したワニス10gを田中貴金属製の33wt%PtRu担持触媒(名称:TEC61V33)0.5gと混合し、

20 超音波印加ののち撹拌し、燃料極用の電極形成用組成物とした。

3-4)接合体の作成

25 3-1 で作成したスルホン酸含有架橋ポリエーテルケトン電解質膜と 3-2 で作成した電極 2 、3-3 で作成した電極 2 それぞれ 1 枚ずつを、 2 0 w t %テトラヒドロフラン水溶液を噴霧しながら、所定の順番に積層し、あらかじめ 8 0 \mathbb{C}

に加熱した熱プレスに導入し、0.4MPaを電極面にのみ加圧した。その後、加圧した状態のまま、80 Cから 130 Cまで昇温させた。使用した熱プレスでは 15 分を要した。接合後の電解質膜電極接合体はほぼ乾燥状態であったが、電極の剥離はなかった。

5 3-5) 発電試験

10

15

20

3-4 で作成した電解質膜電極接合体を、Electrochem 社製の燃料電池試験セル (品番: EFC-05-REF) に組み込み、図1 の燃料電池を組み立てた。図1 では、電解質膜1 を上記で作製した触媒付き電極2 および2 がガスケット3 を使用して挟み、さらにその外側にセパレータ4 が置かれて、全体を加圧板5 を用いて締め付けボルト7 でしっかりと締め付けられた構造となっているが、内部6 にはガス流路が設けられている。

セル組み立て後図2のような燃料電池評価装置を使用して、1Mメタノール 水溶液を燃料として電池特性を測定した。約5.1mW/cm²の出力を得た。

図2では、燃料電池セル8の中には図1の燃料電池が組み込んである。図の上側のラインではメタノール水溶液を送液ポンプ12により燃料電池セル8を通して左側から右側に送液している。また、下側のラインでは空気を加湿用バブリングタンク9により加湿した状態で8を通して左側から右側に通気している。燃料極側の流路6をメタノール水溶液が、空気極側の流路6を空気が流れる様になっている。それぞれの流量はマスフローコントローラー11で制御する。メタノール水溶液および空気を流すことにより生じる電圧および電流密度を電子負荷10で測定することにより燃料電池を評価する仕組みになっている。製作した燃料電池の電池特性を図3に示した。測定条件を表2に示した。

図3は電流密度に対する電圧と出力密度のプロットであり、この図により燃料電池の出力性能が比較できる。

25 発電試験後のセルを分解し、電解質膜電極接合体を観察したが、電解質膜と 電極の剥離はなかった。

表 2 .

測定条件	
燃料電池温度	80℃
メタノール水溶液濃度	1 M (3. 2%)
メタノール水溶液流量	2cc/min
メタノール水溶液温度	30℃
空気圧力	0. 05MPa
空気流量	100SCCM
空気バブリングタンク温度	50℃

(実施例4)

5 4-1) 電解質膜の作成

実施例1のポリマーを用い、(d)で得られたスルホン酸含有架橋ポリエー テルケトン膜を電解質膜とした。

4-2) 空気極(正極) 電極の作成

実施例1で得られたプロトン酸基含有ポリエーテルケトン粉を前記(w)と同様にプロトン交換した粉末0.25g、実施例2で得られたプロトン酸基含有ポリエーテルケトン粉を前記(w)と同様にプロトン交換した粉末0.25gを、蒸留水5.0g、テトラヒドロフラン4.5gの混合溶媒に溶解したワニス10gと、Aldrich社製プロトン酸基含有フッ素系高分子(Nafion)5wt%溶液(品番:27,470-4)10gを混合しワニスとした。この混合ワニス20gと田中貴金属製の30wt%Pt担持触媒(名称:TEC10V30E)1.0gと混合し、超音波印加ののち撹拌し、空気極用の電極形成用組成物とした。

東レ製カーボンペーパー(品番:TGP-H-060)の上にアプリケータを用いて、電極形成用組成物を塗工し、70℃で12時間真空乾燥した後、5 c m² に切り出し電極2とした。塗工量はPt量で2mg/cm²とした。 4-3) 燃料極(負極)電極の作成

実施例1で得られたプロトン酸基含有ポリエーテルケトン粉を前記 (iv) と

同様にプロトン交換した粉末0.25g、実施例2で得られたプロトン酸基含有ポリエーテルケトン粉を前記(iv)と同様にプロトン交換した粉末0.25gを、蒸留水5.0g、テトラヒドロフラン4.5gの混合溶媒に溶解したワニス10gとAldrich社製プロトン酸基含有フッ素系高分子(Nafion)5wt%溶液(品番:27,470-4)10gを混合しワニスとした。この混合ワニス20gと田中貴金属製の33wt%PtRu担持触媒(名称:TEC61V33)1.0gと混合し、超音波印加ののち撹拌し、燃料極用の電極形成用組成物とした。

東レ製カーボンペーパー(品番:TGP-H-060)の上に電極形成用組 10 成物を塗工し、70 \mathbb{C} で 12 時間真空乾燥した後、5 \mathbb{C} \mathbb{m}^2 に切り出し電極 2 とした。塗工量は \mathbb{P} \mathbb{T} \mathbb{T} とした。

4-4)接合体の作成

4-1 で作成したスルホン酸含有架橋ポリエーテルケトン電解質膜と 4-2 で作成した電極 2、4-3 で作成した電極 2 それぞれ 1 枚ずつを使用した以外は、

15 実施例3の3-4と同様に接合体を作成した。接合後の電解質膜電極接合体はほぼ乾燥状態であったが、電極の剥離はなかった。

4-5) 発電試験

4-4 で作成した電解質膜電極接合体を用いて、実施例3の3-5 と同様に燃料電池組み立て、電池特性を測定した。約7.3 mW/c m² の出力を得た。製作した燃料電池の電池特性を図3に示した。測定条件は表2と同じである。

発電試験後のセルを分解し、電解質膜電極接合体を観察したが、電解質膜と 電極の剥離はなかった。

(実施例5)

20

5-1)電解質膜の作成

- 25 実施例1のポリマーを用い、(d)で得られたスルホン酸基含有架橋ポリエーテルケトン膜を電解質膜とした。
 - 5-2) 空気極(正極) 電極の作成

Aldrich社製プロトン酸基含有フッ素系高分子(Nafion) 5wt%溶液(品番:27,470-4)10gと田中貴金属製の30wt%Pt担持触媒(名称:TEC10V30E)0.5gと混合し、超音波印加ののち撹拌し、空気極用の電極形成用組成物とした。

5 東レ製カーボンペーパー(品番: TGP-H-060)の上にアプリケータを用いて、電極形成用組成物を塗工し、70℃で12時間真空乾燥した後、5 c m² に切り出し電極2とした。塗工量はPt量で2mg/c m² とした。

更に電極 2上に実施例 2 で得られたプロトン酸基含有ポリエーテルケトン粉を前記(iv)と同様にプロトン交換した粉末 0. 5 g を蒸留水 5. 0 g、テトラヒドロフラン 4. 5 g の混合溶媒に溶解したワニス 1 0 g と A 1 d r i c h社製プロトン酸基含有フッ素系高分子(Nafion)5 w t %溶液(品番:2 7, 4 7 0 -4) 1 0 g を混合したワニスを噴霧塗工した。その後常温空気中で 1 晩乾燥させた。プロトン酸基含有ポリエーテルケトン/プロトン酸基含有フッ素系高分子混合物塗工量は乾燥重量で 1 m g / c m 2 とした。

15 5-3) 燃料極 (負極) 電極の作成

Aldrich社製プロトン酸基含有フッ素系高分子(Nafion) 5wt%溶液(品番:27,470-4)10gと田中貴金属製の33wt%PtRu担持触媒(名称:TEC61V33)0.5gと混合し、超音波印加ののち撹拌し、燃料極用の電極形成用組成物とした。

20 東レ製カーボンペーパー(品番: TGP-H-060)の上に電極形成用組成物を塗工し、70℃で12時間真空乾燥した後、5cm²に切り出し電極2'とした。塗工量はPtRu量で2mg/cm²とした。

更に電極2,上に実施例2で得られたプロトン酸基含有ポリエーテルケトン 粉を前記(iv)と同様にプロトン交換した粉末0.5gを蒸留水5.0g、テトラヒドロフラン4.5gの混合溶媒に溶解したワニス10gとA1drich社製プロトン酸基含有フッ素系高分子(Nafion)5wt%溶液(品番:27,470-4)10gを混合したワニスを噴霧塗工した。その後常温空気

25

中で1 晩乾燥させた。プロトン酸基含有ポリエーテルケトン/プロトン酸基含有フッ素系高分子混合物塗工量は乾燥重量で1 mg/cm² とした。

5-4)接合体の作成

5-1 で作成したスルホン酸含有架橋ポリエーテルケトン電解質膜と 5-2 で作成した電極 2、5-3 で作成した電極 2 それぞれ 1 枚ずつを使用した以外は、 実施例 3-4 と同様に接合体を作成した。接合後の電解質膜電極接合体はほぼ乾燥状態であったが、電極の剥離はなかった。

5-5) 発電試験

5

5-4 で作成した電解質膜電極接合体を用いて、実施例3の3-5 と同様に燃料 10 電池を組み立て、電池特性を測定した。約10.8 mW/c m² の出力を得た。 製作した燃料電池の電池特性を図3に示した。測定条件は表2と同じである。

発電試験後のセルを分解し、電解質膜電極接合体を観察したが、電解質膜と 電極の剥離はなかった。

(実施例6)

15 実施例1で得られた粉末ポリマーを前記(iv)の方法でプロトン交換し、得られた粉末ポリマーをジメチルアセトアミド(DMAc)に溶解させガラス基板上にキャストし、150で4時間乾燥してポリエーテルケトン膜を得た。この膜を(v-1)記載の方法で光架橋させた後に($v\ddot{u}$)記載の方法でイオン伝導度を測定したところ、伝導度は90で0.129S/c mであった。

20 (実施例7~27)

25

各種芳香族ジヒドロキシ化合物、プロトン酸基含有芳香族ジハライド化合物 および芳香族ジハライド化合物の割合を変えた他は実施例1と同様にして、各 種ポリエーテルケトン膜を作成した。得られたポリエーテルケトン膜について 実施例1と同様にして測定した各種物性を表3に、イオン伝導度を測定した結 果を表4に併せて示す。

以降の実施例において、用いた化合物のうち、以下の化合物は、以下の略号で示す。

DFBP-2S:5,5'-カルボニルビス(2-フルオロベンゼンスルホン酸ナトリウム)

DCBP-2S:5,5'-カルボニルビス(2-クロロベンゼンスルホン酸ナトリウム)

5 DNBP-2S:5,5'-カルボニルビス(3-ニトロベンゼンスルホン酸ナトリウム)

SDCDPS: 5, 5'ースルホニルビス (2ークロロベンジルスルホネート) ナトリウム塩

SDFDPS: 5, 5'-スルホニルビス (2-フルオロベンジルスルホネー

10 ト)ナトリウム塩

DFBP: 4, 4'-ジフルオロベンゾフェノン

DCBP: 4, 4'ージクロロベンゾフェノン

DNBP: 3, 3' -ジニトロベンゾフェノン

DCDPS: 4, 4'ージクロロジフェニルスルホン

15 DFDPS: 4, 4'-ジフルオロジフェニルスルホン

BisA: ビスフェノールA

BisF: ビスフェノールF

HQ:ヒドロキノン

DHBP: 4, 4'-ジヒドロキシビフェニル

20 DHDFS: 4, 4'-ジヒドロキシジフェニルスルホン

dMe-HQ:2,6-ジメチルハイドロキノン

tMe-BisA: 2, 2-ビス (3, 5-ジメチルー4-ヒドロキシフェニル) プロパン

tMe-BP: 3, 3', 5, 5'-テトラメチルー4, 4'-ジヒドロキシ

25 ビフェニル

t Me-MPH: 3, 3', 5, 5' ーテトラメチルー4, 4' ージヒドロキ シジフェニルメタン tMe-OPH: 3, 3', 5, 5'-テトラメチルー<math>4, 4'-ジヒドロキシジフェニルエーテル

tMe-SPH: 3, 3', 5, 5'-テトラメチルー<math>4, 4'-ジヒドロキシジフェニルスルフィド

5 tMe-SOPH: 3, 3', 5, 5' -テトラメチルー4, 4' -ジヒドロ キシジフェニルスルホン

 $tMe-BisP: \alpha$, α 'ービス(3, 5-ジメチルー4-ヒドロキシフェニル)-1, <math>4-ジイソプロピルベンゼン

dMe-BDSA: 5, 5'-ij + 2 + 4'-ij + 2 + 2'-ij +

10 ェニルジスルホン酸ナトリウム塩

BDSA: 4, 4'ージアミノー2, 2'ービフェニルジスルホン酸ナトリウム

DABP: 4, 4'ージアミノベンゾフェノン

NTDA:1,4,5,8ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物

15 3EP: 3-エチニルフェノール

4EFB:4-エチニルフルオロベンゼン

(比較例1)

ナフィオン膜 (膜厚 5 0 μm) (A 1 d r i c h 社試薬) を用いて、実施例 1 の測定方法と同様にして各種物性を測定した。 T g は 1 3 0 ℃であり、伝導 20 度の測定結果は表 4 に示す。

表3

実施例	ジヒドロキ	プロトン酸	ジハライド	収率	還元	ガラス転	5%重量	
	シ化合物	化合物	化合物		粘度	移温度	減少温度	
	g, (mol)	g, (mol)	g、(mol)	%	dl/g	ိင	°C	
7	tMe-BisA	DFBP-2S	DFBP	90	0. 76	248	372	
	5. 69 (0. 02)	6. 76 (0. 016)	0. 87 (0. 004)	90	0. 76	240	3/2	
8	. DMe-HQ	DFBP-2S	DFBP	93	1. 23	不検出	384	
	2. 76 (0. 02)	4. 22 (0. 01)	2. 18 (0. 01)	30	1. 25	1172	304	
9	DMe-HQ	DFBP-2S	DFBP	92	0. 92	不検出	394	
	2. 76 (0. 02)	6. 76 (0. 016)	0. 87 (0. 004)	52	0. 52			
10	tMe-BP	DFBP-2S	DFBP	94	1. 16	. 16 255	363	
	4. 84 (0. 02)	4. 22 (0. 01)	2. 18 (0. 01)	<u> </u>	1. 10			
111	tMe-BP	DFBP-2S	DFBP	93	1.06	不検出	327	
	4. 84 (0. 02)	6. 76 (0. 016)	0. 87 (0. 004)			1 2 1		
12	tMe-MPH	DFBP-2S	DFBP	91	1.01	不検出	332	
	5. 13 (0. 02)	4. 22 (0. 01)	2. 18 (0. 01)					
13	tMe-MPH	DFBP-2S	DFBP	92	0. 86	不検出	326	
ļ	5. 13 (0. 02)	6. 76 (0. 016)	0. 87 (0. 004)					
14	tMe-OPH	DFBP-2S	DFBP	94	1.06	不検出	346	
	5. 17 (0. 02)	4. 22 (0. 01)	2. 18 (0. 01)					
15	tMe-OPH	DFBP-2S	DFBP	92	0. 85	不検出	352	
 	5. 17 (0. 02)	6. 76 (0. 016)	0. 87 (0. 004)					
16	tMe-SPH	DFBP-2S	DFBP	92	0. 82	不検出	343	
	5. 49 (0. 02) tMe-SPH	4. 22 (0. 01) DFBP-2S	2. 18 (0. 01) DFBP					
17	5. 49 (0. 02)	6. 76 (0. 016)	0. 87 (0. 004)	96	0. 73	不検出	346	
	5. 49 (U. UZ) tMe-SOPH	DFBP-2S	0. 87 (0. 004) DFBP					
18	6. 13 (0. 02)	4. 22 (0. 01)	2. 18 (0. 01)	93	0. 89	不検出	362	
	tMe-SOPH	DFBP-2S	2. 18 (0. 01) DFBP					
19	6. 13 (0. 02)	6. 76 (0. 016)	0. 87 (0. 004)	94	0. 71	不検出	352	
	tMe-BisP	DFBP-2S	DFBP					
20	8. 05 (0. 02)	4. 22 (0. 01)	2. 18 (0. 01)	95	1.01	255	358	
	tMe-BisP	DFBP-2S	DFBP					
21	8. 05 (0. 02)	6. 76 (0. 016)	0. 87 (0. 004)	97	0.86	277	374	
22	tMe-BisA	DFBP-2S	DCBP	٥٢.	0.76	7°46W	051	
22	5. 69 (0. 02)	4. 22 (0. 01)	2. 51 (0. 01)	95	U. /6	0.76 不検出	351	
23	DMe-HQ	DFBP-2S	DNBP	00	92 0.68 不検出	不快出	242	
23	2. 76 (0. 02)	4. 22 (0. 01)	2. 72 (0. 01)	92		8 个模出	342	
2 4	tMe-BP	DCBP-2S	DCBP	00	0. 65	7-46-11	262	
24	4. 84 (0. 02)	4. 55 (0. 01)	2. 51 (0. 01)	90	U. 05	不検出	362	
25	tMe-BP	DCBP-2S	DNBP	03	0. 72	不検出	354	
25	4. 84 (0. 02)	4. 55 (0. 01)	2. 72 (0. 01)	93	93 0.7	93 0.72	个快口	354
26	tMe-BisP	DNBP-2S	DNBP 91	01 0.62	0.62	0. 62 不検出	343	
2.0	8. 05 (0. 02)	4. 76 (0. 01)	2, 72 (0, 01)	31	0. 02	17校山	3 4 3	
27	tMe-BisP	DNBP-2S	DFBP	94	0. 69	不検出	358	
	8. 05 (0. 02)	4. 76 (0. 01)	2. 18 (0. 01)		5. 05	17211		

表4

		伝導度 (S	/ c m)	
実施例	(a)	(b)	(c)	(d)
	(30°C ∕90°C)	(30°C∕90°C)	(30°C∕90°C)	(30°C∕90°C)
7	0.034 / 0.082	0.095 / 0.337	0. 030 / 0. 091	0. 054 / 0. 301
8	0. 029 / 0. 073	0. 082 / 0. 296	0. 021 / 0. 084	0. 051 / 0. 245
9	0.039 / 0.098	0. 102 / 0. 352	0. 036 / 0. 103	0.062 / 0.382
10	0.018 / 0.070	0. 050 / 0. 155	0. 020 / 0. 075	0. 024 / 0. 139
11	0. 036 / 0. 089	0.098 / 0.336	0. 032 / 0. 095	0.059 / 0.316
1 2	0. 020 / 0. 069	0. 049 / 0. 150	0. 018 / 0. 072	0. 022 / 0. 140
13	0. 035 / 0. 091	0.096 / 0.336	0. 032 / 0. 094	0.055 / 0.315
14	0. 021 / 0. 071	0.050 / 0.148	0. 016 / 0. 073	0. 023 / 0. 138
15	0. 036 / 0. 090	0.098 / 0.341	0. 033 / 0. 095	0.056 / 0.321
1 6	0. 023 / 0. 070	0.047 / 0.158	0. 017 / 0. 082	0. 024 / 0. 139
17	0. 038 / 0. 092	0.099 / 0.331	0. 031 / 0. 097	0. 054 / 0. 335
18	0. 021 / 0. 072	0.045 / 0.162	0.015 / 0.089	0.026 / 0.135
19	0.035 / 0.095	0.096 / 0.318	0.030 / 0.093	0.055 / 0.328
20	0.014 / 0.055	0.038 / 0.132	0.012 / 0.058	0.019 / 0.122
21	0.029 / 0.074	0.088 / 0.294	0.025 / 0.086	0.043 / 0.278
2 2	0.017 / 0.062	0.046 / 0.145	0.016 / 0.066	0.020 / 0.129
2 3	0. 025 / 0. 070	0.079 / 0.275	0.018 / 0.081	0. 049 / 0. 243
2 4	0.019 / 0.069	0.049 / 0.152	0.019 / 0.072	0. 023 / 0. 135
2 5	0.018 / 0.065	0. 045 / 0. 146	0.018 / 0.076	0.031 / 0.132
2 6	0.012 / 0.051	0. 032 / 0. 126	0.011 / 0.055	0.017 / 0.120
27	0.013 / 0.050	0. 030 / 0. 122	0.013 / 0.058	
比較例 1	未測定	未測定	未測定	0. 020 / 0. 131

表 4 より、実施例 7 ~ 2 7 は比較例 1 のナフィオン膜に比べて同等の優れたイオン伝導度を示し、また、Tgがナフィオン膜の130℃よりも十分に高く、

耐熱性が大きく向上していることが分かる。

(実施例28)

5

10

15

20

25

窒素導入管、温度計、還流冷却器、及び撹拌装置を備えた200mlの5つ口反応器に、tMe-BisA5.69g(20mmol) および炭酸カリウム3.46g(25mmol) を秤取した。これにジメチルアセトアミド(DMAc)20mlとトルエン30mlを加え、窒素雰囲気下130℃で4時間加熱撹拌し、生成する水を系外に除去した後、トルエンを留去した。引き続き、合成例2で得たSDCDPS4.91g(10mmol)、DFBP2.18g(10mmol) およびDMAc20mlを加え、165℃で20時間反応を行い、粘稠なポリマー溶液を得た。得られた溶液にDMAc60mlを加えて希釈した後セライト濾過した。濾液をトルエン600mlに排出し、析出したポリマー粉を濾過後、160℃で4時間乾燥してポリマー粉を得た。合成結果を表5に示す。

得られた粉末ポリマーをDMA c に溶解させガラス基板上にキャストし、200℃で4時間乾燥してスルホン酸N a 基を含有するポリエーテルケトン膜を得た。得られた膜を、(v-2)に記載の方法で架橋し、スルホン酸N a 基含有架橋ポリエーテルケトン膜を得た。次に(iv)に記載の方法でプロトン交換を行い、スルホン酸基含有架橋ポリエーテルケトン膜を得た。得られた膜は可とう性に富み、強靭であった。この膜について、前記(vii)に記載の方法でイオン伝導度を測定した結果および(viii)の方法でメタノール溶解性を測定した結果を表6に示す。

(実施例29~31)

各種芳香族ジヒドロキシ化合物および、プロトン酸基含有芳香族ジハライド 化合物と芳香族ジハライド化合物の種類および割合を変えた他は実施例 2 8 と 同様にして、各種ポリエーテルケトン粉末を得た。得られた粉末ポリマーより キャスト膜を作成し、(v-1) に記載の方法で架橋した。更に(iv) に記載 の方法でプロトン交換を行い、スルホン酸含有架橋ポリエーテルケトン膜を得 た。合成結果を表 5 に、得られた各種ポリエーテルケトン粉末および膜の各種物性の測定結果を表 6 に併せて示す。

(比較例2~4)

架橋基を含む化合物を使用せず、その他の条件は実施例28と同様にして芳 5 香族ジヒドロキシ化合物および、プロトン酸基含有芳香族ジハライド化合物と 芳香族ジハライドよりポリエーテル膜を作製した。得られたポリエーテルの合 成結果を表5に、各種物性測定結果を表6に比較例1と併せて示す。

表 5

実施例	スルホン化シ*ハラ イト*化合物 g(mmol)	シ*ハライト*化 合物 g(mmol)	ジヒドロキシ 化合物 g(mmol)	イか交換 基当量 a g/eq	収率 %	還元 粘度 dl/g
28	SDCDPS 4.91(10)	DFBP 2.18(10)	tMe-BisA 5.69(20)	570	92	1.02
29	SDCDPS 2.95(6)	DFBP 3.52(14)	tMe-BisA 5.69(20)	890	94	0.99
30	SDCDPS 6.88(14)	DFBP 1.51(6)	tMe-BisA 5.69(20)	570	92	1.03
31	SDCDPS 4.91(10)	DCBP 2.51(10)	tMe-MPH 5.13(20)	540	92	1.07
比較例	SDCDPS 4.91(10)	DCDPS 2.87(10)	BisA 4.57(20)	550	93	1.02
比較例	SDCDPS 2.95(6)	DCDPS 4.02(14)	BisA 4.57(20)	840	92	1.11
比較例	SDCDPS 2.95(2)	DCDPS 4.02(18)	BisA 4.57(20)	1210	92	1.14

a: 計算値

表 6

実施例	ガラス転移 温度(℃)	5%重量減少 温度(℃)	伝導度(S/cm) (30℃/90℃)	MeOH 溶解性 (wt%)
28	不検出	391	0.069 / 0.214	4.8
29	不検出	395	0.013 / 0.106	1.2
30	不検出	393	0.072 / 0.220	4.2
31	不検出	390	0.070 / 0.235	4.1
比較例 2	204	412	0.070 / 0.247	100
比較例3	200	410	0.013 / 0.146	49
比較例 4	198	407	0.003 / 0.019	0.7
比較例1	130	未測定	0.020 / 0.131	未測定

表 6 より、実施例 2 8~3 1 は比較例 2 、3 の架橋がないポリエーテルに比べ、耐メタノール性が向上していることは明らかである。また、比較例 1 のナフィオン膜に比べてイオン伝導度は同等以上であり、T g はナフィオン膜の 1 30 \mathbb{C} よりも十分に高く、耐熱性が大きく向上していることが分かる。

(実施例32)

5

窒素導入管、温度計及び撹拌装置を備えた 200mlの5つ口反応器に、dMe-BDSA9.99g(24.0mmol)およびDABP3.40g(16.0mmol)とDMAc36.3gを仕込み室温で攪拌し溶解させた。
引き続きNTDA10.73g(40mmol)をDMAc20.1gとともに仕込み、室温で24時間攪拌した。得られたポリアミド酸ワニスの還元粘度は 0.81dl/gであった(DMAc)。

得られた 30.0 w t %ポリアミド酸溶液をガラス板上に塗布し、イナートオープンにて窒素雰囲気下常圧で280℃まで4時間で昇温し280℃で4 15 時間保持することによりDMAcの除去およびイミド化を行った。前記(v-2)記載の方法にて光架橋させた後、ガラス板を水に浸して膜を剥離し、前記 WO 03/033566 PCT/JP02/10536

88

(iv) 記載の方法でスルホン酸をナトリウム塩型よりフリーのプロトン酸型に戻した。得られた膜は可撓性に富み、強靭であった。この膜について、前記(vii) に記載の方法でイオン伝導度を測定した結果、前記(vii) の方法でメタノール溶解性を測定した結果、前記(ix) の方法でメタノール透過性を測定した結果 および前記(x) の方法でイオン交換基当量を測定した結果を表7に示す。

(実施例33)

芳香族ジアミンとして3,5-ジアミノ-2,4,6-トリメチルベンゼンスルホン酸ナトリウム塩5.96g(24.0mmol)およびDABP3.40g(16.0mmol)、芳香族ジアミン仕込み用DMAcとして26.

10 9gを、NTDA仕込み用のDMAcとして20.0g用い、他は実施例32と同様にして重縮合を行った。還元粘度(DMAc)は0.70dl/gであった。得られた30wt%ポリアミド酸溶液より実施例32と同様にしてキャスト膜を作成し、光架橋、ガラス板からの膜の剥離およびプロトン交換を行った。実施例32と同様に各種物性を測定した結果を表7に示す。

15 (実施例34)

20

200m1反応容器にdMe-BDSA8.33g(20.0mmol)、DABP4.25g(20.0mmol)、ピリジン18.8gおよび溶媒としてDMAc100mlを仕込んだ。無水ベンゼントリメリット酸クロリド8.42g(40.0mmol)をDMAc20mlに溶かして滴下し、室温で24時間攪拌した。得られた反応液をセライト濾過し、濾液を全量が約100mlになるまで濃縮した。実施例32と同様にしてキャスト膜を作成し、光架橋およびプロトン交換を行った。実施例32と同様に各種物性を測定した結果を表7に示す。

(実施例35)

25 200mlの 5つ口反応器に、dMe-BDSA8.33g(20.0mmol)、DMAc 120ml、ピリジン 9.4g、塩化リチウム 3.6g を仕込みジアミンを溶解させた。溶液を-5℃に冷却し、3,3'-ベンゾフ

10

ェノンジカルボン酸クロリド 6.14g (20.0mmo1) をDMA c2 0m1に溶かした溶液を滴下した。滴下後、室温で24時間攪拌した。得られた溶液をDMA c50m1 で希釈し、セライト濾過した。この濾液をトルエン500m1 中に排出し、析出した重合体粉を濾過後、150 で4時間乾燥して重合体粉9.17g (収率70.5%) を得た。得られた重合体の還元粘度は 0.69d1/g (DMA c) であった。

重合体 5.0 gをDMA c 20 m 1 に溶かし、ガラス基板上に塗布した。イナートオーブンにて窒素雰囲気下常圧で200℃まで4時間で昇温し200℃で4時間保持することによりDMA c を除去した。実施例32と同様にして光架橋、膜の剥離およびプロトン交換を行った。この膜について各測定を行った結果を表7に示す。

(実施例36)

芳香族ジアミンとしてdMe-BDSA4.16g(10.0mmol)およびビス(3,5,-ジメチルー4-アミノフェニル)メタン2.54g(10.0mmol)の混合物を用い、他は実施例35と同様にして光架橋性スルホン化ポリアミドの合成を行った。収量は8.10g(収率71.1%)、還元粘度は0.74dl/g(DMAc)であった。実施例35と同様にしてキャスト膜を作成し、光架橋およびプロトン交換後、各測定を行った。結果を表7に示す。

20 (実施例37)

芳香族ジアミンとしてdMe-BDSA4.16g(10.0mmol)およびDABP2.12g(10.0mmol)の混合物を、ジカルボン酸クロリドとしてテレフタル酸クロリド4.06g(20.0mmol)を用い、他は実施例35と同様にして光架橋性スルホン化ポリアミドの合成を行った。収25 量は6.60g(収率74.2%)、還元粘度は0.64dl/g(DMAc)であった。実施例35と同様にしてキャスト膜を作成し、光架橋およびプロトン交換後、各測定を行った。結果を表7に示す。

(実施例38)

室素導入管、温度計、冷却管及び撹拌装置を備えた 200m10 5つ口反応器に3, 3'-ジアミノー4, 4'-ジヒドロキシビフェニル二塩酸塩7. <math>23g(25.0mmo1)、ポリリン酸120gを入れ200で1時間攪拌した。テトラメチルテレフタル酸2.78g(12.5mmo1)、4,4'-ベンゾフェノンジカルボン酸3.38g(12.5mmo1)を加え200で1時間攪拌した。反応溶液をイオン交換水200m1中に排出し、析出した重合体を水およびメタノールで洗浄した。160で4時間乾燥して重合体粉7.83g(収率<math>77.1%)を得た。

2素導入管、冷却管、滴下ロート、温度計及び撹拌装置を備えた 100m lの 5つ口反応器にこの重合体 6.00gを仕込み濃硫酸 40mlに溶かした。クロロスルホン酸 5mlを滴下し、滴下後室温で6時間攪拌した。反応液を400mlのイオン交換水に投入し、析出した重合体をイオン交換水で洗浄液が中性になるまで洗った。イナートオーブンにて窒素雰囲気下100℃で6時間乾燥させてプロトン型スルホン化ポリベンゾオキサゾール 5.75gを得た。得られた重合体の還元粘度は 0.65dl/g(DMAc)であった。

重合体5.0gをDMAc18mlに溶かした溶液をガラス板上に塗布し、イナートオーブンにて窒素雰囲気下常圧で150℃まで4時間で昇温し150℃で4時間保持することによりDMAcを除去した。得られたキャスト膜を実施例32と同様に光架橋させ、膜を剥離した。得られた膜の測定結果を表7に示す。

(合成例4)

20

DFBP8. 73g(40mmol)、ビス(3-メチルー4-ヒドロキシフェニル)メタン 9.13g(40mmol)、および炭酸カリウム 6.9
1g(50mmol)を実施例1と同様にしてDMSO 80mlとトルエン 6
0mlを加えて130℃で4時間加熱撹拌し、150℃でトルエンを留去した後、引き続き、160℃で10時間反応を行い、粘稠な重合体溶液を得た。得

られた溶液にDMSO 200mlを加えて希釈した後、セライト濾過した。 この重合体溶液をメタノール 800mlに排出し、析出した重合体粉を濾過 後、160℃で4時間乾燥して重合体粉13.3g(収率 82%)を得た。 得られたポリエーテルケトン粉の還元粘度は 1.14dl/g(DMSO) であった。

(実施例39)

5

10

15

窒素導入管、滴下ロート、温度計及び撹拌装置を備えた50m1反応容器に合成例4で合成したポリエーテルケトン5.01gおよび濃硫酸20m1を仕込み溶解させた。窒素雰囲気下クロロスルホン酸1.39gを滴下し、滴下後室温で6時間攪拌した。反応液を300m1のイオン交換水に投入し、析出した重合体をイオン交換水で洗浄液が中性になるまで洗った。イナートオーブンにて窒素雰囲気下100℃で6時間乾燥させてプロトン型スルホン化ポリエーテルエーテルケトン5.02gを得た。

得られた粉末ポリマーをDMSOに溶解させガラス基板上にキャストし、150℃で4時間乾燥してスルホン酸基含有ポリエーテルケトン膜を得た。得られた膜は可とう性に富み、強靭であった。得られた膜を、前記(v-2)に記載の方法で架橋し、スルホン酸基含有架橋ポリエーテルケトン膜を得た。得られた膜は可とう性に富み、強靭であった。この膜について、実施例32と同様にして各種物性を測定した結果を表7に示す。

20 また、実施例1の(e)と同様にして、得られたスルホン酸基含有架橋ポリエーテルケトン膜のスルホン酸基脱離による重量減少開始温度を測定したところ235℃であった。

(実施例40)

窒素導入管、温度計及び撹拌装置を備えた100mlの5つ口反応器に合成
 25 例4で合成したポリエーテルケトン4.06gおよびプロパンサルトン2.4
 5g(0.02mol)ニトロベンゼン10mlを仕込んだ。撹拌しながら無水塩化アルミニウム2.9g(0.022mol)を投入した。210℃で8

時間加熱した。次いで、反応物を5mlの濃塩酸を添加した氷水100mlに注ぎ、反応を停止させた。反応溶液を200mlの蒸留水に滴下してポリマーを析出させ、濾過後蒸留水で洗浄した。150Cにて一晩減圧乾燥した。

実施例39と同様にしてキャスト膜を作製し光架橋を行った。実施例32と 同様にして各種物性を測定した結果を表7に示す。

(実施例41)

5

窒素導入管、温度計、還流冷却器、及び撹拌装置を備えた5つロ反応器に、DFBP4.36g(0.02mol)、合成例3で得られた2,2ービス[3,5ービス(スルホメチル)ー4ーヒドロキシフェニル]プロパンナトリウム塩、10 3.46g(0.005mol)、tMe-BisF3.85g(0.015mol)および炭酸カリウム3.46g(0.025mol)を秤取した。これにDMSO50mlとトルエン30mlを加え、130℃で4時間加熱し、生成する水を系外に除去した後、トルエンを留去した。引き続き、160℃で14時間反応を行い、粘稠なポリマー溶液を得た。溶液にDMSO20mlを15加えて希釈した後濾過した。このポリマー溶液をトルエン400mlに排出し、アセトン400ml中で粉砕洗浄した。ポリマー粉を濾過後、160℃で4時間乾燥してアルキルスルホン酸基含有ポリエーテルケトン粉7.17g(収率66%)を得た。得られたポリエーテルケトン粉の還元粘度は0.68dl/g(DMSO)であった。

20 実施例39と同様にしてキャスト膜を作製し光架橋後、(iv)記載の方法で プロトン交換を行った。実施例32と同様にして各種物性を測定した結果を表 7に示す。

(実施例42)

芳香族ジハロゲン化合物としてDFBP4.36g(0.02mol)スル
 25 ホン化ジオールとして2,5ージヒドロキシベンゼンスルホン酸ナトリウム塩
 2.19g(0.01mol)、テトラメチルヒドロキノン1.66g(0.01mol)を用い、他は実施例41と同様にして重合および後処理を行った。

収量は5.79g (収率78%)、還元粘度は0.89dl/g (DMSO)であった。

実施例41と同様にしてキャスト膜を作製し光架橋およびプロトン交換を行った。実施例32と同様にして各種物性を測定した結果を表7に示す。

5 また、実施例1の(e)と同様にして、得られたスルホン酸基含有架橋ポリエーテルケトン膜のスルホン酸基脱離による重量減少開始温度を測定したところ239℃であった。

(比較例5)

芳香族ジアミンとしてBDSA9.32g(24.0mmo1)および4, 4'ージアミノビフェニル2.95g(16.0mmo1)、芳香族ジアミン仕 込み用DMAcとして31.2gおよびNTDA仕込み時のDMAcを20. 0gとし、他は実施例32と同様にして重縮合を行った。ポリアミド酸前駆体 の還元粘度(DMAc)は0.75d1/gであった。得られた30wt%ポ リアミド酸溶液より実施例32と同様にしてスルホン化ポリイミドのキャスト 15 膜を作成し光架橋およびプロトン交換を行った。実施例32と同様に各種物性 を測定した結果を表7に示す。

(比較例6)

芳香族ジアミンとしてBDSA6.89g(20.0mmo1)を用い、他は実施例34と同様にして重縮合を行い、スルホン化ポリアミド粉7.27g(収率67.2%)を得た。得られた重合体の還元粘度は 0.62d1/g(DMAc)であった。

乾燥温度を170℃とし他は実施例35と同様にしてキャスト膜を作成し光架橋およびプロトン交換を行った。実施例32と同様に各種物性を測定した結果を比較例1と併せて表7に示す。

表7

実施例	イオン交換 基当量	膜厚	90℃における イオン伝導度	MeOH 溶解性	MeOH 透過性
	(g·eq ⁻¹)	(μm)	(S·cm ⁻¹)	(wt%)	(µmol·cm ⁻² ·min ⁻¹)
32	450	5 1	0.14	3.1	3. 2
33	760	4 7	0.07	0.7	2.1
34	450	4 4	0.06	4.2	3.8
35	300	5 2	0.08	7.8	6.2
36	550	48	0.06	2. 9	3. 0
37	420	48	0.06	4.0	4 3
38	460	4 6	0.10	5.4	4.2
39	570	5 4	0.19	3.0	4.1
40	710	5 1	0.15	1.0	3.4
41	530	5 5	0.23	1.8	4. 2
42	720	5 2	0.12	2.4	3.3
比較例5	4 3 0	4 9	0.09	23.6	17.1
比較例 6	270	48	溶解のため 測定不能	5 8	溶解のため 測定不能
比較例1	1100	5 0	0.13	0	11.7

実施例32~42は比較例5、6の架橋していない重合体に比べ、メタノール溶解性が小さい、即ち耐メタノール性が大きく向上していることは明らかである。また、比較例1のナフィオン膜に比べてイオン伝導度は同程度のオーダーであるがメタノール透過性は低いことが分かる。

また、実施例 28、30、31、39、41のイオン交換基当量が 400~ 600 g·e q⁻¹ であるスルホン酸基含有ポリエーテル架橋膜と、同程度のイオン交換基当量である実施例 32、34、36、37、38のスルホン酸基含有ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリアミド、ポリアゾール架橋膜を比較す

ると、90℃におけるイオン伝導度はポリエーテル架橋膜の方が高ぐ本発明の 燃料電池用プロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂としてより好ましいことが分か る。

(合成例5)

- 5 窒素導入管、滴下ロート、温度計及び撹拌装置を備えた 500m1反応容器にポリエーテルエーテルケトン (Victrex社製PEEK450P) 5 0gおよび濃硫酸200m1を仕込み溶解させた。窒素雰囲気下クロロスルホン酸70m1を滴下し、滴下後室温で6時間攪拌した。反応液を3000m1のイオン交換水に投入し、析出した重合体をイオン交換水で洗浄液が中性になるまで洗った。イナートオーブンにて窒素雰囲気下100℃で6時間乾燥させてプロトン型スルホン化ポリエーテルエーテルケトン 68.1gを得た。得られたプロトン型スルホン化ポリエーテルエーテルケトンのうち、50gをNaOHで処理しNa塩型スルホン化ポリエーテルエーテルケトンにした。(合成例6)
- 2 室素導入管、温度計及び撹拌装置を備えた 200mlの 5つ口反応器に、BDSA15.53g(40.0mmol)とDMAc46.1gを仕込み攪拌して溶解させた。3,3',4,4'ーテトラカルボン酸ベンゾフェノンニ無水物 12.89g(40.0mmol)およびDMAc 20.3gを仕込み、室温で 24時間攪拌した。得られた 30.0wt%アミド酸ワニスの還 元粘度は 0.72dl/gであった(DMAc)。

(合成例7)

室素導入管、温度計、滴下ロート、還流冷却器及び撹拌装置を備えた 200mlの 5つ口反応器にBDSA7.77g(20.0mmol)、DMAc 70ml、ピリジン 4.7g、塩化リチウム 1.8gを仕込みジアミンを溶解させた。溶液を -5 ℃に冷却し、3,3' - ベンゾフェノンジカルボン酸クロリド 6.14g(20.0mmol)をDMAc 20mlに溶かした溶液を荷下した。滴下後、室温で24時間撹拌した。得られた溶液をDMAc 50

mlで希釈し、セライト濾過した。この濾液をトルエン 500ml中に排出し、析出した重合体粉を濾過後、160で4時間乾燥して重合体粉 8.52 g (収率 71%)を得た。得られた重合体の還元粘度は 0.85dl/g (DMAc)であった。

5 (合成例8)

10

15

20

25

DFBP4. 36g (20mmol)、tMe-BisA5. 69g (20mmol)、および炭酸カリウム 3. 46g (25mmol)を実施例1と同様にしてDMSO 40mlとトルエン 30mlを加え、窒素雰囲気下で 130℃で4時間加熱撹拌し、生成する水を系外に除去した後、150℃でトルエンを留去した。引き続き、160℃で10時間反応を行い、粘稠な重合体溶液を得た。得られた溶液にDMSO 100mlを加えて希釈した後、セライト濾過した。この重合体溶液をメタノール 400mlに排出し、析出した重合体粉を濾過後、160℃で4時間乾燥して重合体粉 7. 77g (収率 84%)を得た。得られたポリエーテルケトン粉の還元粘度は 1.06dl/g (DMSO)であった。

(合成例9)

DCDPS11. 48g (40mmol)、tMe-BisA 11. 38g (40mmol)、および炭酸カリウム6. 92g (50mmol)を秤取し、合成例5と同様にDMAc 80mlとトルエン 60mlを加え130℃で4時間加熱撹拌しトルエンを留去した。引き続き、160℃で 10時間反応を行い、粘稠な重合体溶液を得た。得られた溶液にDMAc 150mlを加えて希釈した後、セライト濾過した。この重合体溶液をメタノール 600mlに排出し、析出した重合体粉を濾過後、160℃で4時間乾燥して重合体粉 16. 34g (収率 82%)を得た。得られたポリエーテルの還元粘度は 0.85dl/g (DMAc)であった。

(合成例10)

ジアミンとして 3, 3', 5, 5' ーテトラメチルー4,4' ービフェニル

ジアミン 9.61g(40mmol)、ジアミンを溶かす溶媒としてDMA c 29.9g、テトラカルボン酸二無水物として3,3',4,"4'ービフェ ニルテトラカルボン酸二無水物 10.81g (40.0mmol)、テトラカ ルボン酸二無水物を洗い込む溶媒としてDMAc 18.2gを用い、その他 の条件は合成例6と同様にして 29.8wt%ポリアミド酸ワニスを調製し た。得られたポリアミド酸の還元粘度は 0.66dl/g(DMAc)であ った。

(合成例11)

5

15

窒素導入管、温度計及び撹拌装置を備えた 200mlの 5つ口反応器に2. 2-ビス[(4-フルオロフェニル)ベンゾオキサゾール-6-イル]ヘキサ 10 フルオロプロパン 11. 48g (20mmol)、テトラメチルハイドロキノ ン 3. 32g (20mmol)、炭酸カリウム 3. 46g (25mmol) を仕込んだ。これにN-メチル-2-ピロリドン(NMP) 40mlとトルエ ン 30mlを加え、窒素雰囲気下で 130℃で 4時間加熱撹拌し、生成す る水を系外に除去した後、150℃に昇温してトルエンを留去した。引き続き、 180℃で20時間反応を行い、粘稠な重合体溶液を得た。得られた溶液にN MP 100mlを加えて希釈した後、セライト濾過した。この重合体溶液を メタノール 400m1に排出し、析出した重合体粉を濾過後、160℃で 4 時間乾燥して重合体粉 7.84g(収率56%)を得た。得られたポリベン 20 ゾオキサゾール粉の還元粘度は 0.59dl/g (NMP) であった。

(合成例12)

窒素導入管、温度計、還流冷却器、及び撹拌装置を備えた 500mlの5 つ口反応器に、DFBP 17. 46g (80mmol)、BisA 18. 2 6g (80mmol)、および炭酸カリウム 13.84g (100mol) 仕 込んだ。これにDMSO160mlとトルエン 120mlを加え、窒素雰囲 気下で 130℃で4時間加熱撹拌し、生成する水を系外に除去した後、15 0℃でトルエンを留去した。引き続き、160℃で10時間反応を行い、粘稠

な重合体溶液を得た。得られた溶液にDMSO 200mlを加えて希釈した後、セライト濾過した。この重合体溶液をメタノール 1000mlに排出し、析出した重合体粉を濾過後、160 \mathbb{C} で4時間乾燥して重合体粉 28.2g (収率 87%)を得た。得られたポリエーテルケトン粉の還元粘度は 0.9 6dl/g (DMSO) であった。

(合成例13)

5

10

室素導入管、温度計及び撹拌装置を備えた 200mlの 5つ口反応器に、3,3'ージアミノジフェニルスルホン 7.05g(40.0mmol)とDMAc 30.4gに仕込み攪拌して溶解させた。3,3',4,4'ーテトラカルボン酸ベンゾフェノン二無水物 12.89g(40.0mmol)およびDMAc 16.2gを仕込み、室温で 24時間攪拌した。得られた 30.0wt%アミド酸ワニスの還元粘度は 0.71dl/gであった(DMAc)。

(合成例14)

2 室素導入管、温度計、滴下ロート、還流冷却器及び撹拌装置を備えた 200mlの5つ口反応器に、3,3'ージアミノジフェニルスルホン 4.97g(20.0mmol)、DMAc70ml、ピリジン 4.7g、塩化リチウム 1.8gを仕込みジアミンを溶解させた。溶液を -5℃に冷却し、3,3'ーベンゾフェノンジカルボン酸クロリド 6.14g(20.0mmol)をDMAc20mlに溶かした溶液を滴下した。滴下後、室温で24時間攪拌した。得られた溶液をDMAc50mlで希釈し、セライト濾過した。この濾液をメタノール 500ml中に排出し、析出した重合体粉を濾過後、160℃で4時間乾燥して重合体粉 7.14g(収率74%)を得た。得られた重合体の還元粘度は 0.72dl/g(DMAc)であった。

25 (実施例43)

窒素導入管、温度計、還流冷却器、及び撹拌装置を備えた 200mlの5つ口反応器に、DFBP-2S8. 45g(20mmol)、tMe-Bis

10

A 5. 69g (20mmol)、および炭酸カリウム 3. 46g (25mmol) 仕込んだ。これにDMSO 40mlとトルエン 30mlを加え、窒素雰囲気下で 130℃で4時間加熱撹拌し、生成する水を系外に除去した後、150℃でトルエンを留去した。引き続き、160℃で10時間反応を行い、

粘稠な重合体溶液を得た。得られた溶液にDMSO 100m1を加えて希釈した後、セライト濾過した。この重合体溶液をトルエン 400m1に排出し、析出した重合体をアセトンで洗浄した。得られた重合体粉を160で4時間乾燥して重合体粉 10.53g (収率79%)を得た。得られたスルホン化ポリエーテルケトン粉の還元粘度は 0.78d1/g (DMSO、35°C)であった。

実施例 41 と同様にして、得られたポリマー粉末よりキャスト膜を作製し光架橋およびプロトン交換を行った。この光架橋膜のイオン交換基当量は320 g·e q⁻¹ であった。また、メタノール溶解性を(viii)記載の方法で測定したところ 10.5 w t %であった。

15 (合成例15)

窒素導入管、温度計、還流冷却器、及び撹拌装置を備えた 300mlの 5 つ口反応器に、tMe-BisA 5.69g (20mmol)、および炭酸カリウム3.46g (25mmol) 秤取した。これにDMAc 20mlとトルエン 30mlを加え、窒素雰囲気下130℃で4時間加熱撹拌し、生成す 3水を系外に除去した後、トルエンを留去した。引き続き、SDCDPS9.82g (20mmol)、およびDMAc20mlを加え、165℃で20時間反応を行い、粘稠な重合体溶液を得た。得られた溶液にDMAc40mlを加えて希釈した後、セライト濾過した。この重合体溶液をトルエン400mlに排出し、析出した重合体をトルエンで洗浄した。得られた重合体粉末を 160℃で4時間乾燥して重合体粉 10.96g (収率78%)を得た。得られたポリエーテルの還元粘度は 0.62dl/g (DMAc)であった。 (合成例16)

WO 03/033566 PCT/JP02/10536

100

ジアミンとして dMe-BDSA 19.30g (40 mmo 1)、ジアミンを溶かすための溶媒としてDMAc 50.00g、テトラカルボン酸二無水物としてNTDA10.73g (40.0 mmo 1)、テトラカルボン酸二無水物を洗い込む溶媒としてDMAc 20.07gを用い、その他の条件は合成例13と同様にして 30.0wt%ポリアミド酸ワニスを調製した。得られたポリアミド酸の還元粘度は0.74d1/g (DMAc)であった。(合成例17)

窒素導入管、温度計、還流冷却器、及び撹拌装置を備えた1000mlの5つ口反応器に、ポリ(2,6ージメチルー1,4ーフェニレンオキシド)12gをクロロホルム200gに溶かし、室温で攪拌しながら10wt%クロロスルホン酸クロロホルム溶液500gを滴下した。沈殿物を濾別し、ジクロロメタンで洗浄した。イナートオーブンにて窒素雰囲気下100℃で6時間乾燥させてプロトン型スルホン化ポリフェニレンオキシド15.11gを得た。得られたプロトン型スルホン化ポリフェニレンオキシドをNaOHで処理しNa型スルホン化ポリフェニレンオキシドにした。

(合成例18)

5

10

15

窒素導入管、温度計及び撹拌装置を備えた 200mlの 5つ口反応器に3,3'ージアミノー4,4'ージヒドロキシビフェニル二塩酸塩7.23g、ポリリン酸120gを入れ200℃で1時間攪拌した。2,5ージメチルテレフ20 タル酸4.15gを加え200℃で1時間攪拌した。反応溶液をイオン交換水2000ml中に排出し、析出した重合体を水およびメタノールで洗浄した。160℃で4時間乾燥して重合体粉6.21g(収率79%)を得た。窒素導入管、滴下ロート、温度計及び撹拌装置を備えた100mlの5つ口反応器にこの重合体6.00gを仕込み濃硫酸40mlに溶かした。クロロスルホン酸5mlを滴下し、滴下後室温で6時間攪拌した。反応液を400mlのイオン交換水に投入し、析出した重合体をイオン交換水で洗浄液が中性になるまで洗った。イナートオーブンにて窒素雰囲気下100℃で6時間乾燥させてプ

ロトン型スルホン化ポリベンゾオキサゾール 6.44g を得た。得られた重合体の還元粘度は 0.91dl/g (DMAc) であった。

(実施例44)

合成例5で合成したNa型スルホン化ポリエーテルエーテルケトン 4.8 6g、合成例8で合成したポリエーテルケトン4.62gをDMSO20mlに溶かした。この混合溶液をガラス基板上に塗布し、イナートオーブンにて窒素雰囲気下常圧で200℃まで4時間で昇温し200℃で4時間保持することによりDMSOを除去した。(v-2)に記載の方法にて光架橋させた後、ガラス板を水に浸して膜を剥離し、(iv)に記載の方法でスルホン酸をナトリウム塩型よりフリーのプロトン酸型に戻した。得られた膜は可とう性に富み、強靭であった。この膜について、前記(vii)に記載の方法でイオン伝導度を測定した結果、および(viii)の方法でメタノール溶解性を測定した結果、前記(ix)の方法でメタノール透過性を測定した結果および前記(x)の方法でイオン交換基当量を測定した結果を表8に示す。

15 (実施例45)

Na型スルホン化ポリエーテルエーテルケトンを 3.40g、ポリエーテルケトンを 6.01gとし、それ以外は実施例44と同様にして光架橋膜を作成した。測定結果を表8に示す。

(実施例46)

20 ポリエーテルケトンの代わりに合成例8で合成したポリエーテル4.98g を用い、それ以外は実施例44と同様にして光架橋膜を作成した。測定結果を表8に示す。

(実施例47)

合成例6で合成したスルホン化ポリアミド酸の 30%DMA c溶液 18. 25 95gおよび合成例10で合成したポリアミド酸の 29.8%DMA c溶液 13.70gを混合した。この混合溶液をガラス基板上に塗布し、イナートオ ーブンにて窒素雰囲気下常圧で 300℃まで 4時間で昇温し 300℃で 4 時間保持することによりDMAc除去および熱イミド化を行った。実施例44 と同様に光架橋、プロトン交換を行い得られた光架橋膜の測定を行った。結果 を表8に示す。

(実施例48)

5 合成例 7 で合成したスルホン酸ナトリウム塩型のポリアミド 6.00g、および合成例 10 で合成した 29.8 w t %ポリアミド酸ワニス 17.13g および DMA c 15 m l を混合溶解した。この混合溶液をガラス基板上にキャストし、イナートオーブンにて窒素雰囲気常圧で 300℃まで 4 時間で昇温し300℃で 4 時間保持することにより DMA c を除去した。実施例 44と同様10 に光架橋、プロトン交換および測定を行った。結果を表8に示す。

(実施例49)

合成例5で合成したNa型スルホン化ポリエーテルエーテルケトン4.86 gおよび合成例11で合成したポリベンゾオキサゾール7.00gをNMP2 5mlに溶かした。この混合溶液をガラス基板上に塗布し、イナートオーブン にて窒素雰囲気常圧で220℃まで4時間で昇温し220℃で4時間保持する ことによりNMPを除去した。実施例44と同様に光架橋、プロトン交換およ び測定を行った。結果を表8に示す。

(実施例50)

15

合成例12で合成したポリエーテルケトン 4.06gおよび実施例43で20 合成したNa塩型スルホン化ポリエーテルケトン6.67gをDMSO 25mlに溶かした。この混合溶液をガラス基板上に塗布し、イナートオーブンにて窒素雰囲気下常圧で200℃まで4時間で昇温し200℃で4時間保持することによりDMSOを除去した。(v-2)記載の方法にて光架橋させた後、ガラス板を水に浸して膜を剥離し、(iv)記載の方法でプロトン交換した。得られた膜は可とう性に富み、強靭であった。この膜について、前記(vii)、(viii)、(x)記載の方法で物性を測定した結果を表8に示す。

(実施例51)

ポリエーテルケトンを 4.88g、Na塩型スルホン化ポリエーテルケトンを <math>5.33gとし、それ以外は実施例 50と同様にして光架橋膜を作成した。測定結果を表8に示す。

(実施例52)

5 Na塩型スルホン化ポリエーテルケトンの代わりに合成例15で合成したNa塩型スルホン化ポリエーテル7.03gを用い、それ以外は実施例50と同様にして光架橋膜を作成した。測定結果を表8に示す。

(実施例53)

合成例13で合成したポリアミド酸の30.0%DMAc溶液19.00 10 gおよび合成例16で合成したスルホン化ポリアミド酸の30.0%DMA c溶液22.90gを混合した。この混合溶液をガラス基板上に塗布し、イナートオーブンにて窒素雰囲気下常圧で、300℃まで4時間で昇温し300℃で4時間保持することによりDMAc除去および熱イミド化を行った。実施例50と同様に光架橋、プロトン交換を行い得られた光架橋膜の各種測定を 15 行った。結果を表8に示す。

(実施例54)

合成例14で合成したポリアミド 4.83g、および合成例16で合成した30.0wt%スルホン化ポリアミド酸ワニス22.91gおよびDMAc15mlを混合溶解した。この混合溶液をガラス基板上にキャストし、イナートオーブンにて窒素雰囲気常圧で300℃まで4時間で昇温し300℃で4時間保持することによりDMAcを除去した。実施例50と同様に光架橋、プロトン交換および各種測定を行った。結果を表8に示す。

(実施例55)

合成例12で合成したポリエーテルケトン4.06gおよび合成例17で合 25 成したNa塩型スルホン化ポリフェニレンオキシド3.87gをDMSO2 5mlに溶かした。この混合溶液をガラス基板上に塗布し、イナートオーブン にて窒素雰囲気常圧で200℃まで4時間で昇温し200℃で4時間保持する

WO 03/033566 PCT/JP02/10536

104

ことによりDMSOを除去した。実施例50と同様に光架橋、プロトン交換および測定を行った。結果を表8に示す。

(実施例56)

合成例12で合成したポリエーテルケトン4.06gおよび合成例18で合成したスルホン化ポリベンブオキサゾール4.11gをDMSO25mlに溶かした。この混合溶液をガラス基板上に塗布し、イナートオーブンにて窒素雰囲気常圧で140℃まで4時間で昇温し140℃で4時間保持することによりDMSOを除去した。実施例50と同様に光架橋および各種測定を行った。結果を表8に示す。

10 (比較例7)

15

20

(比較例8)

tMe-BisAの代わりにBisA 4.57g(20mmol)を用い、その他は合成例8と同様にしてポリエーテルケトンを合成し、重合体粉 6.98g(収率 86%)を得た。還元粘度は 1.16dl/g(DMAc)であった。得られたポリエーテルケトン 4.06gおよび合成例5のプロトン型スルホン化ポリエーテルエーテルケトン4.43gをDMAc 20mlに溶解させ、比較例7と同様にしてキャスト膜を作成した。測定結果を表8に示す。

(比較例9)

25 前記合成例 5 のプロトン型スルホン化ポリエーテルエーテルケトン 3. 5 0 g および合成例 1 2 のポリエーテルケトン 5. 0 0 g を DM S O 2 0 m l に 溶解させ、比較例 7 と同様にしてキャスト膜を作成した。測定結果を表 8 に示

す。

なお、比較を容易にするために、前記比較例1でナフィオン膜を用いて測定 した結果を表8にも示した。

表8

表8							
実施例	イオン交換 基当量 (g·eq ⁻¹)	90℃における イオン伝導度 (S·cm ⁻¹)	MeOH 溶解性 (wt%)	MeOH 透過性 (μmol·cm ⁻¹ ·min ⁻¹)			
44	470	0.28	5. 7	3. 6			
45	630	0.16	2. 5	2. 2			
46	490	0.25	6. 2	4. 2			
47	560	0.09	1.5	2.8			
48	5 4 0	0.08	1. 7	2.4			
49	600	0.11	2. 4	1. 7			
50	5 2 0	0.21	4.4	3. 2			
51	620	0.15	2. 7	2. 7			
52	5 3 0	0.19	5. 0	4. 0			
53	590	0.11	1.9	2. 1			
54	5 5 0	0.07	1. 4	3. 1			
55	530	0.17	3. 2	7. 5			
56	680	0.10	2. 4	4. 1			
比較例7	230	溶解のため 測定不能	100	溶解のため 測定不能			
比較例8	440	溶解のため 測定不能	68	溶解のため 測定不能			
比較例 9	560	溶解のため 測定不能	48.2	溶解のため 測定不能			
比較例1	1100	0.13	0	11.7			

WO 03/033566 PCT/JP02/10536

106

実施例44~56は比較例7、8および9の架橋がない重合体に比べ、メタノール溶解性が小さい、即ち耐メタノール性が大きく向上していることは明らかである。また、比較例1のナフィオン膜に比べてイオン伝導度は同程度のオーダーであるがメタノール透過性は低いことが分かる。

5 (実施例57)

10

実施例 4 4 と同様に、合成例 5 で合成した N a 型スルホン化ポリエーテルエーテルケトン 4.8 6 g、合成例 8 で合成したポリエーテルケトン 4.6 2 gをDMS O 2 0 m 1 に溶かした。この混合溶液より架橋方法を(viii)記載の熱架橋とした他は実施例 4 4 と同様にしてキャスト、プロトン交換を行い、イオン伝導性高分子膜を作製した。この膜について実施例 4 4 と同様に各種物性を測定したところ、イオン交換基当量 4 5 0 g・e q^{-1} 、90 Cのイオン伝導度 0.26 S·cm $^{-1}$ 、メタノール溶解性 6.0 w t %、メタノール透過性 3.1 μ mol·cm $^{-2}$ ·min $^{-1}$ であった。

(実施例58)

窒素導入管、温度計、還流冷却器、及び撹拌装置を備えた200mlの5つ 15 口反応器に、BisA 4. 34g (19mmol)、3EPO. 24g (2m mol) および炭酸カリウム3.46g(25mmol) 秤取した。これにD MAc20mlとトルエン30mlを加え、窒素雰囲気下130℃で4時間加 熱撹拌し、生成する水を系外に除去した後、トルエンを留去した。引き続き、 合成例2で得たSDCDPS4. 91g (10mmol)、DCDPS2. 8 20 7g (10mmol) およびDMAc20mlを加え、165℃で20時間反 応を行い、粘稠なポリマー溶液を得た。得られた溶液にDMAc60mlを加 えて希釈した後セライト濾過した。このポリマー溶液をトルエン600mlに 排出し、析出したポリマー粉を濾過後、160℃で4時間乾燥してポリマー粉 9.69g (収率 89%) を得た。得られたポリエーテル粉の還元粘度は0. 25 82dl/g (DMAc)、ガラス転移温度は205℃、5%重量減少温度は 412°Cであった。

得られた粉末ポリマーをDMA c に溶解させガラス基板上にキャズトし、2 00℃で4時間乾燥してスルホン酸N a 基を含有するポリエーテル膜を得た。 得られた膜を(vi)に記載の方法で架橋し、次に(iv)に記載の方法でプロトン交換を行いスルホン酸基含有架橋ポリエーテル膜を得た。得られた膜は可とう性に富み、強靭であった。この膜について、前記(vii)に記載の方法でイオン伝導度を測定した結果および(vii)の方法でメタノール溶解性を測定した結果を表9に示す。

(実施例59~68)

各種芳香族ジヒドロキシ化合物および、プロトン酸基含有含有芳香族ジハライド化合物と芳香族ジハライド化合物、架橋基を含む化合物の種類および割合をかえて各種ポリエーテル粉末を得た。得られた粉末ポリマーよりキャスト膜を作成し、(vi)に記載の方法で架橋した。更に(iv)に記載の方法でプロトン交換を行い、スルホン酸含有ポリエーテル架橋膜を得た。合成結果を表9に、各種物性の測定結果を表10に併せて示す。

15

10

108

表 9

⇔ +5-750	スルホン化シ、ハラ	ジハライド化	シ゛とト゛ロキシ	架橋基含有	イオン交換	収率	還元
実施例	イド化合物 g(mmol)	合物 g(mmol)	化合物 g(mmol)	化合物 g(mmol)	基当量 a g/eq	%	粘度 dl/g
58	SDCDPS	DCDPS	BisA	3EP	· ·		
36	4.91(10)	2.87(10)	4.34(19)	0.24(2)	520	89	0.82
59	SDCDPS 2.95(6)	DCDPS 4.02(14)	BisA 4.34(19)	3EP 0.24(2)	820	88	0.92
	SDCDPS	DCDPS	BisA	3EP			
60	6.88(14)	1.72(6)	4.34(19)	0.24(2)	400	88	0.73
61	SDCDPS	DCDPS	DHDPS	3EP	540	90	0.91
	4.91(10)	2.87(10)	4.76(19)	0.24(2)	340	30	0.31
62	SDCDPS 4.91(10)	DCDPS 2.87(10)	HQ 2.09(19)	3EP 0.24(2)	400	87	0.68
	SDCDPS	DCDPS	DHBP	3EP			
63	4.91(10)	2.87(10)	3.54(19)	0.24(2)	480	92	0.92
64	SDCDPS	DCDPS	BisF	3EP	500	90	0.84
04	4.91(10)	2.87(10)	4.53(19)	0.24(2)	300	30	0.64
65	SDFDPS	DCDPS	BisA	3EP	520	89	0.85
	4.58(10)	2.87(10)	4.34(19)	0.24(2)			
66	SDCDPS 4.91(10)	DFDPS 2.54(10)	BisA 4.34(19)	3EP 0.24(2)	520	84	0.88
	SFCDPS	DFDPS	BisA	3EP			
67	4.58(10)	2.54(10)	4.34(19)	0.24(2)	520	89	0.88
68	SDCDPS	DCDPS	BisA	4EFB	520	91	0.96
L	4.91(10)	2.58(9)	4.57(20)	0.34(2)			
比較例 2	SDCDPS 4.91(10)	DCDPS 2.87(10)	BisA 4.57(20)	無し	550	93	1.02
比較例	SDCDPS	DCDPS	BisA				
3	2.95(6)	4.02(14)	4.57(20)	無し	840	92	1.11
比較例	SDCDPS	DCDPS	BisA	無し	1210	92	1.14
4	2.95(2)	4.02(18)	4.57(20)				

a:計算値

表10

実施例	ガラス転移 温度 (℃)	5%重量減少 温度 (℃)	伝導度(S/cm) (30℃/90℃)	MeOH 溶解性 (wt%)
58	205	412	0.073 / 0.232	2.2
59	201	406	0.010 / 0.139	0.4
60	不検出	415	0.102 / 0.325	10.2
61	208	416	0.084 / 0.227	2.6
62	不検出	401	0.098 / 0.264	8.0
63	不検出	413	0.091 / 0.232	2.0
64	202	410	0.089 / 0.240	2.8
65	204	410	0.078 / 0.233	2.1
66	205	414	0.075 / 0.235	2.1
67	205	412	0.083 / 0.244	1.8
68	206	412	0.081 / 0.230	2.0
比較例 2	204	412	0.070 / 0.247	100
比較例3	200	410	0.013 / 0.146	49
比較例 4	198	407	0.003 / 0.019	0.7
比較例1	130	未測定	0.020 / 0.131	未測定

表10より、実施例 $58\sim68$ は比較例2、3の架橋がないポリエーテルに比べ、耐メタノール性が向上していることは明らかである。また、比較例<math>1のナフィオン膜に比べてイオン伝導度は同等以上であり、Tgはナフィオン膜の130℃よりも十分に高く、耐熱性が大きく向上していることが分かる。

(実施例69)

窒素導入管、温度計、還流冷却器、及び撹拌装置を備えた200mlの5つ口反応器に、DFBP-2S4.22g(10mmol)、DFBP2.18g(10mmol)、BisA4.34g(19mmol)、3EP0.24g
 (2mmol)および炭酸カリウム3.46g(25mmol)秤取した。これにDMSO40mlとトルエン30mlを加え、窒素雰囲気下130℃で4

10

時間加熱撹拌し、生成する水を系外に除去した後、トルエンを留去した。引き続き、160℃で20時間反応を行い、粘稠なポリマー溶液を得た。得られた溶液にDMSO60mlを加えて希釈した後セライト濾過した。このポリマー溶液をトルエン600mlに排出し、析出したポリマー粉を濾過後、160℃で4時間乾燥してポリマー粉8.65g(収率 85%)を得た。得られたポリエーテル粉の還元粘度は0.76dl/g(DMSO)であった。

得られた粉末ポリマーをDMSOに溶解させガラス基板上にキャストし、2 00℃で4時間乾燥してスルホン酸Naを含有するポリエーテルケトン膜を得 た。得られた膜を、(vi)に記載の方法で熱架橋し、次に(iv)に記載の方法 でプロトン交換を行い、スルホン酸含有ポリエーテルケトン架橋膜を得た。得 られた膜は可とう性に富み、強靭であった。この膜について、前記(vii)、(viii)、 (ix)の方法で各種物性を測定した結果を表11に示す。

(実施例70)

DFBP-2Sを5.07g(12mmo1)、DFBPを1.75g(8 mmo1)とし、他の条件は実施例69と同様にして重合および後処理を行った。ポリマー粉 8.68g(収率 82%)を得た。得られたポリエーテルケトン粉の還元粘度は0.72d1/g(DMSO)であった。実施例69と同様にキャスト膜を作成し熱架橋後、プロトン交換を行った。実施例69と同様にして各種物性を測定した結果を表11に記す。

20 (実施例71)

25

BisAを4.57g(20mmol)、DFBPを1.96g(9mmol)、3EPの代わりに4EFB0.24g(2mmol)を用い、他は実施例69と同じ条件で重合および後処理を行った。ポリマー粉8.36g(収率82%)を得た。得られたポリエーテルケトン粉の還元粘度は0.74dl/g(DMSO)であった。実施例69と同様にキャスト膜を作成し熱架橋後、プロトン交換を行った。実施例69と同様にして各種物性を測定した結果を表11に記す。

(実施例72)

BisAを3.42g(15mmol)、3EPの代わりに2;2ービス(4ーヒドロキシー3ーアリルフェニル)プロパン1.54g(5mmol)を用い、他は実施例69と同じ条件にして重合および後処理を行った。ポリマー粉8.66g(収率82%)を得た。得られたポリエーテルケトン粉の還元粘度は0.94dl/g(DMSO)であった。実施例69と同様にキャスト膜を作成し熱架橋後、プロトン交換を行った。実施例69と同様にして各種物性を測定した結果を表11に記す。

(実施例73)

10 室素導入管、温度計及び撹拌装置を備えた 200mlの 5つ口反応器に、BDSA9. 32g(24.0mmol)および4, 4'ージアミノジフェニルスルホン3.97g(16.0mmol)とDMAc35.7gを仕込み室温で攪拌し溶解させた。引き続きNTDA10.19g(38mmol)および無水マレイン酸0.39g(4mmol)をDMAc20.0gとともに仕込み、室温で24時間攪拌した。得られたポリアミド酸ワニスの還元粘度は0.96であった(DMAc)。

得られた 30.0重量%ポリアミド酸溶液をカラス板上に塗布し、イナートオーブンにて常圧の窒素雰囲気下で室温より280℃まで4時間で昇温後280℃で4時間保持することによりDMAcの除去、イミド化および熱架橋を行った。ガラス板を水に浸して膜を剥離し、(iv)記載の方法でプロトン交換した。得られた膜は可とう性に富み、強靭であった。この膜について、実施例69と同様にして各種物性を測定した結果を表11に記す。

(実施例74)

無水マレイン酸の代わりに3-エチニルフタル酸無水物0.69g(4mm 25 o1)を用い、NTDAの仕込みに使用するDMAcを20.7gとし、他の条件は実施例73と同様にしてポリアミド酸ワニスを作成した。ポリアミド酸ワニスの還元粘度は 0.93であった (DMAc)。

WO 03/033566 PCT/JP02/10536

112

実施例73と同様に、ポリアミド酸溶液をガラス板上に塗布し、DMAcの除去、イミド化および熱架橋を行った。キャスト膜を剥離後、プロトン交換し、各種物性を測定した。測定結果を表11に記す。

(実施例75)

- 200mlの5つ口反応器に、BDSA 7.77g(20.0mmol)、DMAc 120ml、ピリジン 9.4g、塩化リチウム 3.6gを仕込みジアミンを溶解させた。溶液を -5℃に冷却し、3,3'ーベンゾフェノンジカルボン酸クロリド 5.84g(19.0mmol)および3ーエチニル安息香酸クロリド 0.33g(2mmol)をDMAc 20mlに溶かした 20mlで添釈した。滴下後、室温で24時間攪拌した。得られた溶液をDMAc 50mlで希釈し、セライト濾過した。この濾液をトルエン 500ml中に排出し、析出したポリマー粉を濾過後、150℃で4時間乾燥してポリマー粉8.85g(収率71%)を得た。得られたポリマーの還元粘度は 0.73dl/g(DMAc)であった。
- 15 ポリマー5.0gをDMAc20mlに溶かし、ガラス基板上に塗布した。 イナートオーブンにて窒素雰囲気下常圧で280℃まで4時間で昇温し28 0℃で4時間保持することによりDMAcの除去および熱架橋を行った。実施 例69と同様にして膜の剥離およびプロトン交換を行った。この膜について各 測定を行った結果を表11に示す。

20 (実施例76)

25

200m1反応容器にBDSA7.77g(20.0mmol)、DABP 4.25g(20.0mmol)、ピリジン18.8gおよび溶媒としてDM Ac100m1を仕込んだ。無水ベンゼントリメリット酸モノクロリド8.00g(38.0mmol)および無水マレイン酸0.39g(4mmol)をDMAc20m1に溶かして滴下し、室温で24時間攪拌した。得られた反応液をセライト濾過した。濾液を全量が約100mlになるまで濃縮後、実施例73と同様にしてイミド化および熱架橋させたキャスト膜を作製し、プロトン

交換を行った。イオン伝導、メタール溶解性およびメタノール透過性の測定結果を表 1 1 に示す。

(実施例77)

室素導入管、温度計及び撹拌装置を備えた 200mlの5つ口反応器に3, 3'ージアミノー4, 4'ージヒドロキシビフェニル二塩酸塩7. 23g(25mmol)、ポリリン酸120gを入れ200℃で1時間攪拌した。4, 4'ーベンゾフェノンジカルボン酸6. 49g(24mmol)、4ーアリル安息香酸0.32g(2mmol)を加え200℃で1時間攪拌した。反応溶液をイオン交換水2000ml中に排出し、析出したポリマーを水およびメタノールで洗浄した。160℃で4時間乾燥してポリマー粉7.91g(収率76%)を得た。

窒素導入管、滴下ロート、温度計及び撹拌装置を備えた 100mlの 5つ口反応器に得られたポリマー6.00gを仕込み濃硫酸40mlに溶かした。クロロスルホン酸5mlを滴下し、滴下後室温で6時間攪拌した。反応液を400mlのイオン交換水に投入し、析出したポリマーをイオン交換水で洗浄液が中性になるまで洗った。イナートオーブンにて窒素雰囲気下100℃で6時間乾燥させてプロトン型スルホン化ポリベンゾオキサゾール6.01gを得た。得られたポリマーの還元粘度は 0.68dl/g (DMAc)であった。得られたプロトン型スルホン化ポリベンゾオキサゾールを水酸化ナトリウムで処理しNa塩型スルホン化ポリベンゾオキサゾールにした。

そのポリマー5.0gをDMA c 18ml に溶かした溶液をガラス板上に塗布し、イナートオーブンにて窒素雰囲気下常圧で150 でまで4時間で昇温し150 でで4時間保持することによりDMA c を除去した。さらに(vi)の方法で熱架橋させ、膜を剥離後(iv)の方法でプロトン交換した。得られた膜の測定結果を表11に示す。

(実施例78)

酸素導入管、温度計及び撹拌装置を備えた 300m1の 5つ口反応器に2

15

20

ーアリルフェノール6. 71g(50mmo1)、2,6ージメチルフェノール6.11g(50mmo1)、ニトロベンゼン170m1、ピリジン70m1、CuCl 1g、MgSO45g、を仕込み、30 $^{\circ}$ Cに保ちながら1時間反応させた。クロロホルム100mlを加えてセライト濾過し、濾液を塩酸酸性のメタノール1000ml中に排出した。析出したポリマーを塩酸酸性メタノールで洗浄し、100 $^{\circ}$ で4時間乾燥してポリマー粉11.22g(収率89%)を得た。

窒素導入管、温度計、還流冷却器、及び撹拌装置を備えた 500mlの 5 つ口反応器に、得られたポリマー6gおよびクロロホルム100gを仕込み、

10 室温で攪拌しながら10重量%クロロスルホン酸クロロホルム溶液50gを滴下した。沈殿物を濾別し、ジクロロメタンで洗浄した。イナートオーブンにて窒素雰囲気下100℃で6時間乾燥させてプロトン型スルホン化ポリフェニレンオキシド5.92gを得た。得られたプロトン型スルホン化ポリフェニレンオキシドを水酸化ナトリウムで処理しNa塩型スルホン化ポリフェニレンオキシドにした。

ポリマー5.0gをDMA c 18m1 に溶かした溶液をガラス板上に塗布し、イナートオーブンにて窒素雰囲気下常圧で150 でまで4時間で昇温し150 で4時間保持することにより DMA c を除去した。さらに(vi)の方法で熱架橋させ、膜を剥離後(iv)の方法プロトン交換した。得られた膜の測定結果を表11に示す。

(実施例79)

20

25

DFBP-2S8. 45g (20mmol)、BisA4. 34g (19mmol)、3EPO. 24g (2mmol) および炭酸カリウム3. 46g (25mmol) を用いて、他の条件は実施例69と同様にして重合および後処理を行った。ポリマー粉9. 04g (収率68%)を得た。得られたポリエーテルケトン粉の還元粘度は0. 62dl/g (DMSO)であった。

実施例69と同様にして、得られたポリマー粉末よりキャスト膜を作製し熱

架橋およびプロトン交換を行った。この熱架橋膜のイオン交換基当量は320g・e q^{-1} であった。また、メタノール溶解性を(v 記載の方法で測定したとこ528.5%であった。

(比較例10)

5 BisAの使用量を4.57g(20mmo1)とし、3EPの使用を省略したほかは実施例69と同様にして、重縮合および後処理を行ってポリマー粉8.25g(収率81%)を得た。実施例69と同様にしてキャスト膜を作成し、プロトン交換を行った。イオン伝導、メタノール溶解性およびメタノール透過性の測定結果を比較例5、6、1と併せて表11に示す。

116

表11

実施例	イオン交 換基当量 (g·eq ⁻¹)	膜厚 (μm)	90℃における イオン伝導度 (S·cm ⁻¹)	MeOH 溶解性 (wt%)	MeOH 透過性 (μmol·cm ⁻² ·min ⁻¹)
69	490	5 2	0.20	6. 1	4. 1
70	420	4 8	0.28	11.5	7. 1
71	490	5 1	0.19	7. 2	4.3
72	510	5 1	0.19	3.4	3.8
73	460	4 6	0.08	7. 6	5.3
74	470	4 5	0.09	5.6	4.9
75	290	5 1	0.05	8. 4	7.8
76	330	5 3	0.08	8. 2	7.4
77	470	4 6	0.11	7. 5	6.2
78	410	48	0.10	5. 4	8.5
比較例 10	420	5 1	0.27	38.7	溶解のため 測定不能
比較例 5	4 3 0	4 9	0.09	23.6	17.1
比較例 6	270	48	溶解のため 測定不能	5 8	溶解のため 測定不能
比較例1	1100	5 0	0.13	0	11.7

実施例69~78は比較例10、5、6の非熱架橋型ポリマーに比べ、メタ ノール溶解性が小さい、即ち耐メタノール性が大きく向上していることは明ら かである。また、比較例1のナフィオン膜に比べてイオン伝導度は同程度のオ ーダーであるがメタノール透過性は低いことが分かる。

また、実施例69~72のポリエーテル系樹脂と実施例73~77のスルホン酸基含有光架橋性ポリイミド、ポリアミド、ポリアゾールを比較すると、イオン交換基当量が同程度の場合の光架橋性ポリエーテルの方がイオン伝導度が高く、本発明の燃料電池用プロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂としてより好ましいことが分かる。

מיוכררייוני יוויר טיטטפפפאר ו

10

また、実施例43で作成した光架橋性スルホン化ポリエーテルケトン膜と実施例79で作成した熱架橋性スルホン化ポリエーテルケトン膜を比較すると、 光架橋性スルホン化ポリエーテルケトン膜の方がメタノール溶解性が低く、本 発明の燃料電池用プロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂としてより好ましいこと が分かる。

産業上の利用性

本発明のプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂は、プロトン酸基から誘導されず、かつ脱離成分の生成なしに架橋し得る架橋基を有する、新規なプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂であって、架橋により、優れたイオン伝導性、耐熱性、耐水性、接着性、さらには低メタノール透過性を発現するもので、燃料電池用イオン伝導性高分子膜および結着剤として好適である。

本発明により、イオン伝導性が高く、耐熱性、耐水性、接着性に優れた燃料電池用イオン伝導性高分子膜、結着剤、電極ならびに燃料電池が提供される。

10 本発明の高分子膜は、架橋により燃料への耐性(耐溶解性)が向上し、燃料の透過性が低下する。その結果、該高分子膜を用いた燃料電池は、燃料のクロスオーバー(燃料の負極から正極への透過)が抑制され、発電効率が向上でき、高い信頼性を得ることができる。

15

請求の範囲

- 1. 架橋基を有するプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂であって、架橋基が、 プロトン酸基から誘導されず、かつ脱離成分の生成なしに架橋し得る架橋基で あることを特徴とするプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂。
 - 2. 架橋基がカルボニル基および芳香環に直接結合した炭素原子数1~10 のアルキル基であることを特徴とする請求の範囲第1項に記載のプロトン酸基 含有架橋性芳香族樹脂。
- 10 3. カルボニル基と、芳香環に直接結合した炭素原子数1~10のアルキル 基からなる架橋基、およびプロトン酸基を有し、光、熱および/または電子線 により架橋できる請求の範囲第1項または2項に記載のプロトン酸基含有架橋 性芳香族樹脂。
- 4. プロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂が、カルボニル基、芳香環に直接結 15 合した炭素原子数1~10のアルキル基およびプロトン酸基を有する、芳香族 ポリエーテル、芳香族ポリアミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリアミドイミ ド、芳香族ポリアゾールから選ばれる芳香族樹脂であることを特徴とする、請 求の範囲第1~3項のいずれかに記載のプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂。
- 5. プロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂が、プロトン酸基と、直接結合した 20 炭素原子数1~10のアルキル基を有する芳香環を含む光架橋性ポリエーテル ケトンであることを特徴とする請求の範囲第1項または2項に記載のプロトン 酸基含有架橋性芳香族樹脂。
 - 6. プロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂が、全繰り返し構造単位に対し、 下記式(6)で表される繰り返し構造単位 10~100モル%、
- 25 および下記式 (7) で表される繰り返し構造単位 $0 \sim 90$ モル%を含み、 $R^1 \sim R^{10}$ の少なくとも1つが $-C_m H_{2m+1}$ (mは $1 \sim 10$ の整数) であり、 かつ $X^1 \sim X^{10}$ の少なくとも1つがプロトン酸基である芳香族ポリエーテルケ

トンであることを特徴とする、請求の範囲第1~3項のいずれかに記載のプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂。

10

15

20

[式(6)および(7)中、R 1 ~R 1 0はそれぞれ独立して、Hまたは $-C_m$ H $_{2m+1}$ (mは1~10の整数)、X 1 ~X 1 0は、それぞれ独立して、Hまたはプロトン酸基、A 1 ~A 3 は、それぞれ独立して、直接結合、 $-CH_2$ -、-C(CH_3) $_2$ -、-C(CF_3) $_2$ -、-O-、 $-SO_2$ -または-CO-であり、i,j,kおよび $_1$ は、それぞれ独立して、 $_1$ 0または $_1$ 2を示し、式(6)および(7)の芳香環の水素原子は、 $-C_m$ H $_{2m+1}$ (mは $_1$ ~ $_1$ 0の整数)、プロトン酸基、 C_1 、F3たは CF_3 に置換されていても良い。]

- 7. プロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂が、カルボニル基を有するカルボニル基含有樹脂、および芳香環に直接結合した炭素原子数1~10のアルキル基を有するアルキル基含有樹脂からなり、該カルボニル基を有する樹脂および該アルキル基を有する樹脂の少なくとも一方がプロトン酸基を有することを特徴とする請求の範囲第1~3項のいずれかに記載のプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂。
- 25 8. カルボニル基を有する樹脂およびアルキル基を有する樹脂が、それぞれ 独立して、芳香族ポリエーテル、芳香族ポリアミド、芳香族ポリイミド、芳香 族ポリアミドイミド、芳香族ポリアゾールから選ばれる芳香族樹脂であること

を特徴とする、請求の範囲第7項に記載のプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂。 9. プロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂が、全繰り返し構造単位に対し、 下記式(6)に示される繰り返し構造単位10~100モル%を含む樹脂20~80重量%、

5 および、下記式(7)に示される繰り返し構造単位10~100モル%を含む 樹脂20~80重量%を含んでなり、

 $R^6 \sim R^{10}$ の少なくとも1つが $-C_m H_{2m+1}$ (mは1 \sim 10の整数)、かつ、 $X^1 \sim X^{10}$ の少なくとも1つがプロトン酸基

であることを特徴とする、請求の範囲第7項に記載のプロトン酸基含有架橋性 10 芳香族樹脂。

15

20 [式 (6) および (7) 中、R¹~R¹°はそれぞれ独立して、Hまたはー C_m H_{2m+1} (mは1~10の整数)、 X^1 ~ X^1 °は、それぞれ独立して、Hまたはプロトン酸基、 A^1 ~ A^3 は、それぞれ独立して、直接結合、 $-CH_2$ -、-C(CH_3)₂-、-C(CF_3)₂-、-O-、 $-SO_2$ -または-CO-であり、i,j,kおよび1は、それぞれ独立して、0または1を示し、式 (6) および (7) の芳香環の水素原子は、 $-C_m$ H_{2m+1} (mは1~10の整数)、プロトン酸基、C1、Fまたは CF_3 に置換されていても良い。]

10. 架橋基が炭素炭素二重結合または炭素炭素三重結合であることを特徴

とする請求の範囲第1項に記載のプロトン酸基含有芳香族樹脂。

- 11. プロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂が、炭素炭素二重結合または炭素 炭素三重結合を有する、芳香族ポリエーテル、芳香族ポリアミド、芳香族ポリ イミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリアゾールから選ばれる芳香族樹 脂であることを特徴とする、請求の範囲第1項または10項に記載のプロトン 酸基含有架橋性芳香族樹脂。
- 12. プロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂が、全繰り返し構造単位に対し、下記式(34)に示される繰り返し構造単位 $20\sim100$ モル%を含み、 $R^{11}\sim R^{15}$ の少なくとも 1以上が $-C_mH_{2m}-CH=CH-R$
- 10 または $-C_mH_{2m}-C\equiv C-R$ (mは $0\sim 1$ 0の整数、RはHまたはフェニル基)であり、かつ、 $X^{11}\sim X^{15}$ の少なくとも1つがプロトン酸基であることを特徴とする請求の範囲第1項または10項に記載のプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂。

[式中、R¹¹~R塙糠、 それぞれ独立して、H、 $-C_mH_{2m}-CH=CH-R$ または $-C_mH_{2m}-C\equiv C-R$ (mは $0\sim 10$ の整数、RはHまたはフェ 20 ニル基)、VはCH,C-CNまたはNを表し、X¹¹~X¹⁵は、それぞれ独立して、Hまたはプロトン酸基を表し、A⁴およびA⁵は、それぞれ独立して、直接結合、 $-CH_2-$ 、-C(CH_3) $_2-$ 、-C(CF_3) $_2-$ 、-O-、-SO $_2-$ または-CO-を表し、k,1,nは、それぞれ独立して、0または1を示し、式(34)中の芳香環の水素原子は、 $-C_mH_{2m}-CH=CH-R$ 、25 $-C_mH_{2m}-C\equiv C-R$ (mは $0\sim 10$ の整数、RはHまたはフェニル基)、プロトン酸基、C1、Fまたは CF_3 に置換されていてもよい。]

13. プロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂が、全繰り返し構造単位に対し、

下記式 (35) に示される繰り返し構造単位 $20\sim100$ モル%を含み、 $X^{16}\sim X^{20}$ の少なくとも 1 つがプロトン酸基であり、かつその分子末端が $R^a-CH=CH-R^b$ または $-R^a-C\equiv C-R^b$ (R^a はフェニレン基、 R^b は は Hまたはフェニル基を示す)であることを特徴とする請求の範囲第 1 項または 1 0 項に記載のプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂。

$$- O \xrightarrow{\text{II}} \left(A^{6} \xrightarrow{\text{V}} \right) \cap O \xrightarrow{\text{II}} \left(A^{7} \xrightarrow{\text{V}} \right) A^{7} \xrightarrow{\text{II}} \right)$$

$$\times ^{16} \times ^{17} \cap X^{18} \times ^{18} \times ^{20}$$

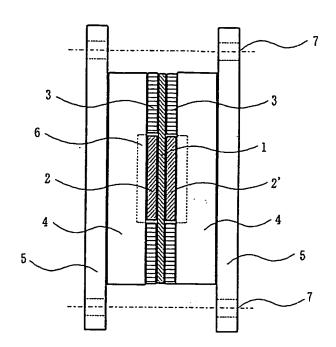
$$\times ^{16} \times ^{18} \times ^{18} \times ^{19} \times ^{19$$

- 【式中、X¹⁶~X²⁰はそれぞれ独立して、Hまたはプロトン酸基、VはCH, C-CNまたはNを表し、A⁶およびA⁷は、それぞれ独立して、直接結合、-CH₂-、-C (CH₃)₂-、-C (CF₃)₂-、-O-、-SO₂-または-CO-を表し、k, 1, nは、それぞれ独立して、0または1を示し、式(35)の芳香環の水素原子は、プロトン酸基、C1、FまたはCF₃に置換されていてもよい。]
 - 14. 前記プロトン酸基が、 $-C_nH_{2n}-SO_3Y$ (nは $0\sim10$ の整数、YはH, N a またはKである)であることを特徴とする請求の範囲第 $1\sim13$ 項に記載のプロトン酸基含有架橋性芳香族樹脂。
- 15. 請求の範囲第1~14項に記載のプロトン酸基含有架橋性樹脂を架橋 20 して得られる架橋物。
 - 16. 請求の範囲第1~14項に記載のプロトン酸基含有架橋性樹脂を用いて得られる高分子膜。
 - 17. 請求の範囲第16項に記載の高分子膜を架橋して得られる燃料電池用イオン伝導性高分子膜。
- 25 18. イオン交換基当量が1000g/mol以下であり、かつメタノール 溶解性が15wt%未満である請求の範囲第17項に記載の燃料電池用イオン 伝導性高分子膜。

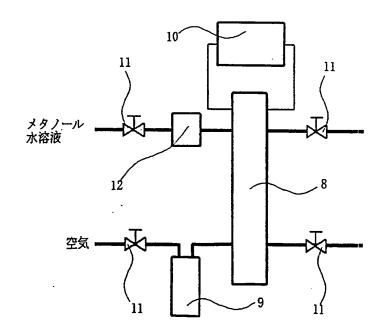
- 19. 請求の範囲第1~14項に記載のプロトン酸基含有架橋性樹脂を含んでなる燃料電池用イオン伝導性結着剤。
- 20. 請求の範囲第19項に記載の結着剤と、電極材料とからなることを特徴とする電極形成用組成物。
- 5 21. 請求の範囲第19項または20項に記載の結着剤および/または電極 形成用組成物を用いて得られる電極。
 - 22. 請求の範囲第16~21項のいずれかに記載の高分子膜、結着剤、電極形成用組成物、電極を用いて得られる燃料電池。

1/2 図面

第1図



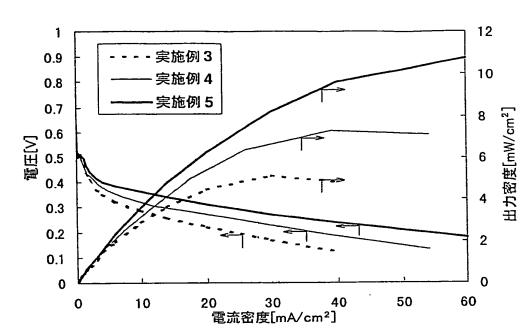
第2図



WO 03/033566

 $^{2}/_{2}$

第3図



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP02/10536

A. CLASS	SIFICATION OF SUBJECT MATTER			
Int	.Cl ⁷ C08G65/40, C08G69/48, C08	BG73/10, C08J5/22, H01M8	3/02	
According	to International Patent Classification (IPC) or to both	national classification and IPC		
	S SEARCHED .			
Minimum o	documentation searched (classification system followers). C1 ⁷ C08G65/40-65/42, C08G69/4 C08J5/22, H01M8/02	d by classification symbols) 18-65/50, C08G73/10-73/1	.6,	
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the	he extent that such documents are included	in the fields seembed	
Koka	i Jitsuyo Shinan Koho 1971-2002	Jitsuyo Shinan Toroku Koho Toroku Jitsuyo Shinan Koho	0 1996-2002 0 1994-2002	
Electronic o	data base consulted during the international search (nat	me of data base and, where practicable, sea	irch terms used)	
		<u>-</u>	,	
C. DOCUM	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where a		Relevant to claim No.	
X	JP 11-502245 A (Hoechst AG. 23 February, 1999 (23.02.99) Claims & WO 96/29359 A),	1-9,14, 16-22	
х	WO 00/15691 A (VICTREX MANU 23 March, 2000 (23.03.00), Claims; page 4, line 2 to pa line 30 to page 6, line 5 & JP 2002-524631 A	ge 5, line 4; page 5,	1-9,14-22	
х	Claims; Par. Nos. [0007], [0 WO 01/25312 A (COMMISSARIAT ATOMIQUE), 12 April, 2001 (12.04.01), Claims & FR 2799198 A		1-4,14, 16-22	
× Further	documents are listed in the continuation of Box C.			
		See patent family annex.		
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search		"X" understand the principle or theory understand the principle or theory under document of particular relevance; the clean considered novel or cannot be considered step when the document is taken alone document of particular relevance; the clean considered to involve an inventive step combined with one or more other such a combination being obvious to a person document member of the same patent far a bate of mailing of the international searce	cular relevance; the claimed invention cannot be alve an inventive step when the document is e or more other such documents, such sobvious to a person skilled in the art of the same patent family international search report	
	anuary, 2003 (10.01.03)	28 January, 2003 (2	8.01.03)	
Japan	ailing address of the ISA/ nese Patent Office	Authorized officer		
Facsimile No		Telephone No.		

3NSDOCID <WO____03033566A1_I_> 0 (second sheet) (July 1998)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP02/10536

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2001-20082 A (COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE), 06 September, 2001 (06.09.01), Claims & JP 2000-510511 A Claims	1-4,14, 16-22
E,X	<pre>JP 2002-358978 A (Sumitomo Electric Industries, Ltd.), 13 December, 2002 (13.12.02), Claims (Family: none)</pre>	1-4,14, 16-22
E,X	JP 2002-367627 A (Sumitomo Electric Industries, Ltd.), 20 December, 2002 (20.12.02), Claims (Family: none)	1-4,14, 16-22
P,X	JP 2002-121281 A (Kaneka Corp.), 23 April, 2002 (23.04.02), Claims (Family: none)	1-4,14, 16-22
P,X	JP 2002-105199 A (Kaneka Corp.), 10 April, 2002 (10.04.02), Claims (Family: none)	1-4,14,

国際調査報告

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' C08G 65/40, C08G 69/48, C08G 73/10, C08J 5/22, H01M 8/02

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl7 C08G 65/40-65/42, C08G 69/48-65/50, C08G 73/10-73/16, C08J 5/22, H01M 8/02

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2002年

日本国実用新案登録公報

1996-2002年

日本国登録実用新案公報

1994-2002年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

関連すると認められる文献 引用文献の 関連する 請求の範囲の番号 カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 11-502245 A (ヘキスト・アクチェンゲゼルシャ 1-9、14、 X フト) 1999.02.23 特許請求の範囲 & WO 96/ 16-22 29359 A WO 00/15691 A (VICTREX MANUFACT 1-9, 14-22 X URING LIMITED) 2000. 03. 23 clai m、第4頁第2行~第5頁第4行、第5頁第30行~第6頁第5行 & JP 2002-524631 A 特許請求の範囲、【0 007], [0011]

× C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による閉示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの

国際調査を完了した日 10.01.03	国際調査報告の発送日 2 8.01.03			
国際調査機関の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員) 4 J 2 9 4 0 藤本 保 印			
日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915				
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3455 			

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)

 C(統き).	関連すると認められる文献	
引用文献の		関連する
<u>カテゴリー*</u> X	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 WO 01/25312 A (COMMISSARIAT A L 'ENERGIE ATOMIQUE) 2001.04.12 特 許請求の範囲 & FR 2799198 A	請求の範囲の番号 1-4、14、 16-22
X	US 2001-20082 A (COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE) 2001. 09. 06 特許請求の範囲 & JP 2000-510511 A 特許 請求の範囲	1-4、14、 16-22
ΕX	JP 2002-358978 A (住友電気工業株式会社) 20 02.12.13 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-4、14、 16-22
ΕX	JP 2002-367627 A (住友電気工業株式会社) 20 02.12.20 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-4、14、 16-22
PΧ	JP 2002-121281 A (鐘淵化学工業株式会社) 20 02.04.23 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-4、14、 16-22
PΧ	JP 2002-105199 A (鐘淵化学工業株式会社) 20 02.04.10 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-4、14、 16-22

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (1998年7月)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| BLACK BORDERS |
| IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| FADED TEXT OR DRAWING |
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| SKEWED/SLANTED IMAGES |
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| GRAY SCALE DOCUMENTS |
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.